

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 2 年 1 0 月 7 日
Date of Application:

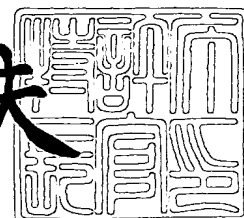
出 願 番 号 特 願 2 0 0 2 - 2 9 3 3 5 0
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 2 - 2 9 3 3 5 0]

出 願 人 アルプス電気株式会社
Applicant(s):

2 0 0 3 年 8 月 1 4 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 3 - 3 0 6 5 8 1 7

【書類名】 特許願

【整理番号】 021197AL

【提出日】 平成14年10月 7日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 43/08
G11B 5/39

【発明の名称】 磁気検出素子及びその製造方法

【請求項の数】 24

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区雪谷大塚町 1 番 7 号 アルプス電気株式会
社内

【氏名】 長谷川 直也

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区雪谷大塚町 1 番 7 号 アルプス電気株式会
社内

【氏名】 梅津 英治

【特許出願人】

【識別番号】 000010098

【氏名又は名称】 アルプス電気株式会社

【代表者】 片岡 政隆

【代理人】

【識別番号】 100085453

【弁理士】

【氏名又は名称】 野▲崎▼ 照夫

【選任した代理人】

【識別番号】 100121049

【弁理士】

【氏名又は名称】 三輪 正義



【手数料の表示】

【予納台帳番号】 041070

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要



【書類名】 明細書

【発明の名称】 磁気検出素子及びその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基板上に少なくとも第 1 の反強磁性層、固定磁性層、非磁性材料層及びフリー磁性層を積層形成した多層膜と、前記フリー磁性層の磁化制御を行うための磁化制御層とを有し、

前記固定磁性層は、トラック幅方向に延び、前記第 1 の反強磁性層に接する側の第 1 の磁性層と、前記第 1 の磁性層と膜厚方向で対向する第 2 の磁性層と、前記第 1 の磁性層と第 2 の磁性層間に介在する非磁性中間層とを有して構成され、前記第 1 の磁性層と第 2 の磁性層は互いに磁化が反平行状態にあり、

前記第 1 の反強磁性層はトラック幅方向に所定間隔の間欠部を介して、前記第 1 の磁性層のトラック幅方向の両側端部に膜厚方向から接して設けられ、

前記間欠部での前記フリー磁性層の磁化の方向と前記第 2 の磁性層内の磁化の方向とで電気抵抗が変化することを特徴とする磁気検出素子。

【請求項 2】 前記多層膜は下から、フリー磁性層、非磁性材料層、固定磁性層及び第 1 の反強磁性層の順に積層され、前記フリー磁性層の下にトラック幅方向に所定の間隔を空け、前記フリー磁性層のトラック幅方向の両側端部下に設けられた前記磁化制御層が第 2 の反強磁性層を有して構成され、前記固定磁性層を構成する第 1 の磁性層の両側端部上に前記第 1 の反強磁性層が設けられる請求項 1 記載の磁気検出素子。

【請求項 3】 前記磁化制御層が永久磁石層で構成され、前記フリー磁性層の両側端部と前記永久磁石層とは直接接触している請求項 2 記載の磁気検出素子。

【請求項 4】 前記第 1 反強磁性層に空けられた前記間隔のトラック幅方向における最小寸法は W_P で、前記磁化制御層に空けられた前記間隔のトラック幅方向における最小寸法は W_f であり、前記 W_f は前記 W_P と同じ寸法かそれよりも小さい請求項 2 又は 3 に記載の磁気検出素子。

【請求項 5】 前記多層膜は下から、フリー磁性層、非磁性材料層、固定磁性層及び第 1 の反強磁性層の順に積層され、少なくとも前記フリー磁性層及び非



磁性材料層のトラック幅方向の両側には前記磁化制御層となる永久磁石層が設けられ、前記非磁性材料層上に設けられる固定磁性層の一部あるいは全部が、前記非磁性材料層上から前記永久磁石層の上側にかけて形成され、前記固定磁性層を構成する第1の磁性層の両側端部上に前記第1の反強磁性層が設けられる請求項1記載の磁気検出素子。

【請求項6】 少なくとも前記フリー磁性層及び非磁性材料層のトラック幅方向の両側には、前記永久磁石層を有する素子両側領域がトラック幅方向に延びて存在し、前記非磁性材料層上に設けられる固定磁性層が、前記非磁性材料層上から前記素子両側領域上にかけて形成される請求項5記載の磁気検出素子。

【請求項7】 少なくとも前記フリー磁性層、非磁性材料層並びに固定磁性層を構成する第2の磁性層及び非磁性中間層のトラック幅方向の両側には、前記永久磁石層を有する素子両側領域がトラック幅方向に延びて存在し、前記非磁性中間層上に設けられる前記固定磁性層を構成する第1の磁性層が、前記非磁性中間層上から前記素子両側領域上にかけて形成される請求項5記載の磁気検出素子。

【請求項8】 前記第1反強磁性層に空けられた前記間隔のトラック幅方向における最小寸法はWPで、前記フリー磁性層のトラック幅方向における最小幅寸法はWf2であり、前記Wf2は前記WPと同じ寸法かそれよりも小さい請求項5ないし7のいずれかに記載の磁気検出素子。

【請求項9】 前記多層膜は下から、第1の反強磁性層、固定磁性層、非磁性材料層及びフリー磁性層の順に積層され、前記第1の反強磁性層はトラック幅方向に所定間隔の間欠部を介して前記第1の磁性層のトラック幅方向の両側端部下に設けられる請求項1記載の磁気検出素子。

【請求項10】 前記第1の反強磁性層の下に設けられた前記基板のトラック幅方向の両側には所定深さの凹み部が設けられ、前記凹み部内に前記第1の反強磁性層が設けられて、前記第1の反強磁性層のトラック幅方向に所定間隔の間欠部が空けられる請求項9記載の磁気検出素子。

【請求項11】 前記フリー磁性層上に、トラック幅方向に所定の間隔を空け、前記フリー磁性層の両側端部上に設けられた前記磁化制御層が第3の反強磁



性層を有して構成される請求項 9 又は 10 に記載の磁気検出素子。

【請求項 12】 前記第 1 反強磁性層に空けられた前記間隔のトラック幅方向における最小寸法は WP で、前記磁化制御層に空けられた前記間隔のトラック幅方向における最小寸法は $Wf3$ であり、前記 $Wf3$ は前記 WP と同じ寸法かそれよりも小さい請求項 11 に記載の磁気検出素子。

【請求項 13】 前記フリー磁性層のトラック幅方向の両側に前記磁化制御層となる永久磁石層が設けられ、前記永久磁石層の下面は少なくとも前記固定磁性層よりも上側に位置する請求項 9 又は 10 に記載の磁気検出素子。

【請求項 14】 前記第 1 反強磁性層に空けられた前記間隔のトラック幅方向における最小寸法は WP で、前記フリー磁性層のトラック幅方向における最小幅寸法は $Wf4$ であり、前記 $Wf4$ は前記 WP と同じ寸法かそれよりも小さい請求項 13 に記載の磁気検出素子。

【請求項 15】 前記 WP は $0.2\ \mu\text{m}$ 以下である請求項 4、8、12 または 14 に記載の磁気検出素子。

【請求項 16】 電極層が磁気検出素子のトラック幅方向における両側端部に設けられ、前記電極層から前記多層膜に向けてセンス電流を流すことによって形成されるセンス電流磁界の向きは、前記固定磁性層を構成する磁性層の単位面積当たりの合成磁気モーメントの方向と一致している請求項 1 ないし 15 のいずれかに記載の磁気検出素子。

【請求項 17】 前記間欠部には、両側の第 1 の反強磁性層と同じ組成の材料層が前記第 1 の磁性層と接して設けられており、前記間欠部での前記材料層は、前記第 1 の反強磁性層よりも薄く形成された不規則結晶構造の層である請求項 1 ないし 16 のいずれかに記載の磁気検出素子。

【請求項 18】 基板上に下から、フリー磁性層、非磁性材料層、固定磁性層及び第 1 の反強磁性層の順に積層された多層膜と、前記フリー磁性層の磁化制御を行うための磁化制御層とを有する磁気検出素子の製造方法において、

(a) 前記固定磁性層をトラック幅方向に延びる第 2 の磁性層と、前記第 2 の磁性層上に非磁性中間層を介して前記第 2 の磁性層と膜厚方向で対向する第 1 の磁性層とで形成し、さらに前記第 1 の磁性層上に前記第 1 の反強磁性層と同じ組成

であり且つ前記第1の反強磁性層よりも膜厚が薄く、不規則結晶構造の層である材料層を形成し、前記材料層の上に非磁性層を形成する工程と、

(b) 前記非磁性層を除去し、前記材料層の両側端部上に前記材料層よりも厚い膜厚の上側反強磁性層を形成し、前記材料層と上側反強磁性層とで前記第1の反強磁性層を構成する工程と、

(c) 磁場中アニールを施して、前記第1の反強磁性層と第1の磁性層の両側端部間に交換結合磁界を生じさせ、前記第1の磁性層と第2の磁性層を反平行状態に磁化固定する工程と、を有することを特徴とする磁気検出素子の製造方法。

【請求項19】 前記(b)工程に代えて以下の工程を有する請求項18記載の磁気検出素子の製造方法。

(d) 前記非磁性層を除去した後、前記第1の反強磁性層と同じ組成の材料層上に前記材料層よりも厚い膜厚の上側反強磁性層を形成し、前記材料層と上側反強磁性層とで前記第1の反強磁性層を構成する工程と、

(e) 前記第1の反強磁性層の上側にトラック幅方向に所定の間隔を空けたマスク層を設け、前記マスク層に覆われていない前記第1の反強磁性層を削ることで、トラック幅方向に所定の間隔を空け、少なくとも前記第1の磁性層の素子両側上に第1の反強磁性層を残す工程。

【請求項20】 前記反強磁性層と同じ組成の材料層を50 Åよりも薄い膜厚で形成する請求項18又は19に記載の磁気検出素子の製造方法。

【請求項21】 基板上に下から、第1の反強磁性層、固定磁性層、非磁性材料層及びフリー磁性層の順に積層された多層膜と、前記フリー磁性層の磁化制御を行うための磁化制御層とを有する磁気検出素子の製造方法において、

(f) 前記基板のトラック幅方向における両側に第1の反強磁性層を設ける工程と、

(g) 前記第1の反強磁性層上から前記第1の反強磁性層間の基板上にかけて、トラック幅方向に延びる第1の磁性層と、前記第1の磁性層上に非磁性中間層を介して前記第1の磁性層に膜厚方向で対向する第2の磁性層とからなる固定磁性層を形成し、前記固定磁性層上に非磁性材料層及びフリー磁性層を形成する工程と、

(h) 磁場中アニールを施して、前記第1の反強磁性層と第1の磁性層の両側端部間に交換結合磁界を生じさせ、前記第1の磁性層と第2の磁性層を反平行状態に磁化固定する工程と、を有することを特徴とする磁気検出素子の製造方法。

【請求項22】 前記(f)及び(g)工程に代えて以下の工程を有する請求項21記載の磁気検出素子の製造方法。

(i) 前記基板のトラック幅方向における両側に所定深さの凹み部を設ける工程と、

(j) 前記凹み部内に前記第1の反強磁性層を形成し、さらに前記第1の反強磁性層上に非磁性層を形成する工程と、

(k) 前記非磁性層を除去した後、前記第1の反強磁性層上から基板上にかけて前記第1の反強磁性層と同じ組成であり且つ前記第1の反強磁性層よりも膜厚が薄く、不規則結晶構造の層である材料層を形成し、前記第1の反強磁性層上に重ねられた材料層を第1の反強磁性層の一部として構成し、さらに前記第1の反強磁性層及び前記材料層上に、トラック幅方向に延びる第1の磁性層と、前記第1の磁性層上に非磁性中間層を介して前記第1の磁性層に膜厚方向で対向する第2の磁性層とからなる固定磁性層を形成し、前記固定磁性層上に非磁性材料層及びフリー磁性層を形成する工程。

【請求項23】 前記(f)及び(g)工程に代えて以下の工程を有する請求項21記載の磁気検出素子の製造方法。

(l) 基板上に第1の磁性層及び非磁性中間層を成膜する工程と、

(m) 前記基板のトラック幅方向における両側に所定深さの凹み部を設ける工程と、

(n) 前記凹み部内に前記第1の反強磁性層を形成し、さらに前記第1の反強磁性層上に第1の磁性層及び非磁性中間層を形成する工程と、

(o) 前記非磁性中間層の上面を一部除去した後、前記非磁性中間層上に第2の磁性層を形成し、第1の磁性層、第2の磁性層及び非磁性中間層で固定磁性層を構成し、前記固定磁性層上に非磁性材料層及びフリー磁性層を形成する工程。

【請求項24】 前記上側反強磁性層を50 Åよりも薄い膜厚で形成する請求項22記載の磁気検出素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】**【0001】****【発明の属する技術分野】**

本発明は、ハードディスク装置などに搭載されるスピバルブ型薄膜素子などの磁気検出素子に係わり、特に固定磁性層と第1の反強磁性層との交換結合膜の構造を適正化することで、前記固定磁性層を適切に磁化固定できると共に、再生出力の向上を図り、さらには狭ギャップ化等に適切に対応することが可能な磁気検出素子及びその製造方法に関する。

【0002】**【従来の技術】**

図50は従来の磁気検出素子（スピバルブ型薄膜素子）を記録媒体との対向面側から見た部分断面図である。

【0003】

符号1はPtMnなどの反強磁性層であり、前記反強磁性層1の上にNiFe合金などで形成された固定磁性層2、Cuなどで形成された非磁性材料層3、およびNiFe合金などで形成されたフリー磁性層4が積層形成されている。

【0004】

図50に示すように前記反強磁性層1からフリー磁性層4までの各層のトラック幅方向（図示X方向）の両側には永久磁石層5が形成され、前記永久磁石層5の上に電極層6が形成されている。

【0005】

図50に示す磁気検出素子では、前記反強磁性層1と固定磁性層2間に交換結合磁界が生じることで前記固定磁性層2の磁化は図示Y方向に固定されている。一方、フリー磁性層4はその両側に設けられた永久磁石層5からの縦バイアス磁界によって図示X方向に向けられている。

【0006】

図50に示す磁気検出素子に対して図示Y方向から外部磁界が侵入すると前記フリー磁性層の磁化が変動し、ハイト方向（図示Y方向）に磁化された固定磁性層2の固定磁化との関係で磁気抵抗効果が発揮され、外部信号が再生される。

【0007】

しかしながら図50に示す磁気検出素子の構造では以下のような問題点があった。

【0008】

すなわち電極層6から流れるセンス電流は前記非磁性材料層3を主に流れ、特に反強磁性層1などに分流しないことが好ましいが、図50に示す構造では前記センス電流は前記固定磁性層2の下全面に形成された反強磁性層1にも分流しやすくなっており、それが電流ロスとなって再生出力が低下するという問題があった。図50に示す磁気検出素子では前記フリー磁性層4の上面のトラック幅方向（図示X方向）における幅寸法でトラック幅Twが決められるが、このトラック幅Twが狭くなるにつれて上記した再生出力の低下は顕著化するため、反強磁性層1へのセンス電流の分流は無視できない問題となっていた。

【0009】

また反強磁性層1はその上に積層される各層の膜厚に比べて非常に厚い膜厚で形成される。その理由の一つには前記固定磁性層2との間で大きな交換結合磁界を生じさせ、前記固定磁性層2の磁化固定を適切化するためであるが、前記反強磁性層1が厚いために上記した電流ロスが大きくなるとともに、前記磁気検出素子の膜厚方向（図示Z方向）の上下に形成されているシールド層7、8の膜厚方向（図示Z方向）への間隔を狭くすることができないため狭ギャップ化に適切に対応可能な磁気検出素子を製造することができなかった。

【0010】

さらに、図50に示すように固定磁性層2の下全面に反強磁性層1が形成されていると静電破壊（ESD）に強い磁気検出素子を製造することができなかった。電極層6からセンス電流が流れると、それによって素子内に熱が発生し、またESDによる過渡電流の影響等を受けて、図示Y方向に固定されるはずの固定磁性層2の磁化が揺らぎやすくなるからである。前記反強磁性層1のブロッキング温度を超えない低い温度での発熱であればさほど大きな問題ではないが、素子自体が非常に小さくなっている今、素子内部でブロッキング温度を超えた熱が生じることで、前記反強磁性層1と固定磁性層2間で生じている交換結合磁界が弱ま

って前記固定磁性層 2 の磁化が揺らぐ s o f t E S D と呼ばれる磁氣的な静電破壊現象が見られるようになっていた。

【0 0 1 1】

【特許文献 1】

特開 2 0 0 0 - 1 6 3 7 1 7 号公報

【特許文献 2】

特開平 8 - 7 3 2 5 号公報

【0 0 1 2】

【発明が解決しようとする課題】

ところで固定磁性層 2 及び反強磁性層 1 とで構成される交換結合膜の構造は、図 5 0 のような単に前記の 2 層を積層しただけの単純なものばかりではなく、前記交換結合膜の構造を改良したものがいくつかの文献に紹介されている。

【0 0 1 3】

例えば図 5 1 に示す磁気検出素子は、特開 2 0 0 0 - 1 6 3 7 1 7 号公報（以下、特許文献 1 という）の図 1 に掲載された図を書き写したものであり、図 5 1 は前記磁気検出素子を記録媒体との対向面側から見た部分断面図である。なお図 5 0 と同じ符号が付けられている層は図 5 0 と同じ層を示している。符号 9、1 0 はギャップ層である。

【0 0 1 4】

図 5 1 に示すように前記反強磁性層 1 のトラック幅方向における中央部には厚さが両側部分と異なる肉薄部 1 1 が設けられている。特許文献 1 によれば、前記肉薄部 1 1 の部分で前記固定磁性層 2 に対する直接的な磁化固定力は弱まるものの、十分な厚さを有する反強磁性層 1 の両側で作用する磁化固定力により、固定磁性層 2 の中央部の磁化固定力も補われ、特性が劣化することは無いと記載されている。

【0 0 1 5】

しかしながら特許文献 1 に記載された磁気検出素子の構造では上記した問題は依然として解決されていない。まず反強磁性層 1 の中央部を肉薄部 1 1 にしても、この肉薄部 1 1 に電極層 6 からセンス電流が分流することでそれが電流ロスと

なるし、また静電破壊も依然として起きやすい。また前記反強磁性層 1 の中央部を肉薄部 1 1 にすれば前記固定磁性層 2 との間で発生する交換結合磁界が低下するから固定磁性層 2 の磁化固定力は、図 5 0 に示す磁気検出素子の固定磁性層 2 の磁化固定力に比べて低下するのは明白である。

【 0 0 1 6 】

また仮に前記反強磁性層 1 の肉薄部 1 1 の膜厚を相当に薄くし、上記した電流ロス等を軽減したとすると、前記肉薄部 1 1 と固定磁性層 2 間で交換結合磁界が全く発生しなくなってしまうため、この公報に記載されているように固定磁性層 2 の両側が反強磁性層 1 との間で強く磁化固定されていたとしても、前記固定磁性層 2 の中央部は、磁性層内部の交換相互作用により媒介されたバイアス磁界のみを頼って磁化制御されるため、強固に前記中央部での磁化を固定できず、前記中央部の磁化は外部磁界によって変動しやすくなり、再生特性の劣化は免れないものと考えられる。

【 0 0 1 7 】

また図 5 2 に示す磁気検出素子は、特開平 8 - 7 3 2 5 号公報（以下、特許文献 2 という）の図 5 の一部を書き写したものであり、前記磁気検出素子を記録媒体との対向面側から見た部分断面図である。なお図 5 0 と同じ符号が付けられている層は図 5 0 と同じ層を示している。

【 0 0 1 8 】

図 5 2 に示す磁気検出素子では前記固定磁性層 2 が 2 層の磁性層 1 2、1 4 とその間に介在する非磁性層 1 3 の 3 層構造からなり、特許文献 2 ではこの固定磁性層 2 を「自動ピン止め層」と呼んでいる。図 5 2 に示すように前記固定磁性層 2 の磁化を固定するための反強磁性層 1 は設けられていない。この特許文献 2 によれば、前記固定磁性層 2 を構成する 2 層の磁性層は互いに反対方向に磁化されて「自動ピン止め」され、外部印加磁界が侵入してきても前記磁性層 1 2、1 4 が回転してしまうことは無いとしている。

【 0 0 1 9 】

しかしながら図 5 2 に示すように反強磁性層 1 などのバイアス手段を設けずに固定磁性層 2 の磁性層 1 2、1 4 間で発生する磁界のみで前記固定磁性層 2 の磁

化固定を行うと外部磁界の大きさや様々な要因によって、前記磁性層の磁化が反平行状態を保ちながら回転しやすく、あるいは前記反平行状態が崩れて、再生特性の劣化を招きやすい。

【0020】

また前記固定磁性層 2 を上記した 3 層構造にするにしても、各磁性層 1 2、1 4 の単位面積当たりの磁気モーメント等をどの程度にすれば、特許文献 2 で言う「自動ピン止め層」として機能させることができるかは明白でない。

【0021】

以上のように従来では、固定磁性層 2 を強固に磁化固定できるとともに、再生出力を向上させることができ、さらには狭ギャップ化、静電破壊に適切に対応することができる交換結合膜の構造は存在しなかった。

【0022】

そこで本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであって、特に固定磁性層と第 1 の反強磁性層との交換結合膜の構造を適正化することで、前記固定磁性層を適切に磁化固定できるとともに、再生出力の向上を図り、さらには狭ギャップ化等に適切に対応することが可能な磁気検出素子及びその製造方法を提供すること目的としている。

【0023】

【課題を解決するための手段】

本発明の磁気検出素子は、基板上に少なくとも第 1 の反強磁性層、固定磁性層、非磁性材料層及びフリー磁性層を積層形成した多層膜と、前記フリー磁性層の磁化制御を行うための磁化制御層とを有し、

前記固定磁性層は、トラック幅方向に延び、前記第 1 の反強磁性層に接する側の第 1 の磁性層と、前記第 1 の磁性層と膜厚方向で対向する第 2 の磁性層と、前記第 1 の磁性層と第 2 の磁性層間に介在する非磁性中間層とを有して構成され、前記第 1 の磁性層と第 2 の磁性層は互いに磁化が反平行状態にあり、

前記第 1 の反強磁性層はトラック幅方向に所定間隔の間欠部を介して、前記第 1 の磁性層のトラック幅方向の両側端部に膜厚方向から接して設けられ、

前記間欠部での前記フリー磁性層の磁化の方向と前記第 2 の磁性層内の磁化の

方向とで電気抵抗が変化することを特徴とするものである。

【0024】

上記した本発明の磁気検出素子の特徴的な部分は、前記固定磁性層が第1の磁性層と第2の磁性層と、両磁性層間に介在する非磁性層とを有して構成されている点と、前記第1の磁性層に膜厚方向から接する第1の反強磁性層には、トラック幅方向の中央に所定間隔の間欠部が空けられている点である。

【0025】

本発明では、前記固定磁性層の両側端部は前記第1の反強磁性層との間で発生する交換結合磁界と、第1の磁性層と第2の磁性層間で発生するRKKY相互作用による反平行結合磁界によって、磁化が固定される。一方、前記固定磁性層の中央部でも上記したRKKY相互作用による反平行結合磁界が発生することで、固定磁性層が単層構造で、しかも中央部での磁化固定を磁性層内部の交換相互作用により媒介されたバイアス磁界に頼っていた図51の磁気検出素子に比べて前記固定磁性層の中央部の磁化をより強固に固定することができるのである。

【0026】

また上記した固定磁性層の中央部での磁化固定の良し悪しは、前記第1の反強磁性層に空けられた間隔のトラック幅方向への幅寸法によって変わるが、後述する実験によれば前記間隔が $0.2\mu\text{m}$ 程度でも十分に前記固定磁性層の中央部での磁化固定を確実なものにできることがわかっており、 $0.1\mu\text{m}$ 以下のトラック幅 T_w を目指す現在にあって、前記間隔を $0.2\mu\text{m}$ 以下で形成することは技術的に難しいことではなく、よって本発明における第1の反強磁性層と固定磁性層との交換結合膜の構造を容易に且つ適切に製造することができる。

【0027】

そして本発明では前記第1の反強磁性層のトラック幅方向における中央部には所定の間隔が空けられ、前記第1の反強磁性層の中央部では前記固定磁性層との間で交換結合磁界が発生しないようになっている。そのため前記間隔内には前記第1の反強磁性層と同じ組成の材料層が全く無いかあっても非常に薄い膜厚である。したがって前記第1の反強磁性層の中央部へのセンス電流の分流ロスが無くなり再生出力の向上を図ることが可能になり、また狭ギャップ化も果たすことが

できる。しかも素子中央にそもそも第1の反強磁性層が全く無いか、あるいは有っても非常に薄い膜厚なので前記固定磁性層の中央部で静電気放電によって固定磁性層と第1の反強磁性層間の交換結合磁界の方向が反転したりする磁氣的破壊の現象は起き難くなり、素子の小型化及び高密度化により厳しい環境下においても、再生特性に優れた磁気検出素子を製造することが可能である。

【0028】

また本発明では、前記多層膜は下から、フリー磁性層、非磁性材料層、固定磁性層及び第1の反強磁性層の順に積層され、前記フリー磁性層の下にトラック幅方向に所定の間隔を空け、前記フリー磁性層のトラック幅方向の両側端部に設けられた前記磁化制御層が第2の反強磁性層を有して構成され、前記固定磁性層を構成する第1の磁性層の両側端部上に前記第1の反強磁性層が設けられる構造を提供することができる。あるいは、前記磁化制御層が永久磁石層で構成され、前記フリー磁性層の両側端部と前記永久磁石層とは直接接触している構造を提供することができる。

【0029】

かかる場合、前記第1反強磁性層に空けられた前記間隔のトラック幅方向における最小寸法はWPで、前記磁化制御層に空けられた前記間隔のトラック幅方向における最小寸法はWf1であり、前記Wf1は前記WPと同じ寸法かそれよりも小さいことが好ましい。Wf1がWPよりも大きいと、Wf1-WPのフリー磁性層領域が、外部磁界を検知する感度領域として働く場合、その領域ではフリー磁性層の上下のシールド間隔が広がるため、再生波形のパルス幅(PW50)が広がったり分解能が低下するといった問題が発生する。よって前記Wf1はWPと同じ寸法か小さい寸法であることが好ましい。

【0030】

また本発明では、前記多層膜は下から、フリー磁性層、非磁性材料層、固定磁性層及び第1の反強磁性層の順に積層され、少なくとも前記フリー磁性層及び非磁性材料層のトラック幅方向の両側には前記磁化制御層となる永久磁石層が設けられ、前記非磁性材料層上に設けられる固定磁性層の一部あるいは全部が、前記非磁性材料層上から前記永久磁石層の上側にかけて形成され、前記固定磁性層を

構成する第1の磁性層の両側端部上に前記第1の反強磁性層が設けられる構造を提供できる。

【0031】

かかる構造の場合、少なくとも前記フリー磁性層及び非磁性材料層のトラック幅方向の両側には、前記永久磁石層を有する素子両側領域がトラック幅方向に延びて存在し、前記非磁性材料層上に設けられる固定磁性層が、前記非磁性材料層上から前記素子両側領域上にかけて形成される構造であるか、または少なくとも前記フリー磁性層、非磁性材料層並びに固定磁性層を構成する第2の磁性層及び非磁性中間層のトラック幅方向の両側には、前記永久磁石層を有する素子両側領域がトラック幅方向に延びて存在し、前記非磁性中間層上に設けられる前記固定磁性層を構成する第1の磁性層が、前記非磁性中間層上から前記素子両側領域上にかけて形成される構造であることが好ましい。

【0032】

また前記第1反強磁性層に空けられた前記間隔のトラック幅方向における最小寸法は WP で、前記フリー磁性層のトラック幅方向における最小幅寸法は $Wf2$ であり、前記 $Wf2$ は前記 WP と同じ寸法かそれよりも小さいことが好ましい。理由は上記した通りである。

【0033】

さらに本発明では、前記多層膜は下から、第1の反強磁性層、固定磁性層、非磁性材料層及びフリー磁性層の順に積層され、前記第1の反強磁性層はトラック幅方向に所定間隔の間欠部を介して前記第1の磁性層のトラック幅方向の両側端部下に設けられる構造を提供することができる。なお前記第1の反強磁性層の下に設けられた前記基板のトラック幅方向の両側には所定深さの凹み部が設けられ、前記凹み部内に前記第1の反強磁性層が設けられて、前記第1の反強磁性層のトラック幅方向に所定間隔の間欠部が空けられる構造であることが好ましい。

【0034】

また上記の構造において、前記フリー磁性層上に、トラック幅方向に所定の間隔を空け、前記フリー磁性層の両側端部上に設けられた前記磁化制御層が第3の反強磁性層を有して構成される構造を提供でき、このとき前記第1反強磁性層に

空けられた前記間隔のトラック幅方向における最小寸法はWPで、前記磁化制御層に空けられた前記間隔のトラック幅方向における最小寸法はWf3であり、前記Wf3は前記WPと同じ寸法かそれよりも小さいことが好ましい。

【0035】

あるいは前記フリー磁性層のトラック幅方向の両側に前記磁化制御層となる永久磁石層が設けられ、前記永久磁石層の下面は少なくとも前記固定磁性層よりも上側に位置する構造を提供でき、このとき前記第1反強磁性層に空けられた前記間隔のトラック幅方向における最小寸法はWPで、前記フリー磁性層のトラック幅方向における最小幅寸法はWf4であり、前記Wf4は前記WPと同じ寸法かそれよりも小さいことが好ましい。

【0036】

また前記WPは $0.2\mu\text{m}$ 以下であることが好ましい。

また本発明では、電極層が磁気検出素子のトラック幅方向における両側端部に設けられ、前記電極層から前記多層膜に向けてセンス電流を流すことによって形成されるセンス電流磁界の向きは、前記固定磁性層を構成する磁性層の合成磁気モーメントの方向と一致していることが、より固定磁性層の磁化固定を強固にできる上で好ましい。

【0037】

また本発明では、前記間欠部には、両側の第1の反強磁性層と同じ組成の材料層が前記第1の磁性層と接して設けられており、前記間欠部での前記材料層は、前記第1の反強磁性層よりも薄く形成された不規則結晶構造の層であることが好ましい。

【0038】

前記第1の反強磁性層は磁場中熱処理を施されることで、少なくとも一部の不規則格子が規則格子に変態し、反強磁性を発揮するものである。一方、前記間欠部に前記第1の反強磁性層と同じ組成の材料層があっても前記材料層の膜厚は非常に薄いために、磁場中熱処理を施しても不規則格子から規則格子に変態できず、反強磁性を発揮しない不規則結晶構造の層となっている。

【0039】

また本発明は、基板上に下から、フリー磁性層、非磁性材料層、固定磁性層及び第 1 の反強磁性層の順に積層された多層膜と、前記フリー磁性層の磁化制御を行うための磁化制御層とを有する磁気検出素子の製造方法において、

(a) 前記固定磁性層をトラック幅方向に延びる第 2 の磁性層と、前記第 2 の磁性層上に非磁性中間層を介して前記第 2 の磁性層と膜厚方向で対向する第 1 の磁性層とで形成し、さらに前記第 1 の磁性層上に前記第 1 の反強磁性層と同じ組成であり且つ前記第 1 の反強磁性層よりも膜厚が薄く、不規則結晶構造の層である材料層を形成し、前記材料層の上に非磁性層を形成する工程と、

(b) 前記非磁性層を除去し、前記材料層の両側端部上に前記反強磁性層と同じ組成の材料層よりも厚い膜厚の上側反強磁性層を形成し、前記材料層と上側反強磁性層とで前記第 1 の反強磁性層を構成する工程と、

(c) 磁場中アニールを施して、前記第 1 の反強磁性層と第 1 の磁性層の両側端部間に交換結合磁界を生じさせ、前記第 1 の磁性層と第 2 の磁性層を反平行状態に磁化固定する工程、とを有することを特徴とするものである。

【 0 0 4 0 】

また本発明では、前記 (b) 工程に代えて以下の工程を有することが好ましい。

(d) 前記非磁性層を除去した後、前記第 1 の反強磁性層と同じ組成の材料層上に前記材料層よりも膜厚の厚い上側反強磁性層を形成し、前記材料層と上側反強磁性層とで前記第 1 の反強磁性層を構成する工程と、

(e) 前記第 1 の反強磁性層の上側にトラック幅方向に所定の間隔を空けたマスク層を設け、前記マスク層に覆われていない前記第 1 の反強磁性層を削ることで、トラック幅方向に所定の間隔を空け、少なくとも前記第 1 の磁性層の素子両側上に第 1 の反強磁性層を残す工程。

【 0 0 4 1 】

かかる場合、前記反強磁性層と同じ組成の材料層を 50 \AA よりも薄い膜厚で形成することが好ましい。

【 0 0 4 2 】

あるいは本発明は、基板上に下から、第 1 の反強磁性層、固定磁性層、非磁性

材料層及びフリー磁性層の順に積層された多層膜と、前記フリー磁性層の磁化制御を行うための磁化制御層とを有する磁気検出素子の製造方法において、

(f) 前記基板のトラック幅方向における両側に第 1 の反強磁性層を設ける工程と、

(g) 前記第 1 の反強磁性層上から前記第 1 の反強磁性層間の基板上にかけて、トラック幅方向に延びる第 1 の磁性層と、前記第 1 の磁性層上に非磁性中間層を介して前記第 1 の磁性層に膜厚方向で対向する第 2 の磁性層とからなる固定磁性層を形成し、前記固定磁性層上に非磁性材料層及びフリー磁性層を形成する工程と、

(h) 磁場中アニールを施して、前記第 1 の反強磁性層と第 1 の磁性層の両側端部間に交換結合磁界を生じさせ、前記第 1 の磁性層と第 2 の磁性層を反平行状態に磁化固定する工程と、を有することを特徴とするものである。

【0 0 4 3】

このとき、前記 (f) 及び (g) 工程に代えて以下の工程を有することが好ましい。

(i) 前記基板のトラック幅方向における両側に所定深さの凹み部を設ける工程と、

(j) 前記凹み部内に前記第 1 の反強磁性層を形成し、さらに前記第 1 の反強磁性層上に非磁性層を形成する工程と、

(k) 前記非磁性層を除去した後、前記第 1 の反強磁性層上から基板上にかけて前記第 1 の反強磁性層と同じ組成であり且つ前記第 1 の反強磁性層よりも膜厚が薄く、不規則結晶構造の層である材料層を形成し、前記第 1 の反強磁性層上に重ねられた材料層を第 1 の反強磁性層の一部として構成し、さらに前記第 1 の反強磁性層及び前記材料層上に、トラック幅方向に延びる第 1 の磁性層と、前記第 1 の磁性層上に非磁性中間層を介して前記第 1 の磁性層に膜厚方向で対向する第 2 の磁性層とからなる固定磁性層を形成し、前記固定磁性層上に非磁性材料層及びフリー磁性層を形成する工程。

【0 0 4 4】

または前記 (f) 及び (g) 工程に代えて以下の工程を有することが好ましい

。

(l) 基板上に第1の磁性層及び非磁性中間層を成膜する工程と、

(m) 前記基板のトラック幅方向における両側に所定深さの凹み部を設ける工程と、

(n) 前記凹み部内に前記第1の反強磁性層を形成し、さらに前記第1の反強磁性層上に第1の磁性層及び非磁性中間層を形成する工程と、

(o) 前記非磁性中間層の上面を一部除去した後、前記非磁性中間層上に第2の磁性層を形成し、第1の磁性層、第2の磁性層及び非磁性中間層で固定磁性層を構成し、前記固定磁性層上に非磁性材料層及びフリー磁性層を形成する工程。

【0045】

なお前記上側反強磁性層を 50 \AA よりも薄い膜厚で形成することが好ましい。

上記した (a) ないし (e) 工程を施すことで、固定磁性層の上に第1の反強磁性層を所定形状で形成でき、且つ前記第1の磁性層の両側端部と第1の反強磁性層間で所定の大きさの交換結合磁界を生じさせることができ、(f) ないし (o) 工程を施すことで、固定磁性層の下に第1の反強磁性層を所定の形状で形成でき、且つ前記第1の磁性層の両側端部と第1の反強磁性層間で所定の大きさの交換結合磁界を生じさせることができる。

【0046】

前記固定磁性層の上あるいは下に前記第1の反強磁性層を設ける際、特に前記固定磁性層の下に第1の反強磁性層を設ける際には、単純に固定磁性層と第1の反強磁性層とを積層すればよいのではなく、固定磁性層のトラック幅方向における両側端部と前記第1の反強磁性層間で所定の大きさの交換結合磁界を生じさせるには、前記固定磁性層と第1の反強磁性層とを積層する際に工夫が必要である。

【0047】

上記した (a) ないし (d) 工程、あるいは (e) ないし (h) 工程を施すことで、前記固定磁性層を第1の磁性層と第2の磁性層と両磁性層間に介在する非磁性層とを有する構造で形成でき、さらに前記第1の反強磁性層にトラック幅方向に所定の間隔を空け、且つ前記第1の磁性層の両側端部間でのみ交換結合磁界

を生じさせることのできる磁気検出素子を製造することが可能になるのである。

【 0 0 4 8 】

なお第 1 の反強磁性層が固定磁性層の上側に形成され、且つフリー磁性層の磁化制御層として永久磁石層が形成される場合には、単純に固定磁性層と第 1 の反強磁性層とを連続して成膜すればよく製造工程が容易である。

【 0 0 4 9 】

【発明の実施の形態】

図 1 は本発明における第 1 の実施形態の磁気検出素子（スピンバルブ型薄膜素子）の構造を記録媒体との対向面側から見た部分断面図である。図 1 に示す磁気検出素子はフリー磁性層 2 4 が第 1 の反強磁性層 3 0 よりも下側に形成されるタイプである。

【 0 0 5 0 】

符号 2 0 は磁性材料製の下部シールド層（基板）である。前記下部シールド層 2 0 は N i F e 合金やセンダストなどで形成される。図 1 に示すように前記下部シールド層 2 0 にはトラック幅方向（図示 X 方向）の中央に膜厚方向（図示 Z 方向）に突出する突出部 2 0 a が設けられ、そのトラック幅方向の両側に凹み部 2 0 b が設けられる。

【 0 0 5 1 】

図 1 に示すように前記下部シールド層 2 0 の突出部 2 0 a の上面には A l₂O₃ などの絶縁材料で形成された下部ギャップ層 2 1 が形成され、前記下部ギャップ層 2 1 は、前記突出部 2 0 a のトラック幅方向における両側端面 2 0 a 1 から前記凹み部 2 0 b の上面にかけても形成されている。

【 0 0 5 2 】

図 1 に示すように前記下部シールド層 2 0 の凹み部 2 0 b 上及び突出部 2 0 a 上に形成された下部ギャップ層 2 1 上には N i F e 合金、N i F e C r 合金あるいは C r などで形成されたシード層 2 2 が形成されている。

【 0 0 5 3 】

図 1 に示すように前記シード層 2 2 上には第 2 の反強磁性層 2 3 が形成されている。この第 2 の反強磁性層 2 3 は主に前記下部シールド層 2 0 に形成された凹

み部 20b 内に埋められた状態になっている。前記第 2 の反強磁性層 23 は例えば PtMn 合金などの反強磁性材料で形成される。

【0054】

前記第 2 の反強磁性層 23 と同じ組成の材料で形成された層は前記下部シールド層 20 の突出部 20a 上に形成されたシード層 22 上にも形成されているが、この部分での前記層の膜厚は、前記下部シールド層 20 の凹み部 20b 内に形成された前記第 2 の反強磁性層 23 の膜厚よりも薄くなっている。前記下部シールド層 20 の突出部 20a 上に形成された前記第 2 の反強磁性層 23 と同じ組成で形成された材料層の膜厚は 50 \AA よりも薄いことが好ましく、前記材料層は不規則結晶構造で前記フリー磁性層 24 との間で交換結合磁界が生じておらず、前記フリー磁性層 24 の素子中央部 24b が、前記交換結合磁界によって磁化固定されることを回避している。すなわち前記材料層は不規則結晶構造の層である。

【0055】

図 1 に示すように前記第 2 の反強磁性層 23 上にはフリー磁性層 24 が形成される。前記フリー磁性層 24 は NiFe 合金や CoFe 合金などの磁性材料で形成される。また図 1 に示す磁気検出素子では前記フリー磁性層 24 が単層構造であるが、複数の磁性層が積層された構造であってもよいし、あるいは 2 つの磁性層間に非磁性層が介在する人工フェリ構造であってもよい。

【0056】

図 1 に示す実施の形態では、前記フリー磁性層 24 のトラック幅方向（図示 X 方向）における両側端部 24a がその下に接して形成された膜厚の厚い第 2 の反強磁性層 23 との間で発生する交換結合磁界によって図示 X 方向に磁化固定されている。一方、前記フリー磁性層 24 のトラック幅方向における中央部 24b では、その下に非常に薄い膜厚の第 2 の反強磁性層 23 と同じ組成の材料層が形成されており、この材料層は不規則結晶構造の層であるため前記第 2 の反強磁性層 23 との間で交換結合磁界が発生しておらず、前記フリー磁性層 24 の中央部 24b がその両側端部 24a のように強固に磁化固定されない。前記フリー磁性層 24 の中央部 24b の磁化は図示 Y 方向から進入してくる外部磁界によって磁化変動する程度に弱く単磁区化された状態にある。

【0057】

前記フリー磁性層 24 の上には非磁性材料層 25 が形成されている。前記非磁性材料層 25 は、固定磁性層 26 とフリー磁性層 24 との磁気的な結合を防止し、またセンス電流が主に流れる層であり、Cu, Cr, Au, Ag など導電性を有する非磁性材料により形成されることが好ましい。特に Cu によって形成されることが好ましい。

【0058】

前記非磁性材料層 25 の上には固定磁性層 26 が形成されている。図 1 に示す実施形態では、固定磁性層 26 は人工フェリ構造である。前記固定磁性層 26 は第 1 の反強磁性層 30 に接する側の第 1 の磁性層 29 と、前記第 1 の磁性層 29 と膜厚方向（図示 Z 方向）で対向する第 2 の磁性層 27 と、前記第 1 の磁性層 29 と第 2 の磁性層 27 間に介在する非磁性中間層 28 との 3 層構造である。

【0059】

前記磁性層 27、29 は、例えば NiFe 合金、Co、CoNiFe 合金、CoFe 合金、CoNi 合金などの磁性材料で形成される。前記第 1 の磁性層 29 と第 2 の磁性層 27 は、同一の材料で形成されることが好ましい。また単層構造であっても磁性層の積層構造であってもどちらでもよい。

【0060】

また前記非磁性中間層 28 は、非磁性材料により形成されるもので、Ru、Rh、Ir、Cr、Re、Cu のうち 1 種またはこれらの 2 種以上の合金で形成されている。特に Ru によって形成されることが好ましい。

【0061】

図 1 に示す実施形態では前記第 1 の磁性層 29 のトラック幅方向（図示 X 方向）における両側端部 29a 上に第 1 の反強磁性層 30 が形成されている。前記第 1 の反強磁性層 30 は前記第 1 の磁性層 29 の中央部 29b 上には形成されておらず、その部分に所定の間隔 C が形成されている。前記第 1 の反強磁性層 30 は、PtMn 合金、または、X—Mn（ただし X は、Pd, Ir, Rh, Ru, Os, Ni, Fe のいずれか 1 種または 2 種以上の元素である）合金で、あるいは Pt—Mn—X'（ただし X' は、Pd, Ir, Rh, Ru, Au, Ag, Os

、Cr、Ni、Ar、Ne、Xe、Krのいずれか1または2種以上の元素である)合金で形成されることが好ましいが、IrMn合金などPtMn合金よりもブロッキング温度の低い反強磁性材料で形成されてもよい。

【0062】

磁場中熱処理が施されると前記第1の反強磁性層30と第1の磁性層29の両側端部29a間に交換結合磁界が発生し、前記第1の磁性層29は図示Y方向に磁化固定される。このため磁場中熱処理が施された後の段階では前記第1の反強磁性層30は少なくとも一部が不規則格子から規則格子に変態した状態になっている。

【0063】

図1に示す実施形態では、前記固定磁性層26が2層の磁性層27、29とその間に介在する非磁性中間層28との人工フェリ構造であるから前記第1の磁性層29と第2の磁性層27間にRKKY相互作用による反平行磁界が作用し、前記第2の磁性層27の両側端部27aは図示Y方向とは逆方向に磁化固定される。一方、前記第1の磁性層29及び第2の磁性層27の中央部29b、27bでも上記したRKKY相互作用による反平行結合磁界は生じ、前記第1の磁性層29及び第2の磁性層27の中央部29b、27bの磁化は両側端部29a、27aでの磁化方向に倣って反平行状態で磁化固定される。

【0064】

図1に示すように、前記第1の反強磁性層30の上にはCrなどで形成されたストッパ層31が形成され、前記ストッパ層31の上にはTaなどで形成された保護層32が形成されている。前記保護層32上には例えばAu、Pd、Cr、Rh、Ru、Ta、Wなどの非磁性導電材料で形成された電極層33が形成され、さらに前記電極層33上にTaなどで形成された保護層34が形成されている。

【0065】

図1に示すように前記保護層34から、前記第1の反強磁性層30間に形成された間隔C内から露出する固定磁性層26の第1の磁性層29上にかけて絶縁材料で形成された上部ギャップ層35が形成され、前記上部ギャップ層35上に磁

性材料製の上部シールド層 36 が形成されている。

【0066】

図 1 に示す実施形態では、前記下部シールド層 20 の突出部 20a と膜厚方向（図示 Z 方向）で対向するフリー磁性層 24 のトラック幅方向（図示 X 方向）における幅寸法がトラック幅 T_w である。なおここで言うトラック幅 T_w とは物理的なトラック幅（Physical Read Track Width；略してトラック幅 $R T_w$ とも言う）であり、以下においても同じである。

【0067】

図 1 に示す磁気検出素子の構造の特徴的部分について以下に説明する。図 1 に示す実施の形態では、前記固定磁性層 26 が、第 1 の反強磁性層 30 と接する側の第 1 の磁性層 29 と、前記第 1 の磁性層 29 と膜厚方向で対向する第 2 の磁性層 27 と、前記第 1 の磁性層 29 と第 2 の磁性層 27 間に介在する非磁性中間層 28 との 3 層構造で構成されている。前記第 1 の磁性層 29 と第 2 の磁性層 27 間には RKKY 相互作用による反平行結合磁界が生じるため、両磁性層 27、29 の磁化は反平行状態になっている。

【0068】

前記第 1 の反強磁性層 30 は、前記第 1 の磁性層 29 の両側端部 29a 上のみ設けられ、前記第 1 の磁性層 29 の中央部 29b 上には設けられていない。このため交換結合磁界は前記第 1 の磁性層 29 の両側端部 29a との間でのみ生じ、前記第 1 の磁性層 29 の中央部 29b との間には生じていない。したがって前記第 1 の磁性層 29 及び第 2 の磁性層 27 の両側端部 29a、27a の磁化は前記交換結合磁界と RKKY 相互作用等により反平行状態を保ちながらハイト方向（図示 Y 方向）と平行な方向に固定されている。

【0069】

一方、前記固定磁性層 26 の第 1 の磁性層 29 及び第 2 の磁性層 27 の中央部 29b、27b では各磁性層内部の交換相互作用により媒介されたバイアス磁界や上記した RKKY 相互作用によって反平行状態を保ってハイト方向（図示 Y 方向）と平行な方向に固定されることが後述する実験でも確認されており、図 1 に示す実施の形態であれば、前記固定磁性層 26 の磁化固定を適切に行うことが可

能である。

【0070】

すなわち図1のように固定磁性層26上に設けられた第1の反強磁性層30は、前記固定磁性層26のトラック幅方向における両側端部上に設けられ、この両側端部でのみ交換結合磁界が生じるが、この第1の反強磁性層30の構造に対して、前記固定磁性層26を人工フェリ構造にすることで、前記固定磁性層26全体の磁化を適切にハイト方向に磁化固定できるのである。

【0071】

そして図1に示す構造の磁気検出素子であれば前記固定磁性層26の磁化を確実に固定できる上、以下のような効果を期待できる。まず前記第1の磁性層29の中央部29b上には前記第1の反強磁性層30が設けられていないので、前記電極層33から主に非磁性材料層25を中心として流れるセンス電流が、その非磁性材料層25にたどり着くまでに前記第1の反強磁性層30に分流することが少なくなり、分流ロスを軽減できる結果、再生出力の向上を図ることが可能である。

【0072】

また前記第1の磁性層29の中央部29b上に前記第1の反強磁性層30を設けないことで、素子中央部でのシールド層20、36の膜厚方向（図示Z方向）への間隔は狭まり、いわゆる狭ギャップ化を図ることが可能である。フリー磁性層24の中央部24bが再生感度を持つ領域であるから、素子中央部でのギャップ長を短くできれば、再生波形のパルス幅（PW50）が広がって分解能が低下するといった問題を適切に防止でき、今後の高記録密度化に適切に対応可能な磁気検出素子を製造することが可能である。

【0073】

さらに前記第1の磁性層29の中央部29b上に前記第1の反強磁性層30を設けないことで、前記固定磁性層26の素子中央部での時期的な静電破壊（soft ESD）は起こりにくくなる。従来では、前記第1の反強磁性層は固定磁性層上全体に設けられていたから、前記第1の反強磁性層のブロッキング温度を超える高い熱の発生等により、交換結合磁界が弱まり素子中央部での固定磁性層

の磁化固定状態が崩れて再生特性の劣化を招いたが、図1のように第1の磁性層29の中央部29b上に前記第1の反強磁性層30を設けなければ、そもそも固定磁性層26の中央部に前記第1の反強磁性層30のブロッキング温度と発熱との温度関係等を気にする必要がなく、上記した静電破壊の発生を未然に防ぐことができる。また第1の反強磁性層30が設けられている素子両側端部には抵抗の小さい電極層33が重ねられ、かつ素子高さ方向（図示Y方向）に長く形成されるため、両側端部での電流密度は中央部に比べてはるかに低く、ジュール熱が発生しにくくなっており、よって前記両側端部で静電破壊は元々起こりにくい構造となっている。

【0074】

このように、図1に示す磁気検出素子の構造では、固定磁性層26の磁化を適切にハイト方向に磁化固定できるとともに、再生出力の向上や狭ギャップ化及び静電破壊の抑制をも図ることができ、今後の更なる高記録密度化に適切に対応可能な磁気検出素子を提供することができる。

【0075】

また図1に示す磁気検出素子では、前記下部シールド層20の両側端部に設けられた凹み部20b内に第2の反強磁性層23が埋められることで前記第2の反強磁性層23間にはトラック幅方向（図示X方向）に所定の間隔Dが形成され、この間隔Dのトラック幅方向における最小幅寸法は $Wf1$ である（図1の実施形態では前記最小幅寸法 $Wf1$ はトラック幅 Tw と同じ寸法である）。

【0076】

また前記第1の反強磁性層30間に形成された間隔Cはトラック幅方向に最小寸法 WP で形成される。

【0077】

そして図1に示す実施の形態では、前記最小幅寸法 $Wf1$ は最小寸法 WP と同じかあるいはそれよりも小さくなっている。このように最小幅寸法 $Wf1$ を最小寸法 WP と同じかあるいはそれよりも小さくすることで、フリー磁性層24の中央部24bは確実にシールド層20、36の膜厚方向への間隔（いわゆるギャップ長）が最も狭い間に位置し、再生パルス幅（ $PW50$ ）の広がりや分解能の低

下を抑制できる。前記フリー磁性層 24 の中央部 24 b は再生感度に優れた部分で、この部分が実質的に磁気抵抗効果に寄与する部分であるから、前記フリー磁性層 24 の中央部 24 b の上下に設けられるシールド層 20、36 の間隔は最も狭くなるようにして、余分な外部磁界が前記中央部 24 b 内に入り込まないようにすることが必要である。

【0078】

なお前記第 1 の反強磁性層 30 間の最小寸法 WP は $0.3 \mu\text{m}$ 以下であることが好ましく、より好ましくは $0.2 \mu\text{m}$ 以下である。後述する実験によれば前記最小寸法 WP を狭くすることで一方向性交換バイアス磁界を大きくでき、さらに再生出力を大きくできることがわかった。前記最小寸法 WP を狭くするほど、素子中央部における前記第 1 の磁性層 29 と第 2 の磁性層 27 の磁化を効果的に反平行状態に磁化固定できるからである。

【0079】

次に前記固定磁性層 26 を構成する第 1 の磁性層 29 と第 2 の磁性層 27 の単位面積当たりの磁気モーメントについて説明する。

【0080】

前記第 2 の磁性層 27 の単位面積当たりの磁気モーメント（飽和磁化 $M_s \times$ 膜厚 t ）から第 1 の磁性層 29 の単位面積当たりの磁気モーメントを引いた単位面積当たりの合成磁気モーメントは $-6 \text{ (T} \cdot \text{nm)}$ 以上で $2.6 \text{ (T} \cdot \text{nm)}$ 以下の範囲内であると、第 1 の反強磁性層 30 が上に形成されていない前記固定磁性層 26 の素子中央部がトラック幅方向の磁界によっても回転せず、回転しても $\cos \theta \geq 0.8$ となる回転角 θ 以下に抑えることができる。

【0081】

なおより好ましくは、前記合成磁気モーメントは $0 \text{ (T} \cdot \text{nm)}$ より大きく $2.6 \text{ (T} \cdot \text{nm)}$ 以下であり、前記固定磁性層 26 のスピントロップ磁界を大きくでき、前記固定磁性層 26 を磁化制御する際の前記磁場中アニール時の磁場強度のマージンを広く取ることが可能になり、前記固定磁性層 26 の第 1 の磁性層 29 と第 2 の磁性層 27 を適切にハイト方向と平行な方向であって且つ反平行に磁化固定しやすい。

【0082】

なお前記第2の磁性層27の膜厚から第1の磁性層29の膜厚を引いた膜厚差は -30 \AA 以上で 30 \AA 以下の範囲内であることが好ましい。第1の反強磁性層30が上に形成されていない前記固定磁性層26の素子中央部が外部磁界によって回転せず、回転しても $\cos\theta \geq 0.8$ となる回転角 θ 以下に抑えることができる。また前記膜厚差は 0 \AA 以上で 30 \AA 以下の範囲内であることがより好ましく、前記固定磁性層26のスピンフロップ磁界を大きくでき、前記固定磁性層26を磁化制御する際の前記磁場中アニール時の磁場強度のマージンを広く取ることが可能になる。

【0083】

次に図1に示す実施の形態では、前記第1の反強磁性層30の上に電極層33が設けられ、前記電極層33から、固定磁性層26、非磁性材料層25及びフリー磁性層24の多層膜へ向けて流れるセンス電流は各層を膜面と平行な方向（図示X方向）に流れる。このとき前記センス電流を流すことによって形成されるセンス電流磁界の向きは、前記固定磁性層26を構成する第1の磁性層29と第2の磁性層27との合成磁気モーメントの向きと一致していることが前記固定磁性層26の磁化固定をさらに強固なものにできて好ましい。

【0084】

図13は、図1に示す固定磁性層26、非磁性材料層25及びフリー磁性層24の部分を図示Y-Z平面と平行な方向から切断した部分模式図である。第1の磁性層29の磁化は図示右側に向いており、第2の磁性層27の磁化は図示左側に向いている。図13では例えば前記第1の磁性層29と第2の磁性層27は共に同じ材質で形成され、前記第1の磁性層29の膜厚の方が前記第2の磁性層27の膜厚に比べて厚くなっているから、前記第1の磁性層29の単位面積当たりの磁気モーメント（飽和磁化 $M_s \times$ 膜厚 t ）の方が前記第2の磁性層27の単位面積当たりの磁気モーメントよりも大きくなっている。このため合成磁気モーメントは図示右方向に向いている。

【0085】

一方、センス電流は紙面垂直下方向に向いており、センス電流が流れることに

よって発生するセンス電流磁界は、固定磁性層 26 側で図示右方向を向いており、よって前記合成磁気モーメントの方向と一致している。

【0086】

一方、図 14 は図 13 と異なって第 1 の磁性層 29 の単位面積当たりの磁気モーメントが第 2 の磁性層 27 よりも小さくなっているが、前記第 1 の磁性層 29 及び第 2 の磁性層 27 の磁化方向を図 13 とは反対にすることで、合成磁気モーメントは図示右方向を向き、同じく固定磁性層 26 側で図示右方向を向いているセンス電流磁界の向きと一致している。

【0087】

このように、合成磁気モーメントの向きを変えるには、各磁性層 27、29 の磁化方向や単位面積当たりの磁気モーメントの大きさをえることで行うことができる。

【0088】

図 2 は本発明における第 2 の実施形態の磁気検出素子（スピンバルブ型薄膜素子）の構造を記録媒体との対向面側から見た部分断面図である。図 2 に示す磁気検出素子は図 1 と同様にフリー磁性層 24 が第 1 の反強磁性層 30 よりも下側に形成されるタイプである。

【0089】

図 2 の磁気検出素子と図 1 の磁気検出素子と構造上異なる点は、第 2 の反強磁性層 23 とフリー磁性層 24 の形状の部分のみであり、それ以外は同じ構造である。

【0090】

図 2 では、前記下部シールド層 20 のトラック幅方向（図示 X 方向）の両側に形成された凹み部 20b 内に第 2 反強磁性層 23 とともに、前記第 2 反強磁性層 23 の上にフリー磁性層 24 の下層部 24c も埋め込まれている。図 2 では前記フリー磁性層 24 の上層部 24d が前記下層部 24c 上から前記下部シールド層 20 の突出部 20a 上に形成されたシード層 22 上にまで形成されている。前記フリー磁性層 24 の下層部 24c と上層部 24d との界面は点線で示されているようにその存在の有無を判別しにくく、前記下層部 24c と上層部 24d とが一

体化されている。

【0091】

図2に示す実施の形態では前記第2の反強磁性層23が前記下部シールド層20の凹み部20b内にのみ埋められており、図1のように前記下部シールド層20の突出部20a上に前記第2の反強磁性層23と同じ組成の材料層が薄い膜厚で残っていない。

【0092】

図1と図2の前記第2の反強磁性層23とフリー磁性層24の形状の違いは製造方法が異なるために生じる違いであり、特に固定磁性層26と第1の反強磁性層30との交換結合膜に関する効果は、図1と異なるところが無い。

【0093】

次に図3ないし図8に示す各実施の形態は、磁気検出素子（スピンバルブ型薄膜素子）の構造を記録媒体との対向面側から見た部分断面図であり、図3ないし図8に示す磁気検出素子は図1と同様にフリー磁性層24が第1の反強磁性層30よりも下側に形成されるタイプである。

【0094】

ただし図1及び図2では、前記フリー磁性層24の磁化制御層として第2の反強磁性層23を用いていたが、図3ないし図8では永久磁石層41を用いて前記フリー磁性層24の磁化制御を行っている。なお図3ないし図8において、図1と同じ符号がつけられている層は図1と同じ層であるので説明を省略する。

【0095】

図3に示すように、前記下部シールド層20上に下部ギャップ層21が形成され、前記下部ギャップ層21のトラック幅方向（図示X方向）における中央部上にシード層22が形成される。さらに前記シード層22上にはフリー磁性層24が形成され、前記フリー磁性層24のトラック幅方向の両側に前記フリー磁性層24の磁化制御層となる永久磁石層41が形成されている。前記永久磁石層41はCoPt合金やCoPtCr合金などで形成される。図3に示すように前記永久磁石層41の下にはCrやWなどで形成されたバイアス下地層40が形成されており、このバイアス下地層40の上に前記永久磁石層41を設けることで前記

永久磁石層 4 1 の特性（保磁力 H_c や角形比 S ）を向上させることができる。なおトラック幅 T_w は前記フリー磁性層 2 4 の上面のトラック幅方向への幅寸法で規制される。

【0096】

また前記永久磁石層 4 1 の上には、 T_a などで形成された保護層 4 2 及びシード層 2 2 が積層形成されており、前記フリー磁性層 2 4 の両側には、前記永久磁石層 4 1 や保護層 4 2 及びシード層 2 2 を有する素子両側領域 A がトラック幅方向に広がって形成されている。

【0097】

図 3 では前記永久磁石層 4 1 からトラック幅方向への縦バイアス磁界が前記フリー磁性層 2 4 に作用し、前記フリー磁性層 2 4 の磁化がトラック幅方向へ単磁区化される。

【0098】

図 3 では、前記フリー磁性層 2 4 の上に非磁性材料層 2 5 の下層部 2 5 a が形成され、この下層部 2 5 a のトラック幅方向の両側に前記素子両側領域 A が広がり、またこの下層部 2 5 a と一体に形成された前記非磁性材料層 2 5 の上層部 2 5 b が前記下層部 2 5 a 上から前記素子両側領域 A 上に伸びて形成され、前記下層部 2 5 a と上層部 2 5 b とで非磁性材料層 2 5 が構成される。なお図面では下層部 2 5 a と上層部 2 5 b との境界は点線で示されている。

【0099】

図 3 に示すように、前記非磁性材料層 2 5 上には、第 1 の磁性層 2 9 と第 2 の磁性層 2 7 とその間に介在する非磁性中間層 2 8 との人工フェリ構造で構成される固定磁性層 2 6 が形成されている。前記第 1 の磁性層 2 9 と第 2 の磁性層 2 7 間には RKKY 相互作用による反平行結合磁界が生じるため、両磁性層 2 7、2 9 の磁化は反平行状態になっている。

【0100】

図 3 に示すように第 1 の反強磁性層 3 0 は、前記第 1 の磁性層 2 9 の両側端部 2 9 a 上にのみ設けられ、前記第 1 の磁性層 2 9 の中央部 2 9 b には設けられていない。このため交換結合磁界は前記第 1 の磁性層 2 9 の両側端部 2 9 a との間

でのみ生じ、前記第1の磁性層29の中央部29bとの間には生じていない。したがって前記第1の磁性層29及び第2の磁性層27の両側端部29a、27aの磁化は前記交換結合磁界とRKKY相互作用等により反平行状態を保ちながらハイト方向（図示Y方向）と平行な方向に固定されている。

【0101】

一方、前記固定磁性層26の第1の磁性層29及び第2の磁性層27の中央部29b、27bでは各磁性層内部の交換相互作用により媒介されたバイアス磁界や上記したRKKY相互作用によって反平行状態を保ってハイト方向（図示Y方向）と平行な方向に固定され、図3に示す実施の形態であれば、前記固定磁性層26の磁化固定を適切に行うことが可能である。

【0102】

そして図3に示す磁気検出素子の構造により、前記固定磁性層26の磁化を適切にハイト方向に磁化固定できるとともに、再生出力の向上や狭ギャップ化さらには静電破壊（ESD）に対して強くでき、今後の更なる高記録密度化に適切に対応可能な磁気検出素子を提供することができる。

【0103】

また図3に示す磁気検出素子では、前記永久磁石層41間に挟まれたフリー磁性層24のトラック幅方向への最小幅寸法は $Wf2$ （図3の実施形態では前記最小幅寸法 $Wf2$ はトラック幅 Tw と同じ寸法である）であり、また前記第1の反強磁性層30間に形成された間隔Cはトラック幅方向に最小寸法 WP で形成される。

【0104】

そして図3に示す実施の形態では、前記最小幅寸法 $Wf2$ は最小寸法 WP と同じかあるいはそれよりも小さくなっている。このように最小幅寸法 $Wf2$ を最小寸法 WP と同じかあるいはそれよりも小さくすることで、フリー磁性層24は確実にシールド層20、36の膜厚方向への間隔（いわゆるギャップ長）が最も狭い間に位置し、再生パルス幅（ $PW50$ ）の広がりや分解能の低下を抑制できる。

【0105】

また図3に示す実施の形態では、前記第1の反強磁性層30の上に電極層33が設けられ、前記電極層33から、固定磁性層26、非磁性材料層25及びフリー磁性層24等で構成される多層膜へ向けて流れるセンス電流は各層を膜面と平行な方向（図示X方向）に流れる。このとき前記センス電流を流すことによって形成されるセンス電流磁界の向きは、前記固定磁性層26を構成する第1の磁性層29と第2の磁性層27との合成磁気モーメントの向きと一致していることが前記固定磁性層26の磁化固定をさらに強固なものにできて好ましい。前記合成磁気モーメントの向きとセンス電流磁界の向きとの一致のさせ方については図13及び図14で説明したのでそちらを参照されたい。

【0106】

なお第1の磁性層29と第2の磁性層27の単位面積当たりの合成磁気モーメントの好ましい範囲などは図1で説明した通りなのでそちらを参照されたい。なお図3の場合は、後述の製造方法で説明する第2の磁場中アニールを行う必要がないため前記合成磁気モーメントを0 T・nmより大きくする必要は無い。

【0107】

図4は図3と異なり、前記下部ギャップ層21のトラック幅方向（図示X方向）における中央部上にシード層22、フリー磁性層24及び非磁性材料層25が形成され、さらに前記非磁性材料層25上に固定磁性層26を構成する第2の磁性層27の下層部27cが形成され、前記シード層22から前記下層部27cのトラック幅方向の両側に永久磁石層41を有する素子両側領域Aが形成されている。

【0108】

図4では前記第2の磁性層27の下層部27c上から前記素子両側領域A上にかけて前記第2の磁性層27の上層部27dが形成され、前記下層部27cと上層部27dとが一体化して第2の磁性層27が構成されている。

【0109】

図5は図3及び図4と異なり、前記下部ギャップ層21のトラック幅方向（図示X方向）における中央部上にシード層22、フリー磁性層24、非磁性材料層25、固定磁性層26を構成する第2の磁性層27及び非磁性中間層28が形成

され、さらに前記非磁性中間層 28 の上に第 1 の磁性層 29 の下層部 29c が形成され、前記シード層 22 から前記第 1 の磁性層 29 の下層部 29c のトラック幅方向の両側に永久磁石層 41 を有する素子両側領域 A が形成されている。

【0110】

図 5 では前記第 1 の磁性層 29 の下層部 29c 上から前記素子両側領域 A 上にかけて前記第 1 の磁性層 29 の上層部 29d が形成され、前記下層部 29c と上層部 29d とが一体化して第 1 の磁性層 29 が構成されている。

【0111】

図 6 は図 3 ないし図 5 と異なり、前記下部ギャップ層 21 のトラック幅方向（図示 X 方向）における中央部上にシード層 22、フリー磁性層 24、非磁性材料層 25、固定磁性層 26 を構成する第 2 の磁性層 27 及び非磁性中間層 28 が形成され、さらに前記非磁性中間層 28 の上に磁性中間層 43 の下層部 43a が形成され、前記シード層 22 から前記磁性中間層 43 の下層部 43a のトラック幅方向の両側に永久磁石層 41 を有する素子両側領域 A が形成されている。

【0112】

図 6 では前記磁性中間層 43 の下層部 43a 上から前記素子両側領域 A 上にかけて前記磁性中間層 43 の上層部 43b が形成され、前記下層部 43a と上層部 43b とが一体化して磁性中間層 43 が構成されている。さらに前記磁性中間層 43 上には非磁性中間層 28 と同様の材質で形成された非磁性中間層 44 が形成され、前記非磁性中間層 44 の上に第 1 の磁性層 29 が形成される。図 6 では前記固定磁性層 26 が 5 層の積層構造である。

【0113】

図 7 は図 3 ないし図 6 と異なり、前記下部ギャップ層 21 のトラック幅方向（図示 X 方向）における中央部上にシード層 22、フリー磁性層 24、非磁性材料層 25、固定磁性層 26 を構成する第 2 の磁性層 27、非磁性中間層 28 が形成され、前記シード層 22 から前記非磁性中間層 28 のトラック幅方向の両側に永久磁石層 41 を有する素子両側領域 A が形成されている。

【0114】

図 7 では前記非磁性中間層 28 上から前記素子両側領域 A 上にかけて第 1 の磁

性層 29 が形成されている。

【0115】

図8は図3ないし図7と異なり、前記下部ギャップ層 21 のトラック幅方向（図示 X 方向）における中央部上にシード層 22、フリー磁性層 24、非磁性材料層 25、固定磁性層 26 を構成する第2の磁性層 27、非磁性中間層 28 が形成され、前記シード層 22 から前記非磁性中間層 28 のトラック幅方向の両側に永久磁石層 41 を有する素子両側領域 A が形成されている。

【0116】

図8では前記非磁性中間層 28 上から前記素子両側領域 A 上にかけて磁性中間層 43 が形成され、さらに前記磁性中間層 43 の上に非磁性中間層 44 及び第1の磁性層 29 が積層形成されている。

【0117】

図3ないし図8に示す構造の違いは製造方法に起因するもので、図3のように非磁性材料層 25 を製造の際に下層部 25a と上層部 25b とを別々に形成した場合や図4のように第2の磁性層 27 を製造の際に下層部 27c と上層部 27d とを別々に形成した場合には、その下層部と上層部間に原子配列の乱れが発生しやすくその結果、MR 特性の低下が懸念されるが、固定磁性層 26 の両側端部を確実に磁化固定できるという効果を期待できる。

【0118】

図5では、第1の磁性層 29 の下層部 29c と上層部 29d とを別々に形成することで、前記固定磁性層 26 の中央部での磁化固定が適切に行われるか否か不安が残るが、MR 特性の向上を期待することができる。

【0119】

また図6では、固定磁性層 26 に磁性中間層 43 を設けることで、前記磁性中間層 43 への電流ロスで再生出力の低下が懸念されるが、固定磁性層 26 の磁化固定の適正化及び MR 特性の向上を期待することができる。

【0120】

図7では図5と同様に、前記固定磁性層 26 の中央部での磁化固定が適切に行われるか否か不安が残るが、MR 特性の向上を期待することができ、図8では図

6と同様に、前記磁性中間層43への電流ロスで再生出力の低下が懸念されるが、固定磁性層26の磁化固定の適正化及びMR特性の向上を期待することができる。

【0121】

また図9に示す磁気検出素子は、下部ギャップ層21上にトラック幅方向（図示X方向）に所定間隔を空けて一对の永久磁石層41が形成され、この永久磁石層41の上から前記永久磁石層41間の間隔内にかけてフリー磁性層24が形成されている。この実施形態では前記フリー磁性層24と永久磁石層41との界面は直接接していた方がよく、これにより適切にサイドリーディングの発生を抑制できる。

【0122】

図10は本発明における第9の実施形態の磁気検出素子（スピバルブ型薄膜素子）の構造を記録媒体との対向面側から見た部分断面図である。図10に示す磁気検出素子はフリー磁性層24が第1の反強磁性層30よりも上側に形成されるタイプである。

【0123】

図10に示すように下部シールド層20にはトラック幅方向（図示X方向）の中央に膜厚方向（図示Z方向）に突出する突出部20aが設けられ、そのトラック幅方向の両側に凹み部20bが設けられる。

【0124】

図10に示すように前記下部シールド層20の突出部20aの上面にはA12O3などの絶縁材料で形成された下部ギャップ層21が形成され、前記下部ギャップ層21は、前記突出部20aのトラック幅方向における両側端面20a1から前記凹み部20bの上面にかけても形成されている。

【0125】

図10に示すように前記下部シールド層20の凹み部20b上及び突出部20a上に形成された下部ギャップ層21上にはNiFe合金、NiFeCr合金あるいはCrなどで形成されたシード層22が形成されている。

【0126】

図10に示すように前記下部シールド層20の凹み部20b内に形成された前記シード層22上には第1の反強磁性層30が形成されている。よって前記第1の反強磁性層30は前記下部シールド層20の凹み部20b内に埋められた状態になっている。

【0127】

前記第1の反強磁性層30は前記下部シールド層20の突出部20a上に形成されたシード層22上に形成されておらず、交換結合磁界は前記固定磁性層26を構成する第1の磁性層29の両側端部29aと前記第1の反強磁性層30との間でのみ生じている。なお前記下部シールド層20の突出部20a上に第1の反強磁性層30と同じ組成の材料層が50Åよりも薄い膜厚で形成されていてもよく、かかる場合、前記固定磁性層26を構成する第1の磁性層29の中央部29bと前記材料層との間で交換結合磁界は生じていない。それは前記材料層は膜厚が薄いため磁場中熱処理を施しても不規則格子のままで規則格子に変態できないからである。

【0128】

図10に示すように、前記下部シールド層20の突出部20a上に形成されたシード層22上から前記第1反強磁性層30上にかけて第1の磁性層29が形成され、前記第1の磁性層29上に非磁性中間層28を介して第2の磁性層27が形成される。前記第1の磁性層29と第2の磁性層27と非磁性中間層28とで人工フェリ構造の固定磁性層26が形成される。前記第1の磁性層29と第2の磁性層27はハイト方向（図示Y方向）に平行であって互いに反平行状態を保って磁化固定されている。

【0129】

前記固定磁性層26上には非磁性材料層25が形成され、前記非磁性材料層25はトラック幅方向（図示X方向）における中央部25cが突出し、その両側端部25dが凹んだ形状となっている。前記非磁性材料層25の中央部25c上にはフリー磁性層24及びTaなどで形成された保護層46が形成され、前記非磁性材料層25の両側端部25d上から少なくとも前記フリー磁性層24のトラック幅方向における両側端面にかけて永久磁石層41が形成されている。前記永久

磁石層 4 1 の下面は、少なくとも前記固定磁性層 2 6 の上側に位置していることが好ましい。前記永久磁石層 4 1 の下面が、前記固定磁性層 2 6 の表面よりも下側に位置すると、前記固定磁性層 2 6 のトラック幅方向への両側端部を一部削ることになり、これにより前記固定磁性層 2 6 の磁化固定を適切に行うことができなくなるので、前記永久磁石層 4 1 の下面は、少なくとも前記固定磁性層 2 6 の上側に位置していることが必要である。

【0130】

なお図 10 では、少なくとも前記永久磁石層 4 1 と前記非磁性材料層 2 5 の両側端部 2 5 d との間に Cr など形成されたバイアス下地層 4 0 が形成されることが、前記永久磁石層 4 1 の特性（保磁力 H_c や角形比 S ）を向上させることができて好ましい。また前記バイアス下地層 4 0 の下に Ta 層が設けられると、前記バイアス下地層 4 0 の体心立方構造の結晶配向を適正化でき、前記永久磁石層 4 1 の特性（保磁力 H_c や角形比 S ）を向上させることができてさらに好ましい。上記したバイアス下地層や Ta 層が設けられる場合には、これらの層の下面が、少なくとも前記固定磁性層 2 6 の上側に位置していることが必要である。

【0131】

図 10 に示すように前記永久磁石層 4 1 の上には Ta など形成された拡散防止層 4 5 を介して電極層 3 3 が形成される。

【0132】

図 10 に示す磁気検出素子も、図 1 ないし図 8 に示す磁気検出素子と同様に、前記固定磁性層 2 6 が、第 1 の反強磁性層 3 0 と接する側の第 1 の磁性層 2 9 と、前記第 1 の磁性層 2 9 と膜厚方向で対向する第 2 の磁性層 2 7 と、前記第 1 の磁性層 2 9 と第 2 の磁性層 2 7 間に介在する非磁性中間層 2 8 とを有して構成されている。前記第 1 の磁性層 2 9 と第 2 の磁性層 2 7 間には RKKY 相互作用による反平行結合磁界が生じるため、両磁性層 2 7、2 9 の磁化は反平行状態になっている。

【0133】

前記第 1 の反強磁性層 3 0 は、前記第 1 の磁性層 2 9 の両側端部 2 9 a 下に厚い膜厚で形成されている。このため交換結合磁界は前記第 1 の磁性層 2 9 の両側

端部 29 a との間で生じ、前記第 1 の磁性層 29 及び第 2 の磁性層 27 の両側端部 29 a、27 a の磁化は前記交換結合磁界と RKKY 相互作用等により反平行状態を保ちながらハイト方向（図示 Y 方向）と平行な方向に固定されている。

【0134】

一方、前記固定磁性層 26 の中央部における第 1 の磁性層 29 の下には前記第 1 の反強磁性層 30 が形成されておらず、よって前記第 1 の磁性層 29 の中央部 29 b には交換結合磁界は生じていないが、前記第 1 の磁性層 29 及び第 2 の磁性層 27 の中央部 29 b、27 b では各磁性層内部の交換相互作用により媒介されたバイアス磁界や上記した RKKY 相互作用によって反平行状態を保ってハイト方向（図示 Y 方向）と平行な方向に固定されている。したがって図 10 に示す実施の形態であれば、前記固定磁性層 26 の磁化固定を適切に行うことが可能である。

【0135】

図 10 に示す構造の磁気検出素子であれば、前記第 1 の磁性層 29 の中央部 29 b の下に第 1 の反強磁性層 30 b が無く、あっても前記第 1 の反強磁性層 30 と同じ組成の材料層が 50 Å よりも薄い膜厚で形成されるので、前記電極層 33 から主に非磁性材料層 25 を中心として流れるセンス電流が、前記第 1 の反強磁性層 30 に分流することが少なくなり、分流ロスを軽減できる結果、再生出力の向上を図ることが可能である。

【0136】

また前記第 1 の磁性層 29 の中央部 29 b の下に前記第 1 の反強磁性層 30 と同じ組成の材料層を設けないか、あるいは設けても 50 Å よりも薄い膜厚とすることで、素子中央部でのシールド層 20、36 の間隔は狭まり、いわゆる狭ギャップ化を図ることが可能である。

【0137】

さらに前記第 1 の磁性層 29 の中央部 29 b の下に前記第 1 の反強磁性層 30 と同じ組成の材料層を設けないか、あるいは設けても 50 Å よりも薄い膜厚とすることで、前記固定磁性層 26 の素子中央部での磁気的な静電破壊（soft ESD）は起こりにくくなる。

【0138】

このように、図10に示す磁気検出素子の構造では、固定磁性層26の磁化を適切にハイト方向に磁化固定できるとともに、再生出力の向上や狭ギャップ化等も図ることができ、今後の更なる高記録密度化に適切に対応可能な磁気検出素子を提供することができる。

【0139】

また図10に示す磁気検出素子では、前記永久磁石層41間に設けられたフリー磁性層24のトラック幅方向における最小幅寸法が W_f3 である（図10の実施形態では前記最小幅寸法 W_f3 はトラック幅 T_w と同じ寸法である）。

【0140】

また前記第1の反強磁性層30間に形成された間隔Cはトラック幅方向に最小寸法 W_P で形成される。

【0141】

そして図10に示す実施の形態では、前記最小幅寸法 W_f3 は最小寸法 W_P と同じかあるいはそれよりも小さくなっている。このように最小幅寸法 W_f3 を最小寸法 W_P と同じかあるいはそれよりも小さくすることで、フリー磁性層24は確実にシールド層20、36の膜厚方向への間隔（いわゆるギャップ長）が最も狭い間に位置し、再生パルス幅（ $PW50$ ）の広がりや分解能の低下を抑制できる。

【0142】

図10に示す実施の形態では、前記永久磁石層41の上に上部ギャップ層35を介して電極層33が設けられ、前記電極層33から、固定磁性層26、非磁性材料層25及びフリー磁性層24等で構成される多層膜へ向けて流れるセンス電流は各層を膜面と平行な方向（図示X方向）に流れる。このとき前記センス電流を流すことによって形成されるセンス電流磁界の向きは、前記固定磁性層26を構成する第1の磁性層29と第2の磁性層27との合成磁気モーメントの向きと一致していることが前記固定磁性層26の磁化固定をさらに強固なものにできて好ましい。前記合成磁気モーメントの向きとセンス電流磁界の向きとの一致のさせ方については図13及び図14で説明したのでそちらを参照されたい。

【0143】

また前記固定磁性層 26 の単位面積当たりの合成磁気モーメントの好ましい範囲等については図 1 で説明した通りなのでそちらを参照されたい。但し図 10 の場合は、後述の製造方法で説明する第 2 の磁場中アニールを行う必要が無いため、スピンプロップ磁界を特に大きくする必要が無く、合成磁気モーメントを $0\text{ T} \cdot \text{nm}$ より大きくしなくてもよい。

【0144】

図 11 は、本発明における第 10 の実施形態の磁気検出素子（スピバルブ型薄膜素子）の構造を記録媒体との対向面側から見た部分断面図である。図 11 に示す磁気検出素子は図 10 と同様にフリー磁性層 24 が第 1 の反強磁性層 30 よりも上側に形成されるタイプである。なお図 10 と同じ符号が付けられている層は図 10 と同じ層であるので、説明を省略する。

【0145】

図 11 に示す磁気検出素子では、図 10 の磁気検出素子と下部シールド層 20 から固定磁性層 26 までの構成が同じである。

【0146】

前記固定磁性層 26 上にはトラック幅方向にほぼ均一な膜厚の非磁性材料層 25 が形成され、さらに前記非磁性材料層 25 の上にフリー磁性層 24 が形成されている。

【0147】

図 11 に示すように前記フリー磁性層 24 上には非磁性中間層 52 が形成され、前記フリー磁性層 24 のトラック幅方向（図示 X 方向）における両側端部 24a 上に前記非磁性中間層 52 を介して強磁性層 48 が形成され、前記強磁性層 48 間のトラック幅方向（図示 X 方向）における間隔よりも広い間隔を有する第 2 反強磁性層 23 が前記強磁性層 48 上に形成されている。また前記第 2 の反強磁性層 23 上には、Cr など形成されたストッパ層 53、Ta など形成された保護層 49、Cr など形成されたストッパ層 50 及び Ta など形成された保護層 51 が形成されている。

【0148】

厚い膜厚で形成された前記第2の反強磁性層23と膜厚方向（図示Z方向）で重なる前記強磁性層48は前記第2の反強磁性層23との間で発生する交換結合磁界によってトラック幅方向（図示X方向）に強固に磁化固定される。またこの磁化固定された強磁性層48と膜厚方向で対向する領域のフリー磁性層24は、前記強磁性層48との間で発生するRKKY相互作用による交換結合によって前記強磁性層48とは反対方向に磁化固定される。

【0149】

一方、前記第2反強磁性層23の内側端面23bよりも前記トラック幅方向（図示X方向）の中心方向に延出する領域の強磁性層48及びその強磁性層48と膜厚方向（図示Z方向）で対向する領域のフリー磁性層24には、前記強磁性層48内部及びフリー磁性層24内部の交換相互作用により媒介されたバイアス磁界の他に、強磁性層48とフリー磁性層24との間で生じるRKKY相互作用による交換結合も作用し、これによって前記第2の反強磁性層23の内側端面23bよりも前記トラック幅方向（図示X方向）の中心方向に延出する領域の強磁性層48及びフリー磁性層24の感度はより鈍化し、この領域での感度をゼロにすることもできる。

【0150】

また前記フリー磁性層24のトラック幅方向における中央部24bには、膜厚方向に非磁性中間層52を介して強磁性層48は形成されていない。したがって前記フリー磁性層24の中央部24bには、磁性層内部の交換相互作用により媒介されたバイアス磁界のみが働き、第2の反強磁性層23との間でのRKKY相互作用による交換結合は働かないから、前記フリー磁性層24の中央部24bは外部磁界に対し感度良く磁化反転できる程度に弱く単磁区化された状態となっている。

【0151】

また、前記フリー磁性層24と前記強磁性層48との単位面積当たりの合成磁気モーメント（ $N_{et} \quad M_{st}$ ）は、 $0 \text{ T} \cdot \text{nm}$ より大きく $2.6 \text{ T} \cdot \text{nm}$ 以下であることが好ましい。前記 $N_{et} \quad M_{st}$ を上記した範囲内に設定することで、前記フリー磁性層24と強磁性層48とが膜厚方向で重なる部分の再生感度を

適切に低減させることができ、具体的には感度 $\{\Delta v (\pm 1000 \text{ Oe}) / \Delta V (\pm 4000 \text{ Oe})\}$ を 0.2 以下に抑えることができる。

【0152】

また N_{et} M_{st} をプラス側、すなわちフリー磁性層の単位面積当たりの磁気モーメントを前記強磁性層の単位面積当たりの磁気モーメントよりも大きくする理由は、再生波形の安定性を向上させると共に、フリー磁性層 24 の磁化方向を制御するための磁場中アニール工程を容易に行うことができるようにするためである。

【0153】

また本発明では、前記フリー磁性層 24 の膜厚 (t) から前記強磁性層 48 の膜厚 (t) を引いた膜厚差は、0 Å 以上で 30 Å 以下であることが好ましい。前記膜厚差を上記した範囲内に設定することで、前記フリー磁性層 24 と強磁性層 48 とが膜厚方向で重なる部分の再生感度を適切に低減させることができ、具体的には感度 $\{\Delta v (\pm 1000 \text{ Oe}) / \Delta V (\pm 4000 \text{ Oe})\}$ を 0.2 以下に抑えることができる。またフリー磁性層 24 の膜厚を強磁性層 48 の膜厚より厚くすると、上記した N_{et} M_{st} をプラス側にする効果と同じ効果を得ることができる。

【0154】

なお図 10 で説明した最小幅寸法 W_{f3} は、図 11 では前記強磁性層 48 間のトラック幅方向における間隔の最小幅寸法 W_{f4} であり、前記最小幅寸法 W_{f4} は最小寸法 W_P と同じかあるいはそれよりも小さくすることで、フリー磁性層 24 の中央部 24b をシールド層 20、36 の膜厚方向への間隔（いわゆるギャップ長）が最も狭い間に位置させることができ、再生パルス幅 (PW_{50}) の広がりや分解能の低下を抑制できる。

【0155】

図 12 は、本発明における第 11 の実施形態の磁気検出素子（スピンバルブ型薄膜素子）の構造を記録媒体との対向面側から見た部分断面図である。図 12 に示す磁気検出素子は図 10 及び図 11 と同様にフリー磁性層 24 が第 1 の反強磁性層 30 よりも上側に形成されるタイプである。なお図 10 及び図 11 と同じ符

号が付けられている層は図 10 及び図 11 と同じ層であるので、説明を省略する。

【0156】

図 12 では前記下部シールド層 20 上に下部ギャップ層 21 及びシード層 22 が形成され、前記シード層 22 の表面は平らである。この平らな表面上に前記第 1 の反強磁性層 30 が形成され、前記第 1 の反強磁性層 30 はトラック幅方向の両側端部 30c で膜厚が厚くなっている。また前記第 1 の反強磁性層 30 の中央部 30d も非常に薄い、具体的には 50 \AA よりも薄い膜厚で残されているが、前記第 1 の反強磁性層 30 の中央部 30d は形成されない方が好ましい。

【0157】

前記第 1 の反強磁性層 30 が平らな表面上に形成され、前記第 1 の反強磁性層 30 の両側端部での膜厚が厚く形成されるので、磁気検出素子の両側端部は盛り上がり、素子の中央部が凹んだ形状となる。図 12 では前記フリー磁性層 24 の磁化制御層として強磁性層 48 と第 2 の反強磁性層 23 を使用している。これら層の形状等については図 11 で説明したのでそちらを参照されたい。

【0158】

また図 12 の構造の磁気検出素子でも図 10 と同じ効果を得ることができ、すなわち固定磁性層 26 の磁化を適切にハイト方向に磁化固定できるとともに、再生出力の向上や狭ギャップ化等も図ることができ、今後の更なる高記録密度化に適切に対応可能な磁気検出素子を提供することができる。

【0159】

図 15 は、本発明における第 12 の実施形態の磁気検出素子（スピバルブ型薄膜素子）の構造を記録媒体との対向面側から見た部分断面図である。

【0160】

図 15 はデュアルスピバルブ型薄膜素子と呼ばれる構造である。図 1 ないし図 12 に示す磁気検出素子は、すべてフリー磁性層 24 と固定磁性層 26 とが一層ずつ設けられていたが、図 15 では、フリー磁性層 24 が一層で固定磁性層 26、64 が 2 層設けられており、前者をシングルスピバルブ型薄膜素子と後者をデュアルスピバルブ型薄膜素子と呼ぶ。デュアルスピバルブ型薄膜素子の

構造の方がシングルスピンバルブ型薄膜素子よりも抵抗変化率を大きくしやすいといった効果はあるが、一方、ギャップ長が広がったりするなどのデメリットもある。

【0161】

図15は、図7と磁気検出素子の構造が似ており、いわば図7に示す磁気検出素子をデュアルスピンバルブ型薄膜素子の形にしたのが図15である。

【0162】

すなわち図15では、シード層22上に第3の反強磁性層60が設けられ、この上に下側の固定磁性層64が設けられる。前記固定磁性層64は第1の磁性層61と前記第1の磁性層61に膜厚方向で対向する第2の磁性層63と両磁性層61、63間に介在する非磁性中間層62との3層で形成された人工フェリ構造である。

【0163】

前記下側の固定磁性層64上には非磁性材料層65を介してフリー磁性層24が形成されており、前記非磁性材料層65上の膜構成及び形状は図7と同じである。

【0164】

図15では、前記シード層22から上側の固定磁性層26を構成する非磁性中間層28までの各層のトラック幅方向（図示X方向）の両側に、下からバイアス下地層40、永久磁石層41、保護層42及びシード層22が積層された素子両側領域Bが形成されている。

【0165】

図16は、本発明における第13の実施形態の磁気検出素子（スピンバルブ型薄膜素子）の構造を記録媒体との対向面側から見た部分断面図であり、図15と同様にデュアルスピンバルブ型薄膜素子の構造である。

【0166】

図16に示す磁気検出素子は、図10と磁気検出素子の構造が似ており、いわば図10に示す磁気検出素子をデュアルスピンバルブ型薄膜素子の形にしたのが図16である。

【0167】

図16では、下部シールド層20から前記非磁性材料層25までの構造は図10と同じであり、前記非磁性材料層25のトラック幅方向（図示X方向）の中央部からフリー磁性層24、非磁性材料層65、第1の磁性層61と第2の磁性層63と両磁性層61、63間に介在する非磁性中間層62との3層の人工フェリ構造で形成された固定磁性層64、第3の反強磁性層60及びTaなどの保護層67が積層形成され、前記フリー磁性層24から前記保護層67までのトラック幅方向の両側に下からTaなどで形成された下地層66、バイアス下地層40、永久磁石層41、拡散防止層45及び電極層33が形成されている。

【0168】

図15及び図16に示すように、フリー磁性層24よりも上側あるいは下側のどちらかに形成された固定磁性層26と第1の反強磁性層30との交換結合膜が図1ないし図12に示すシングルスピンバルブ型薄膜素子の前記交換結合膜と同じ構造で、すなわち前記固定磁性層26は人工フェリ構造で、少なくとも前記第1の反強磁性層30は前記固定磁性層26のトラック幅方向における両側端部と膜厚方向で接する位置に設けられ、前記第1の反強磁性層30との間で発生する交換結合磁界は前記固定磁性層26を構成する第1の磁性層29の両側端部との間でのみ生じている。

【0169】

よってデュアルスピンバルブ型薄膜素子の構造を図15あるいは図16に示す構造とすることで、固定磁性層26の磁化を適切にハイト方向に磁化固定できるとともに、再生出力の向上や狭ギャップ化等も図ることができ、今後の更なる高記録密度化に適切に対応可能な磁気検出素子を提供することができる。

【0170】

また図15及び図16では、もう一方の固定磁性層64と膜厚方向から接する第3の反強磁性層60は前記固定磁性層64の上面あるいは下面の全面に設けられているが、前記第1の反強磁性層30と同様に、少なくとも前記第3の反強磁性層60を前記固定磁性層64のトラック幅方向における両側端部と膜厚方向で接する位置に設け、前記第3の反強磁性層60との間で発生する交換結合磁界を

前記固定磁性層 64 を構成する第 1 の磁性層 61 の両側端部との間でのみ生じるものとすれば、さらに再生出力の向上や狭ギャップ化等も図ることができ、今後の更なる高記録密度化に適切に対応可能な磁気検出素子を提供することができる。

【0171】

図 17 は、本発明における第 14 の実施形態の磁気検出素子（スピンバルブ型薄膜素子）の構造を記録媒体との対向面側から見た部分断面図である。

【0172】

図 1 ないし図 16 に示す磁気検出素子は、前記電極層 33 からのセンス電流が、固定磁性層 26、非磁性材料層 25 及びフリー磁性層 24 等で構成される多層膜の各膜面に対しほぼ平行な方向に流れる CIP (current in the plane) 型となっているが、図 1 ないし図 16 に示す磁気検出素子の構成を、前記センス電流が前記多層膜の各層を膜厚方向に流れる CPP (current perpendicular to the plane) 型の磁気検出素子にも適用可能である。

【0173】

図 17 は図 1 に示す磁気検出素子を CPP 型とした実施形態である。なお図 1 と同じ符号が付けられている層は図 1 と同じ層を示している。

【0174】

図 17 に示す実施形態では、下部シールド層 20 はシールド層とともに下部電極層としても機能する。前記下部シールド層 20 に絶縁材料のギャップ層を設け無い方が素子の寄生抵抗を低減できる点で好ましく、前記下部シールド層 20 上にはシールド層 22 が設けられ、このシールド層 22 が下部ギャップ層として機能する。

【0175】

図 17 では図 1 の電極層 33 であった部分が絶縁層 70 となり、Ta などの非磁性材料で形成された保護層 71 が前記絶縁層 70 上から、前記第 1 の反強磁性層 30 間の間隔 C 内から露出する第 1 の磁性層 29 上にかけて形成され、前記保護層 71 上に上部シールド層 36 が形成される。前記保護層 71 が上部ギャップ層として機能し、前記上部シールド層 36 がシールド層とともに上部電極層とし

ても機能している。

【0176】

なお図17に示す前記非磁性材料層25は、例えばCuで形成されているが、スピントンネル効果の原理を用いたトンネル型磁気抵抗効果素子（TMR素子）の場合、前記非磁性材料層25は、例えば Al_2O_3 等の絶縁材料で形成される。

【0177】

図17のようなCPP型の磁気検出素子としても図1と同様に、固定磁性層26の磁化を適切にハイト方向に磁化固定できるとともに、狭ギャップ化等を図ることができ、今後の更なる高記録密度化に適切に対応可能な磁気検出素子を提供することができる。

【0178】

図18ないし図22は図1に示す磁気検出素子の製造方法を示す一工程図である。図18ないし図22に示す各工程は記録媒体との対向面側から見た部分断面図である。

【0179】

図18に示す工程では、まず下部シールド層20、下部ギャップ層21、シールド層22、第2の反強磁性層23、フリー磁性層24、非磁性材料層25、第1の磁性層29と第2の磁性層27と両磁性層27、29間に介在する非磁性中間層28との3層で構成された人工フェリ構造の固定磁性層26を図18の形状で形成した後、前記第1の磁性層29の上に薄い膜厚の第1の反強磁性層と同じ組成の材料層30eを成膜し、さらに前記材料層30eの上にRuやCrなどで形成された非磁性層80を成膜する。前記非磁性層80は前記材料層30eを酸化から防止するための保護層である。

【0180】

前記材料層30eの膜厚は50 Åよりも薄い膜厚であり、この程度の薄い膜厚であれば、次の工程で磁場中アニールを施しても前記材料層30eは、下地である第1の磁性層29との結合による拘束力によって不規則格子から規則格子に変態できず、このため反強磁性を有さず、前記第1の磁性層29間に交換結合磁界

は生じない。つまり前記材料層 30 e は不規則結晶構造のままである。

【0181】

図 18 に示す形状の積層膜を成膜後、1 回目の磁場中アニールを施す。トラック幅 T_w (図示 X 方向) と平行な方向である第 1 の磁界 (図示 X 方向) を印加しつつ、第 1 の熱処理温度で熱処理し、第 2 の反強磁性層 23 とフリー磁性層 24 の両側端部 24 a 間に交換結合磁界を発生させて、前記フリー磁性層 24 の両側端部 24 a の磁化を図示 X 方向に固定する。

【0182】

前記フリー磁性層 24 の中央部 24 b の下には非常に膜厚の薄い、具体的には 50 \AA よりも薄い膜厚で形成された第 2 の反強磁性層 23 と組成の材料層が存在するが、膜厚が薄いために前記フリー磁性層 24 の中央部 24 b と第 2 の反強磁性層 23 間には前記交換結合磁界は発生せず、前記フリー磁性層 24 の中央部 24 b は外部磁界に対し磁化反転できる程度に弱く単磁区化された状態になっている。

【0183】

また上記したように 1 回目の磁場中アニールを施しても反強磁性層と同じ組成の材料層 30 e と第 1 の磁性層 29 間にも前記交換結合磁界は生じていない。

【0184】

次に図 19 に示す工程では、前記非磁性層 80 を低エネルギーのイオンビームエッチングで除去する。ここで「低エネルギーのイオンビームエッチング」とは、ビーム電圧 (加速電圧) が 1000 V 未満のイオンビームを用いたイオンミリングであると定義される。例えば、 $100 \text{ V} \sim 500 \text{ V}$ のビーム電圧が用いられる。本実施の形態では、 200 V の低ビーム電圧のアルゴン (Ar) イオンビームを用いている。「低エネルギーのイオンビームエッチング」の定義は以下においても同じである。

【0185】

次に図 20 に示す工程では、前記非磁性層 80 を除去したことで露出した第 1 の反強磁性層と同じ組成の材料層 30 e 上に重ねて反強磁性層と同じ組成でしかも前記材料層 30 e よりも厚い膜厚の上側反強磁性層 30 f を成膜し、前記材料

層 3 0 e、及び上側反強磁性層 3 0 f の 2 層が一体化して第 1 の反強磁性層 3 0 が構成される。なお前記上側反強磁性層 3 0 f を成膜する際には、トータルで前記第 1 の反強磁性層 3 0 の膜厚が $80 \text{ \AA} \sim 300 \text{ \AA}$ の範囲内になるように前記上側反強磁性層 3 0 f の膜厚を調整する。また前記材料層 3 0 e 及び上側反強磁性層 3 0 f の界面 3 0 g に非磁性層 8 0 の一部が残されていても、前記材料層 3 0 e 及び上側反強磁性層 3 0 f が反強磁性結合して一体の反強磁性層として機能していればよい。

【0 1 8 6】

図 2 0 に示すように前記第 1 の上側反強磁性層 3 0 f 上には Cr など形成されたストッパ層 3 1 を成膜し、さらに前記ストッパ層 3 1 上に Ta など形成された保護層 3 2 を成膜し、前記保護層 3 2 の上に Au など形成された電極層 3 3 を成膜し、前記電極層 3 3 の上に Ta など形成された保護層 3 4 を成膜する。

【0 1 8 7】

次に図 2 1 に示す工程では、前記保護層 3 4 のトラック幅方向（図示 X 方向）の両側端部に、マスク層 8 1 を設ける。前記マスク層 8 1 はメタル層であってもよいし、レジスト層であってもよい。

【0 1 8 8】

図 2 1 に示すように前記マスク層 8 1 のトラック幅方向に形成された所定の間隔 8 1 a 内から露出する保護層 3 4、電極層 3 3 及び保護層 3 2 をリアクティブ・イオン・エッチング（RIE）で除去する。エッチングガスとして、 CF_4 や C_3F_8 あるいは Ar と CF_4 の混合ガス、または C_3F_8 と Ar との混合ガスを使用する。そうすると図 2 1 に示すように前記電極層 3 3 は磁気検出素子のトラック幅方向における両側端部にのみ残され、前記電極層 3 3 間に間隔 C が形成される。前記 RIE 工程はストッパ層 3 1 が前記間隔 C 内から露出すると終了される。

【0 1 8 9】

図 2 2 に示す工程では、間隔 C 内に露出するストッパ層 3 1、第 1 の反強磁性層 3 0 をイオンミリングで除去する。このイオンミリング時の削り込み量は S I

MS分析計によって制御することが可能である。前記間隔C内から第1の磁性層29が露出した瞬間にイオンミリングを止める。なおこのイオンミリング工程でマスク層81も削られる。

【0190】

図22まで工程を施した後、図1に示す上部ギャップ層35や上部シールド層36を成膜し、さらに第2の磁場中アニールを施す。このときの磁場方向は、トラック幅方向と直交する方向（図示Y方向）である。なおこの第2の磁場中アニールは、第2の印加磁界を、第2の反強磁性層23の交換異方性磁界よりも小さく、また第1の磁性層29及び第2の磁性層27のスピンフロップ磁界よりも小さく、さらに前記第1の磁性層29及び第2の磁性層27の保磁力や異方性磁界よりも大きい値とする。なお前記第2の磁性層27の単位面積当たりの磁気モーメントを前記第1の磁性層29の単位面積当たりの磁気モーメントよりも大きくすると前記スピンフロップ磁界を大きくできるので、印加磁場のマージンを広くとることができ、製造工程を容易化できて好ましい。

【0191】

また熱処理温度を、前記第2の反強磁性層23のブロッキング温度よりも低くする。これによって、前記第2の反強磁性層23と第1の反強磁性層30を共に、上記したPtMn合金やPtMnX合金等で形成しても、前記第2の反強磁性層23の交換異方性磁界の方向をトラック幅方向（図示X方向）に向けたまま、前記第1の反強磁性層30の交換異方性磁界をハイト方向（図示Y方向）に向けることができる。なお前記第1の反強磁性層30に、前記第2の反強磁性層23よりもブロッキング温度の低いIrMn合金などを使用してもよい。

【0192】

上記の第2の磁場中アニールによって、前記第1の反強磁性層30は適切に規則化変態し、前記第1の反強磁性層30と第1の磁性層29の両側端部29a間に適切な大きさの交換結合磁界が発生し、これによって前記第1の磁性層29の両側端部29aの磁化は、トラック幅方向と直交する方向（図示Y方向）に固定される。

【0193】

また前記第1の磁性層29と第2の磁性層27間にはRKKY相互作用による反平行結合磁界が生じるため、前記第2の磁性層27は前記第1の磁性層29とは反平行状態で磁化固定される。また前記第1の磁性層29と第2の磁性層27の中央部29b、27bの磁化は、前記RKKY相互作用による反平行結合磁界と各磁性層内部の交換相互作用により媒介されたバイアス磁界によって反平行状態を保って固定される。上記した工程を施すことで図1に示す磁気検出素子が完成する。

【0194】

図23ないし図25に示す工程は、図4に示す磁気検出素子の製造方法を示す一工程図である。なお各図は製造工程中の磁気検出素子を記録媒体との対向面側から見た部分断面図である。

【0195】

図23に示す工程では、下部シールド層20上に下部ギャップ層21、シード層22、フリー磁性層24、非磁性材料層25、固定磁性層26を構成する第2の磁性層27の下層部27c及び保護層82を連続して成膜する。

【0196】

前記保護層82をCuなどの非磁性材料で形成し、膜厚を3～10Å程度の薄い膜厚で形成することが好ましい。特に前記保護層82にCuを使用すると、後工程で前記第2の磁性層27の上層部27dを前記下層部27c上に形成したときに前記上層部27dと下層部27c間に若干、前記保護層82が残っても前記上層部27dと下層部27cとで一体の第2の磁性層27として機能させることができる。

【0197】

前記保護層82はその下に形成された前記下層部27cを酸化から保護するための層である。

【0198】

図23に示すように前記保護層82上にリフトオフ用のレジスト層83を形成し、前記レジスト層83に覆われていない、前記シード層22から保護層82までの各層のトラック幅方向（図示X方向）における両側端部をイオンミリングで

削り取り、図 23 のように、前記各層の両側に下から Cr など形成されたバイアス下地層 40、CoPtCr など形成された永久磁石層 41、Ta など形成された保護層 42、NiFeCr など形成されたシード層 22 及び Cr など形成された保護層 84 をこの順で積層する。前記保護層 84 を $3\text{ \AA} \sim 10\text{ \AA}$ 程度の膜厚で形成する。このスパッタ成膜時、前記レジスト層 83 の上面にもバイアス下地材料層 40a、永久磁石材料層 41a、保護材料層 42a、シード材料層 22a 及び非磁性材料層 84a が付着する。

【0199】

次に図 24 に示す工程では前記レジスト層 83 を除去した後、前記第 1 の磁性層 27 の下層部 27c 上に形成された保護層 82 及びシード層 22 上に形成された保護層 84 を低エネルギーのイオンビームエッチングで削り取る。これにより前記下層部 27c 及びシード層 22 が露出する。

【0200】

次に図 25 に示す工程では、前記下層部 27c 及びシード層 22 上に第 2 の磁性層 27 の上層部 27d を成膜し、前記下層部 27c と上層部 27d とが一体化した第 2 の磁性層 27 を形成し、さらに前記第 2 の磁性層 27 上に非磁性中間層 28、第 1 の磁性層 29、第 1 の反強磁性層 30、ストッパ層 31、保護層 32、電極層 33 及び保護層 34 を成膜する。次に図 21 及び図 22 と同様の工程を施すと、図 4 に示す磁気検出素子が完成する。なお図 4 に示す磁気検出素子には反強磁性層は図 1 と異なって 1 層しかないので、前記第 1 の反強磁性層 30 に対して磁場中アニールを施すときの印加磁場及びアニール温度は図 22 工程で説明した第 2 の磁場中アニールのように厳しい制限はなく、このため第 2 の磁性層 27 の単位面積当たりの磁気モーメントと第 1 の磁性層 29 の単位面積当たりの磁気モーメントはどちらが大きくても製造工程の適正化及び容易性に影響を及ぼさず、また前記永久磁石層 41 の着磁はスライダー加工後またはヘッド (HGA) 組立後に行えばよい。

【0201】

上記は図 4 の磁気検出素子の製造方法であったが、図 3、図 5 ないし図 8 に示す各磁気検出素子も図 23 ないし図 25 に示す工程を利用することで製造するこ

とができる。

【0202】

図26ないし図29は図10に示す磁気検出素子の製造方法を示す一工程図である。各図は製造工程中の磁気検出素子を記録媒体との対向面側から見た部分断面図である。

【0203】

図26に示す工程では、下部シールド層20上に下部ギャップ層21、シード層22及びCrやRuなどで形成された非磁性層85を成膜した後、前記非磁性層85の上にリフトオフ用のレジスト層87を形成する。

【0204】

次に前記レジスト層87に覆われていない前記非磁性層85、シード層22、下部ギャップ層21及び下部シールド層20の一部をイオンミリングで削りこみ、前記下部シールド層20のトラック幅方向（図示X方向）における両側端部に凹み部20bを形成する。そしてこの凹み部20b内に下から下部ギャップ層21、シード層22、第1の反強磁性層30及びRuなどで形成された非磁性層86を成膜する。このとき前記レジスト層87の上面にも前記ギャップ材料層21a、シード材料層22a、反強磁性材料層30及び非磁性材料層86aが付着する。

【0205】

次に図27に示す工程では前記レジスト層87を除去した後、低エネルギーのイオンビームエッチングで前記非磁性層85、86を除去する。これによって前記下部シールド層20の中央部上からシード層22の表面及び前記下部シールド層20の両側端部上から第1の反強磁性層30の表面が露出する。

【0206】

次に図28に示す工程では、前工程で露出した前記第1の反強磁性層30上及びシード層22上に薄い膜厚、具体的には50Åよりも薄い反強磁性層と同じ組成の材料層30fを成膜した後、その上に第1の磁性層29、非磁性中間層28、第2の磁性層27、非磁性材料層25、フリー磁性層24及び保護層46を成膜する。

【0207】

前記第1の反強磁性層30及びシード層22上に50 Åよりも薄い反強磁性層と同じ組成の材料層30fを成膜し連続して第1の磁性層29を成膜すると、磁場中アニールによって素子の両側端部に設けられた膜厚の厚い第1の反強磁性層30と一体化した材料層30fは不規則格子から少なくとも一部が規則格子に変態して、前記第1の磁性層29の両側端部との間で交換結合磁界が生じ、前記素子の中央部では前記材料層30fの膜厚が非常に薄いので、前記材料層30fは不規則格子から規則格子に変態できず、前記第1の磁性層29の中央部との間では前記交換結合磁界は生じないようにしている。

【0208】

図29工程では前記保護層46の上にリフトオフ用のレジスト層88を形成し、前記レジスト層88に覆われていない前記保護層46、フリー磁性層24及び非磁性材料層25の一部をイオンミリングで除去する。このように前記非磁性材料層25の両側端部25dが一部でも残されるようにしておくことで、前記イオンミリングから前記固定磁性層26を保護することができる。

【0209】

次に前記非磁性材料層25上にCrなどで形成されたバイアス下地層40を形成し、さらに前記バイアス下地層40上に永久磁石層41を形成し、前記永久磁石層41上に拡散防止層45を形成し、さらに前記拡散防止層45の上に電極層33を成膜する。なお前記非磁性材料層25とバイアス下地層40との間にTaなどで形成された下地層を敷く方が、前記バイアス下地層の結晶配向を適正化でき、前記永久磁石層41の特性（保磁力H_cや角形比）を向上させることができて好ましい。

【0210】

また上記の成膜によって、前記レジスト層88の上面にもバイアス下地材料層40a、永久磁石材料層41a、拡散防止材料層45a及び電極材料層33aが付着する。その後、前記レジスト層88を除去し、前記永久磁石層41のトラック幅方向（図示X方向）への着磁を行う。以上の工程を施すことで図10に示す磁気検出素子を製造することができる。

【 0 2 1 1 】

なお上記した製造方法では、図 1 0 と異なり、若干、前記下部シールド層 2 0 の突出部 2 0 a 上に一部、材料層 3 0 f が残ってしまうが、前記材料層 3 0 f が残らないようにする製造方法もあるのでそれについては後述する。

【 0 2 1 2 】

図 3 0 ないし図 3 3 に示す工程は図 1 1 に示す磁気検出素子の製造方法を示す一工程図である。各図は製造工程中の磁気検出素子を記録媒体との対向面側から見た部分断面図である。

【 0 2 1 3 】

図 3 0 に示す工程ではまず図 2 6 及び図 2 7 と同じ工程を施して第 1 の反強磁性層 3 0 までを成膜した後、前記第 1 の反強磁性層 3 0 上に、膜厚が 50 \AA よりも薄い反強磁性層と同じ組成の材料層 3 0 f、人工フェリ構造の固定磁性層 2 6、非磁性材料層 2 5、フリー磁性層 2 4、非磁性中間層 5 2、強磁性層 4 8、反強磁性層と同じ組成の材料層 2 3 c (50 \AA よりも薄い) 及び非磁性層 9 2 を連続して成膜し、磁場中アニールで前記第 1 の反強磁性層 3 0 と第 1 の磁性層 2 9 の両側端部 2 9 a 間に交換結合磁界を生じさせた後、前記非磁性層 9 2 を低エネルギーのイオンミリングで除去し、さらに前記第 2 の反強磁性層 2 3 の下層部 2 3 c 上に前記第 2 の反強磁性層 2 3 の上層部を積層し、前記下層部 2 3 c と上層部とで一体化された第 2 の反強磁性層 2 3 を形成した後、前記第 2 の反強磁性層 2 3 の上にストッパ層 5 3 及び保護層 4 9 を成膜する。

【 0 2 1 4 】

図 3 1 に示す工程では前記保護層 4 9 上にトラック幅方向に所定の間隔 9 3 a が空けられたマスク層 9 3 を形成し、前記マスク層 9 3 間に空けられた間隔 9 3 a 下に露出する保護層 4 9 を R I E で除去してストッパ層 5 3 が露出したら、今後はイオンミリングで前記ストッパ層 5 3 及び第 2 の反強磁性層 2 3 を削り込み、この工程で前記マスク層 9 3 も除去される。

【 0 2 1 5 】

なお前記間隔 9 3 a 内には若干、前記第 2 の反強磁性層 2 3 と同じ組成の材料層 2 3 d が残されているが、 50 \AA よりも薄い膜厚なら残されていてもよい。

【0216】

次に図32の工程では、前記保護層49上から第2の反強磁性層23の中央部23d上にかけてCrなどで形成されたストッパ層50を形成し、さらに前記ストッパ層50上にTaなどの保護層51を形成し、前記保護層51の上にAuなどで形成された電極層33を形成し、前記電極層33の上にTaなどで形成された保護層34を形成する。

【0217】

次に図33に示す工程では、前記保護層34上にトラック幅方向（図示X方向）に所定の間隔Cが開けられたマスク層100を形成する。このマスク層100間に開けられた間隔Cのトラック幅方向への中心が素子のトラック幅方向への中心と一致するように、前記マスク層100をアライメント形成する。またこの工程では前記マスク層100を反応性イオンエッチング（RIE）で削られない、あるいは削られ難い材質で形成する。前記マスク層100をレジストによるリフトオフ等を利用してメタル層で形成しており、例えば前記マスク層100をCr層で形成している。前記マスク層100をメタル層で形成する場合、前記マスク層100を100Å～500Å程度の膜厚で形成することが好ましい。

【0218】

前記マスク層100のトラック幅方向（図示X方向）に開けられた間隔Cは、前記第2の反強磁性23の内側端面23bの下面間のトラック幅方向における間隔よりも狭くすることが好しい。

【0219】

次に前記マスク層100を形成した後、前記マスク層100に覆われていない保護層34及び電極層33をエッチングで削り取っていく。このエッチングには反応性イオンエッチング（RIE）を使用することが好ましい。エッチングガスとして、CF₄やC₃F₈あるいはArとCF₄の混合ガス、またはC₃F₈とArとの混合ガスを使用する。

【0220】

前記保護層34、電極層33及び保護層51を削り取ってストッパ層50の表面が現れると、ここで一旦エッチング工程を終了し、次に前記マスク層100間

に現れた前記ストッパ層 50 をイオンミリングで削り、さらにその下に残された第 2 反強磁性層 23 を削り、またこの図 33 工程では、その下に現われた強磁性層 48 をすべて除去してイオンミリングを止めている。このイオンミリング時の削り込み量は SIMS 分析計によって制御することが可能である。特にこのイオンミリングは低エネルギーのイオンミリングを使用できる。削り込む層の膜厚が薄いからである。このためミリング制御を向上させることができ、強磁性層 48 をすべて除去した瞬間にミリングを止めることも精度良く行うことができる。

【0221】

なお上記した製造方法では、図 11 と異なり、若干、前記下部シールド層 20 の突出部 20a 上に一部、反強磁性層と同じ組成の材料層 30f が残ってしまうが、前記材料層 30f が残らないようにする製造方法を以下で説明する。

【0222】

図 34 及び図 35 に示す工程は、図 26 及び図 27 に示す工程と異なる工程で前記第 1 の反強磁性層 30 及び固定磁性層 26 を形成するための一工程図であり、各図は製造工程中の磁気検出素子を記録媒体との対向面側から見た部分断面図である。

【0223】

図 34 の工程では、下部シールド層 20、下部ギャップ層 21、シード層 22 及び非磁性層 85 を形成し、前記非磁性層 85 上に図 34 に示すリフトオフ用のレジスト層 89 を形成した後、前記レジスト層 89 に覆われていない前記非磁性層 85、シード層 22、下部ギャップ層 21 及び前記下部シールド層 20 の一部をエッチングで除去し、前記レジスト層 89 よりもトラック幅方向（図示 X 方向）に延出する前記下部シールド層 20 上に下部ギャップ層 21、シード層 22、第 1 の反強磁性層 30、第 1 の磁性層 29 及び非磁性層 90 を成膜する。前記非磁性層 90 を Ru など形成し、前記レジスト層 89 を除去した後、前記非磁性層 85 及び前記非磁性層 90 の一部を除去する。

【0224】

図 35 に示すように前記第 1 の磁性層 29 上には前記非磁性層 90 の一部が残され、素子中央のシード層 22 上から前記非磁性層 90 上にかけて磁性中間層 1

02、非磁性中間層28、第2の磁性層27を形成し、前記第1の磁性層29、磁性中間層102、第2の磁性層27、非磁性中間層28、90の5層で固定磁性層26を形成する。その後の工程は図28以降と同じであり、前記固定磁性層26上に連続して非磁性材料層25、フリー磁性層24・・・を成膜していく。

【0225】

図36及び図37は、図34及び図35に示す工程とは異なる工程で前記第1の反強磁性層30及び固定磁性層26を形成するための一工程図であり、各図は製造工程中の磁気検出素子を記録媒体との対向面側から見た部分断面図である。

【0226】

図36に示す工程では、下部シールド層20、下部ギャップ層21、シード層22、固定磁性層26を構成する第1の磁性層29の下層部29c及び非磁性層85を成膜し、前記非磁性層85の上に図36に示すリフトオフ用のレジスト層89を形成する。前記レジスト層89に覆われていない前記非磁性層85、前記第1の磁性層29の下層部29c、シード層22、下部ギャップ層21及び前記下部シールド層20の一部を除去し、一部残された前記下部シールド層20上に下部ギャップ層21、シード層22、第1の反強磁性層30、第1の磁性層29の下層部29c及び非磁性層91を成膜する。

【0227】

次に前記レジスト層89を除去し、前記非磁性層85、91をイオンミリングで除去した後、図37に示すように、前記非磁性層85、91を除去したことで露出した第1の磁性層29の下層部29c上に前記第1の磁性層29の上層部29dを成膜し、さらに前記上層部29d上に非磁性中間層28及び第2の磁性層27を成膜する。

【0228】

図37に示す点線部は前記下層部29cと上層部29dとの境界線であり、この境界線に前記非磁性層85、91の一部が残されていてもよいが、前記下層部29cと上層部29dとは強磁性結合によって一体の第1の磁性層29となり、前記第1の磁性層29、非磁性中間層28及び第2の磁性層27の3層で固定磁性層26が構成される。その後の工程は図28以降と同じであり、前記固定磁性

層 26 上に連続して非磁性材料層 25、フリー磁性層 24・・・を成膜していく。

【0229】

図 34 ないし図 37 に示す工程を用いると下部シールド層 20 の突出部 20a 上に第 1 の反強磁性層 30 の一部が形成されることなく、前記第 1 の反強磁性層 30 は、前記素子の両側端部にのみ形成される形態を製造することができる。

【0230】

図 38 及び図 39 に示す工程図は、図 12 に示す磁気検出素子の製造工程を示す一工程図であり、各図は製造工程中の磁気検出素子を記録媒体との対向面側から見た部分断面図である。

【0231】

図 38 に示す工程では、下部シールド層 20、下部ギャップ層 21、シード層 22、第 1 の反強磁性層 30 及び Ru など形成された非磁性層 101 を成膜し、さらに前記非磁性層 101 の上にトラック幅方向（図示 X 方向）に間隔 C が空けられた例えばレジストなどのマスク層 94 を形成し、前記マスク層 94 に覆われていない前記非磁性層 101 及び第 1 の反強磁性層 30 をイオンミリングあるいは RIE など除去する。そうすると前記第 1 の反強磁性層 30 にもトラック幅方向（図示 X 方向）に間隔 C が設けられる。

【0232】

次に図 38 に示すように前記マスク層 94 上から前記間隔 C 内にかけて Ru など形成された非磁性層 95 を成膜した後、前記マスク層 94 を剥離し、さらに非磁性層 95、101 を低エネルギーのイオンビームエッチングで除去する。

【0233】

次に図 39 工程に示すように薄い膜厚、具体的には 50 Å よりも薄い膜厚の反強磁性層と同じ組成の材料層 30e を前記第 1 の反強磁性層 30 上から前記間隔 C 内にかけて成膜した後、図 30 工程以降と同様に前記反強磁性層 30 上に連続して人工フェリ構造の固定磁性層 26、非磁性材料層 25、フリー磁性層・・・を成膜していく。

【0234】

なお図15ないし図17に示す磁気検出素子も上記した図18ないし図39工程のいくつかを組み合わせることで製造することが可能である。

【0235】

また図1ないし図39では磁気検出素子で再生を行うMRヘッド部のみの説明であったが、上部シールド層上に書き込み用のインダクティブヘッド部が積層されている薄膜磁気ヘッドであっても本発明を適用できる。

【0236】

また本発明における磁気検出素子はハードディスク装置に内蔵される磁気ヘッドに装備されるほか磁気センサなどにも使用可能である。

【0237】

【実施例】

図40（実施例）及び図43（比較例）に示す構造の磁気検出素子を用いて一方向性交換バイアス磁界 H_{ex}^* 及び再生出力（規格化出力）を求めた。

【0238】

図40（実施例）は、磁気検出素子を記録媒体との対向面側から見た部分断面図の模式図であり、膜構成は、下からシード層： $(Ni_{0.8}Fe_{0.2})_{60}at\%Cr_{40}at\%$ （60Å）／フリー磁性層： $Ni_{80}at\%Fe_{20}at\%$ （35Å）／ $Co_{90}at\%Fe_{10}at\%$ （10Å）／非磁性材料層： Cu （21Å）／固定磁性層：[第2の磁性層： $Co_{90}at\%Fe_{10}at\%$ （XÅ）／非磁性中間層： Ru （9Å）／第1の磁性層： $Co_{90}at\%Fe_{10}at\%$ （YÅ）]／第1の反強磁性層： $Pt_{50}at\%Mn_{50}at\%$ （200Å）の順である。なお括弧書きは膜厚を示している。図40に示すようにフリー磁性層はトラック幅方向に磁化が向けられているが、前記フリー磁性層の磁化を制御するための永久磁石層や第2の反強磁性層は設けられていない。また図40に示すように前記第1の磁性層と第2の磁性層はハイト方向（図示Y方向）に平行な方向で且つ互いに磁化が反平行状態になっている。

【0239】

また図40に示すように第1の反強磁性層間には間隔が空けられ、この間隔内からは固定磁性層を構成する第1の磁性層が露出している。そして前記間隔のト

トラック幅方向（図示X方向）における幅寸法がトラック幅 R_{TW} であり、前記トラック幅 R_{TW} は物理的なトラック幅（Physical Read Track Width）である。

【0240】

上記のように第2の磁性層の膜厚は $X \text{ \AA}$ で、第1の磁性層の膜厚は $Y \text{ \AA}$ であり、これら各磁性層の膜厚を変化させて、トラック幅 R_{TW} と一方向性交換バイアス磁界及び前記トラック幅 R_{TW} と規格化出力との関係について求めた。なお一方向性交換バイアス磁界 H_{ex*} とは、抵抗変化率（ $\Delta R/R$ ）の最大値の半分の値になる時の外部磁界の大きさを前記一方向性交換バイアス磁界（ H_{ex*} ）と定める。一方向交換バイアス磁界には、前記固定磁性層と反強磁性層間で発生する交換結合磁界のほか、前記固定磁性層は人工フェリ構造であるため、前記固定磁性層を構成する $CoFe$ 間で発生する $RKKY$ 交換相互作用における結合磁界などを含む磁界の大きさである。この一方向性交換バイアス磁界が大きいほど前記固定磁性層を所定の方に適切にピン止めすることが可能になる。

【0241】

図41に示すように、トラック幅 R_{TW} が広がるにつれて一方向性交換バイアス磁界は低下する。しかし前記トラック幅 R_{TW} が約 $0.22 \mu m$ 程度でも $100 kA/m$ 程度の高い一方向性交換バイアス磁界を生じている。前記固定磁性層の磁化固定には最低で $80 kA/m$ 程度の一方向性交換バイアス磁界が必要であると考えられることからすると、前記トラック幅 R_{TW} の設定にある程度の自由度があることがわかった。

【0242】

図42は、前記トラック幅 R_{TW} とトラック幅で規格化された再生出力（ $\Delta V/R_{TW}$ ）との関係を示すグラフである。規格化出力は、ハイト方向に $\pm 4000 Oe$ （ $\pm 31 kA/m$ ）の一樣磁界を印加したときの電圧変化量 ΔV をトラック幅 R_{TW} で割ったものである。

【0243】

図42に示すように、トラック幅 R_{TW} が大きくなるにつれて、規格化出力は若干低下する傾向を見せるが、規格化出力は前記トラック幅 R_{TW} が $0.2 \mu m$ を超えても $12 mV/\mu m$ 以上を保っていることがわかる。

【 0 2 4 4 】

図 4 3（比較例）は、磁気検出素子を記録媒体との対向面側から見た部分断面図の模式図であり、膜構成は、図 4 0 の磁気検出素子の膜構成と同じである。図 4 3 に示すようにフリー磁性層はトラック幅方向に磁化が向けられているが、前記フリー磁性層の磁化を制御するための永久磁石層や第 2 の反強磁性層は設けられていない。また図 4 3 に示すように前記第 1 の磁性層と第 2 の磁性層はハイト方向（図示 Y 方向）に平行な方向で且つ互いに磁化が反平行状態になっている。

【 0 2 4 5 】

なお図 4 0 の場合と同様に第 2 の磁性層の膜厚は $X \text{ \AA}$ で、第 1 の磁性層の膜厚は $Y \text{ \AA}$ であり、これら各磁性層の膜厚を変化させて、トラック幅 $R T w$ と一方向性交換バイアス磁界及び前記トラック幅 $R T w$ と規格化出力との関係について求めた。なお図 4 3 に示す磁気検出素子は図 4 0 のように第 1 の反強磁性層にはトラック幅方向（図示 X 方向）に間隔が空けられておらず、前記第 1 の反強磁性層は前記第 1 の磁性層上の全面に設けられている。前記第 1 の反強磁性層の上に設けられた電極層に図 4 3 に示すようにトラック幅方向に間隔が空けられ、前記間隔のトラック幅方向（図示 X 方向）における幅寸法がトラック幅 $R T w$ であり、前記トラック幅 $R T w$ は物理的なトラック幅（Physical Read Track Width）である。

【 0 2 4 6 】

図 4 4 に示すように、トラック幅 $R T w$ が広がっても一方向性交換バイアス磁界の大きさにはさほど大きな変化が見られない。同様に図 4 5 に示すように、規格化出力の大きさもトラック幅 $R T w$ が広がっても変化しない。

【 0 2 4 7 】

本発明の実施形態の磁気検出素子は図 4 0 のように、第 1 の反強磁性層にトラック幅方向に所定の間隔を空けて成るものであるが、まず図 4 1 と図 4 4 に示す一方向性交換バイアス磁界 H_{ex}^* を比べて見ると、実施例の方が比較例に比べて前記一方向性交換バイアス磁界 H_{ex}^* は小さくなる。これは実施例の場合、素子の中央部の前記第 1 の磁性層上に第 1 の反強磁性層が設けられていないため、素子の中央部で交換結合磁界が生じないためであると考えられるが、実施例で

もトラック幅 $R T w$ の大きさを適切に制御すれば前記固定磁性層を適切に磁化固定できるだけの一方向性交換バイアス磁界 $H e x *$ を得ることができることがわかった。

【 0 2 4 8 】

上記したように前記一方向性交換バイアス磁界 $H e x *$ は最低、 80 k A/m 程度以上あれば足りると考えられるので図 4 1 に示すように前記トラック幅 $R T w$ を $0.2 \mu \text{ m}$ 以下にすれば、前記一方向性交換バイアス磁界を 80 k A/m 程度以上得ることが可能であるとわかった。

【 0 2 4 9 】

次に図 4 2 と図 4 5 に示す規格化出力を比べて見ると、実施例の方が比較例に比べて前記規格化出力は大きくなる。これは実施例のように素子の中央部の第 1 の磁性層上に第 1 の反強磁性層を設けないことで、電極層から流れるセンス電流の分流ロスが減るためであると考えられる。

【 0 2 5 0 】

つまり、実施例のように素子の中央部の第 1 の磁性層上に第 1 の反強磁性層を設けない構成とすれば、固定磁性層の第 1 の磁性層と第 2 の磁性層を磁化固定できるだけの十分な一方向性交換バイアス磁界を得ることができると共に、従来に比べて再生出力を大きくすることができることがわかった。

【 0 2 5 1 】

また図 4 1 及び図 4 2 に示すように第 1 の磁性層と第 2 の磁性層の膜厚は、互いに薄く且つ膜厚差が小さい方が、一方向性交換バイアス磁界及び規格化出力を大きくできることがわかった。

【 0 2 5 2 】

次に図 4 0 に示すフリー磁性層下に第 2 の反強磁性層を設けた磁気検出素子を製造した。なおトラック幅 $R T w$ を $0.2 \mu \text{ m}$ 程度とした。

【 0 2 5 3 】

そしてこの磁気検出素子を用い、第 2 の磁性層の単位面積当たりの磁気モーメントから第 1 の磁性層との単位面積当たりの磁気モーメントを引いた単位面積当たりの合成磁気モーメント ($N e t \quad M s t$) とトラック幅方向の磁界に対する

固定磁性層の中央部の磁化回転のしやすさ（感度）との関係、および第2の磁性層の膜厚から第1の磁性層の膜厚を引いた膜厚差とトラック幅方向の磁界に対する固定磁性層の中央部の磁化回転のしやすさ（感度）との関係について調べた。

【0254】

実験では、第1の磁性層及び第2の磁性層の膜厚を変化させ、前記第1の磁性層及び第2の磁性層の単位面積当たりの磁気モーメント（飽和磁化 $M_s \times$ 膜厚 t ）を変化させた。そして外部磁界が $\pm 4000\text{ Oe}$ （ここで $+4000\text{ Oe}$ の外部磁界とは例えばトラック幅方向方向への外部磁界の方向及び強さを指し、 -4000 Oe の外部磁界とはトラック幅方向と逆方向への外部磁界の方向及び強さを指す）時のときの電圧差（ ΔV ）に対する、外部磁界が $\pm 100\text{ Oe}$ （ここで $+100\text{ Oe}$ の外部磁界とは例えばトラック幅方向への外部磁界の方向及び強さを指し、 -100 Oe の外部磁界とはトラック幅方向と逆方向への外部磁界の方向及び強さを指す）時のときの電圧差（ ΔV ）の比率 $\{\Delta V (\pm 100\text{ Oe}) / \Delta V (\pm 4000\text{ Oe})\}$ を求めた。 $\Delta V (\pm 100\text{ Oe}) / \Delta V (\pm 4000\text{ Oe})$ は、弱い磁場で第1の磁性層及び第2の磁性層の磁化がどれくらい回転するかの指標、すなわちトラック幅方向の磁界に対する固定磁性層の感度を示す。なお 4000 Oe は、約 $31.8 \times 10^4 (\text{A/m})$ である。

【0255】

図46が、単位面積当たりの合成磁気モーメントと感度 $\{\Delta V (\pm 100\text{ Oe}) / \Delta V (\pm 4000\text{ Oe})\}$ （以下、単に感度という）との関係を示すグラフである。図46に示すように単位面積当たりの合成磁気モーメントが小さくなるほど、徐々に前記感度が低下していくことがわかる。図46では、単位面積当たりの合成磁気モーメントが $1 (\text{T} \cdot \text{nm})$ 付近で、感度が0になるものと考えられる。また前記単位面積当たりの合成磁気モーメントを $1.5 (\text{T} \cdot \text{nm})$ 以下にすると前記感度を0.2以下に抑えることができるとわかった。

【0256】

この実験では、単位面積当たりの合成磁気モーメントをある範囲内で小さくすれば、効果的に感度を低下させることができるとわかった。

【0257】

図 4 7 は、第 2 の磁性層の膜厚から第 1 の磁性層の膜厚を引いた膜厚差と感度 $\{\Delta V (\pm 1000 \text{ Oe}) / \Delta V (\pm 4000 \text{ Oe})\}$ (以下、単に感度という) との関係を示すグラフであるが、このグラフでも図 4 7 と同様の傾向が見られ、前記膜厚差が小さくなるほど、徐々に前記感度が低下していくことがわかる。図 4 7 では、膜厚差が 5 Å 付近で、前記感度が 0 になるものと考えられる。また前記膜厚差を 10 Å 以下にすれば前記感度を 0.2 以下に抑えることができるとわかった。

【0258】

次に第 2 の磁性層を下から、Co90at%Fe10at%(10 Å) / Ni80at%Fe20at%(30 Å) / Co90at%Fe10at%(6 Å) の 3 層構造で形成した。括弧書きは膜厚を示している。

【0259】

また非磁性中間層には膜厚が 9 Å の Ru を用い、第 1 の磁性層には Co90at%Fe10at% を用い、前記強磁性層の膜厚を変化させることで、単位面積当たりの合成磁気モーメントの大きさ、および第 1 の磁性層と第 2 の磁性層との膜厚差を変化させた。

【0260】

図 4 8 は、第 2 の磁性層の単位面積当たりの磁気モーメントから第 1 の磁性層の単位面積当たりの磁気モーメントを引いて求めた単位面積当たりの合成磁気モーメント (Net Mst) と感度 $\{\Delta V (\pm 1000 \text{ Oe}) / \Delta V (\pm 4000 \text{ Oe})\}$ (以下、単に感度という) との関係を示すグラフである。

【0261】

図 4 8 を見てわかるように前記感度は図 4 6 と同様に前記単位面積当たりの合成磁気モーメントが小さくなっていくほど低下していくことがわかった。また図 4 8 では、2.6 (T・nm) の単位面積当たりの合成磁気モーメントを境として前記感度が急激に変化している。すなわち 2.6 (T・nm) の単位面積当たりの合成磁気モーメントを変曲点として前記感度が大きく変化している。

【0262】

図 4 8 に示すように前記単位面積当たりの合成磁気モーメントが 2.6 (T・

n m) 以下になると前記感度は 0.2 以下になることがわかった。

【0263】

図 49 は、第 2 の磁性層の膜厚から第 1 の磁性層の膜厚を引いた膜厚差と感度 $\{\Delta V (\pm 1000 \text{ Oe}) / \Delta V (\pm 4000 \text{ Oe})\}$ (以下、単に感度という) との関係を示すグラフである。

【0264】

図 49 に示すように前記膜厚差が小さくなるほど図 47 と同様に前記感度は低下していくことがわかった。

【0265】

図 49 に示すように 30 Å の膜厚差を境として前記感度は急激に変化していることがわかった。すなわち 30 Å の膜厚差を変曲点として前記感度が大きく変化することがわかった。図 49 に示すように、前記膜厚差が 30 Å 以下になると前記感度は 0.2 以下になることがわかった。

【0266】

上記した図 46 ないし図 49 の実験では、フリー磁性層はその下の全面に形成された第 2 の反強磁性層との間で発生する交換結合磁界によって磁化が固定された状態にあるから、実験での再生感度は前記固定磁性層の素子中央部の磁化が変動することに起因するところが大きく、よってできる限り再生感度が小さくなる単位面積当たりの合成磁気モーメントや膜厚差を選択することが、前記固定磁性層の磁化固定を適切に行うことができて好ましいことになる。

【0267】

そこで図 46 ないし図 49 に示す実験結果を用いて、本発明において好ましい単位面積当たりの磁気モーメントの大きさ、および膜厚差を求めることとした。

【0268】

まず素子中央部での固定磁性層の感度の好ましい大きさについて説明する。図 48 を見てわかるように、2.6 (T・nm) の単位面積当たりの磁気モーメントを境として急激に感度変化が見られ、前記単位面積当たりの合成磁気モーメントを 2.6 (T・nm) 以下にすると感度を 0.2 以下に抑えることができるとわかった。

【0 2 6 9】

そして図 4 8 に示すグラフから、前記単位面積当たりの合成磁気モーメントを -6 ($\text{T} \cdot \text{nm}$) 以上で 2.6 ($\text{T} \cdot \text{nm}$) 以下の範囲内に設定すると前記感度を絶対値で 0.2 以下に抑えることができることがわかった。

【0 2 7 0】

またスピントロップ磁界は前記合成磁気モーメントをプラス側の領域にした方が大きくなることがわかっており、スピントロップ磁界が大きい方が、前記固定磁性層の磁化固定を適正化でき且つ製造工程を容易化できて好ましい。特に第 1 の反強磁性層がフリー磁性層よりも上側にあり、且つ前記フリー磁性層の磁化制御層として第 2 の反強磁性層を用いた場合、まず前記フリー磁性層と第 2 の反強磁性層間に交換結合磁界を生じさせる磁場中アニールを施すため、第 1 の反強磁性層と固定磁性層を構成する第 1 の磁性層間に交換結合磁界を生じさせるために施す磁場中アニール時の印加磁場の大きさは、前記フリー磁性層と第 2 の反強磁性層間に生じる交換結合磁界よりも小さくしなければならないという制約がある。このため、第 1 の反強磁性層がフリー磁性層よりも上側にあり、且つ前記フリー磁性層の磁化制御層として第 2 の反強磁性層を用いた場合には、前記合成磁気モーメントをプラス側の値にした方が、スピントロップ磁界を大きくできるため前記印加磁場のマージンを広くでき製造工程での容易性を向上させることができるので好ましい。

【0 2 7 1】

また前記合成磁気モーメントが 0 ($\text{T} \cdot \text{nm}$) であると、第 1 の磁性層と第 2 の磁性層の単位面積当たりの磁気モーメントが等しくなるため、磁場中アニール時に支配的な層（すなわち磁場をかけたときのその磁場方向に向く層）が第 1 の磁性層及び第 2 の磁性層のどちらでもなくなり、前記第 1 の磁性層と第 2 の磁性層を反平行状態にしつつハイト方向に平行な方向に磁化固定しにくい。従って前記合成磁気モーメントは 0 ($\text{T} \cdot \text{nm}$) でないことが必要である。

【0 2 7 2】

以上の結果、本発明での好ましい合成磁気モーメントは -6 ($\text{T} \cdot \text{nm}$) 以上で 2.6 ($\text{T} \cdot \text{nm}$) 以下（ただし $0 \text{ T} \cdot \text{nm}$ は除く）であり、第 1 の反強磁性

層がフリー磁性層よりも上側にあり、且つ前記フリー磁性層の磁化制御層として第2の反強磁性層を用いた場合には、好ましい前記合成磁気モーメントは0 ($T \cdot nm$) よりも大きく2.6 ($T \cdot nm$) 以下の範囲内とした。

【0273】

また図3ないし図8のように第2の反強磁性層を用いず、磁場中アニールが一回で済む構造、あるいは図10ないし図12のように固定磁性層が下側に位置し、第1の磁場中アニールで固定磁性層の磁化を固定する場合は、アニールを強磁場（第1及び第2磁性層の磁化が同じ方向に平行となるような磁場）で行えるため、合成磁気モーメントが0 ($T \cdot nm$) であってもよい。

【0274】

ただし図46に示す実験では、第1の磁性層及び第2の磁性層がともにCoFe合金で形成された磁気検出素子を用いて行ったものであり、かかる場合、前記合成磁気モーメントを1.5 ($T \cdot nm$) 以下Å以下にすると前記感度を0.2以下に抑えることができる。よって第1の磁性層及び第2の磁性層をともにCoFe合金で形成する場合、より好ましい前記合成磁気モーメントを0 ($T \cdot nm$) より大きく1.5 ($T \cdot nm$) 以下とした。

【0275】

次に膜厚差の好ましい範囲について説明する。感度を絶対値で0.2以下に抑えるには図49に示すように前記膜厚差を-30Å以上で30Å以下にすればよいとわかった。しかしながら前記膜厚差がマイナス側の値であると、前記第1の反強磁性層がフリー磁性層よりも上側にあり、且つ前記フリー磁性層の磁化制御層として第2の反強磁性層を用いた場合に、上記と同様の不具合が生じ易いので、かかる場合、前記膜厚差はプラス側の値であることが好ましい。

【0276】

なお図49に示す実験では第2の磁性層にCoFe/NiFe/CoFeの3層構造を用い、第1の磁性層にはCoFeの単層構造を用いているので、第1の磁性層と第2の磁性層の飽和磁化 M_s は異なる値であり、よって前記第1の磁性層と第2の磁性層が共に同じ膜厚値であっても、すなわち膜厚差が0Åであっても、単位面積当たりの合成磁気モーメントは0 ($T \cdot nm$) にならない。

【0277】

よって本発明における好ましい膜厚差は -30 \AA 以上で 30 \AA 以下であり、前記第1の反強磁性層がフリー磁性層よりも上側にあり、且つ前記フリー磁性層の磁化制御層として第2の反強磁性層を用いた場合、好ましい膜厚差は 0 \AA 以上で 30 \AA 以下である。

【0278】

ただし図47に示す実験では、第1の磁性層及び第2の磁性層がともにCoFe合金で形成された磁気検出素子を用いて行ったものであり、かかる場合、前記膜厚差を 10 \AA 以下にすると前記感度を0.2以下に抑えることができる。またかかる場合、前記膜厚差が 0 \AA であると合成磁気モーメントは $0\text{ (T}\cdot\text{nm)}$ になってしまうため、より好ましい膜厚差を 0 \AA よりも大きく 10 \AA 以下と設定した。

【0279】**【発明の効果】**

以上詳細に説明した本発明では、固定磁性層を、第1の反強磁性層に接する側の第1の磁性層と、前記第1の磁性層と膜厚方向で対向する第2の磁性層と、前記第1の磁性層と第2の磁性層間に介在する非磁性中間層とを有して構成し、前記第1の反強磁性層にはトラック幅方向に所定の間隔を空け、少なくとも前記第1の磁性層のトラック幅方向の両側端部に膜厚方向から接して設け、前記第1の反強磁性層との間で生じる交換結合磁界を、前記第1の磁性層の両側端部との間でのみ生じさせることで、固定磁性層の磁化固定を可能にできるとともに、再生出力を向上でき、狭ギャップ化を実現でき、さらに静電破壊(ESD)に強い磁気検出素子を製造することができる。よって今後の更なる高記録密度化に適切に対応可能な磁気検出素子を提供することができる。

【図面の簡単な説明】**【図1】**

本発明の第1の実施の形態である磁気検出素子の構造を記録媒体との対向面側から見た部分断面図、

【図2】

本発明の第 2 の実施の形態である磁気検出素子の構造を記録媒体との対向面側から見た部分断面図、

【図 3】

本発明の第 3 の実施の形態である磁気検出素子の構造を記録媒体との対向面側から見た部分断面図、

【図 4】

本発明の第 4 の実施の形態である磁気検出素子の構造を記録媒体との対向面側から見た部分断面図、

【図 5】

本発明の第 5 の実施の形態である磁気検出素子の構造を記録媒体との対向面側から見た部分断面図、

【図 6】

本発明の第 6 の実施の形態である磁気検出素子の構造を記録媒体との対向面側から見た部分断面図、

【図 7】

本発明の第 7 の実施の形態である磁気検出素子の構造を記録媒体との対向面側から見た部分断面図、

【図 8】

本発明の第 8 の実施の形態である磁気検出素子の構造を記録媒体との対向面側から見た部分断面図、

【図 9】

本発明の第 9 の実施の形態である磁気検出素子の構造を記録媒体との対向面側から見た部分断面図、

【図 1 0】

本発明の第 1 0 の実施の形態である磁気検出素子の構造を記録媒体との対向面側から見た部分断面図、

【図 1 1】

本発明の第 1 1 の実施の形態である磁気検出素子の構造を記録媒体との対向面側から見た部分断面図、

【図 1 2】

本発明の第 1 2 の実施の形態である磁気検出素子の構造を記録媒体との対向面側から見た部分断面図、

【図 1 3】

固定磁性磁性層の単位面積当たりの合成磁気モーメントの向きとセンス電流磁界の向きとを一致させるための説明図であり、本発明の実施の形態である磁気検出素子の構造を Y-Z 平面と平行な面で切断して見た部分断面図、

【図 1 4】

固定磁性磁性層の単位面積当たりの合成磁気モーメントの向きとセンス電流磁界の向きとを一致させるための説明図であり、本発明の実施の形態である磁気検出素子の構造を Y-Z 平面と平行な面で切断して見た部分断面図、

【図 1 5】

本発明の第 1 3 の実施の形態である磁気検出素子の構造を記録媒体との対向面側から見た部分断面図、

【図 1 6】

本発明の第 1 4 の実施の形態である磁気検出素子の構造を記録媒体との対向面側から見た部分断面図、

【図 1 7】

本発明の第 1 5 の実施の形態である磁気検出素子の構造を記録媒体との対向面側から見た部分断面図、

【図 1 8】

図 1 の形態の磁気検出素子の製造工程を示す一工程図、

【図 1 9】

図 1 8 の次に行なわれる一工程図、

【図 2 0】

図 1 9 の次に行なわれる一工程図、

【図 2 1】

図 2 0 の次に行なわれる一工程図、

【図 2 2】

図 2 1 の次に行なわれる一工程図、

【図 2 3】

図 4 の形態の磁気検出素子の製造工程を示す一工程図、

【図 2 4】

図 2 3 の次に行なわれる一工程図、

【図 2 5】

図 2 4 の次に行なわれる一工程図、

【図 2 6】

図 1 0 の形態の磁気検出素子の製造工程を示す一工程図、

【図 2 7】

図 2 6 の次に行なわれる一工程図、

【図 2 8】

図 2 7 の次に行なわれる一工程図、

【図 2 9】

図 2 8 の次に行なわれる一工程図、

【図 3 0】

図 1 1 の形態の磁気検出素子の製造工程を示す一工程図、

【図 3 1】

図 3 0 の次に行なわれる一工程図、

【図 3 2】

図 3 1 の次に行なわれる一工程図、

【図 3 3】

図 3 2 の次に行なわれる一工程図、

【図 3 4】

図 2 6 及び図 2 7 とは別の製造方法を示すための一工程図、

【図 3 5】

図 3 4 の次に行なわれる一工程図、

【図 3 6】

図 2 6 及び図 2 7 とは別の製造方法を示すための一工程図、

【図 3 7】

図 3 6 の次に行なわれる一工程図、

【図 3 8】

図 1 2 の形態の磁気検出素子の製造工程を示す一工程図

【図 3 9】

図 3 8 の次に行なわれる一工程図、

【図 4 0】

実験に使用した磁気検出素子（実施例）の構造を示す模式図、

【図 4 1】

図 4 0 の磁気検出素子を使用して求めた、トラック幅 $R T w$ と一方向性交換バイアス磁界 $H_{ex} *$ との関係を示すグラフ、

【図 4 2】

図 4 0 の磁気検出素子を使用して求めた、トラック幅 $R T w$ と規格化出力との関係を示すグラフ、

【図 4 3】

実験に使用した磁気検出素子（比較例）の構造を示す模式図、

【図 4 4】

図 4 3 の磁気検出素子を使用して求めた、トラック幅 $R T w$ と一方向性交換バイアス磁界 $H_{ex} *$ との関係を示すグラフ、

【図 4 5】

図 4 3 の磁気検出素子を使用して求めた、トラック幅 $R T w$ と規格化出力との関係を示すグラフ、

【図 4 6】

図 4 0 の磁気検出素子のフリー磁性層を第 2 の反強磁性層で磁化固定し、その状態での磁気検出素子を使用して求めた、固定磁性層の単位面積当たりの合成磁気モーメント ($N_{et} \quad M_{st}$) と、 $\Delta V (\pm 1000 \text{ Oe}) / \Delta V (\pm 4000 \text{ Oe})$ との関係を示すグラフ、

【図 4 7】

図 4 0 の磁気検出素子のフリー磁性層を第 2 の反強磁性層で磁化固定し、その状

態での磁気検出素子を使用して求めた、第2の磁性層の膜厚から第1の磁性層の膜厚を引いた膜厚差と、 ΔV ($\pm 1000 \text{ Oe}$) / ΔV ($\pm 4000 \text{ Oe}$) との関係を示すグラフ、

【図48】

図40とは異なる材質によって第2の磁性層を形成した磁気検出素子を使用して求めた、固定磁性層の単位面積当たりの合成磁気モーメント ($N_{\text{et}} M_{\text{st}}$) と、 ΔV ($\pm 1000 \text{ Oe}$) / ΔV ($\pm 4000 \text{ Oe}$) との関係を示すグラフ、

【図49】

図40とは異なる材質によって第2の磁性層を形成した磁気検出素子を使用して求めた、第2の磁性層の膜厚から第1の磁性層の膜厚を引いた膜厚差と、 ΔV ($\pm 1000 \text{ Oe}$) / ΔV ($\pm 4000 \text{ Oe}$) との関係を示すグラフ、

【図50】

従来における磁気検出素子の構造を記録媒体との対向面側から見た部分断面図、

【図51】

特開2000-163717号公報の図1に掲載された図を書き写した磁気検出素子の部分断面図、

【図52】

特開平8-7325号公報の図5の一部を書き写した磁気検出素子の部分断面図、

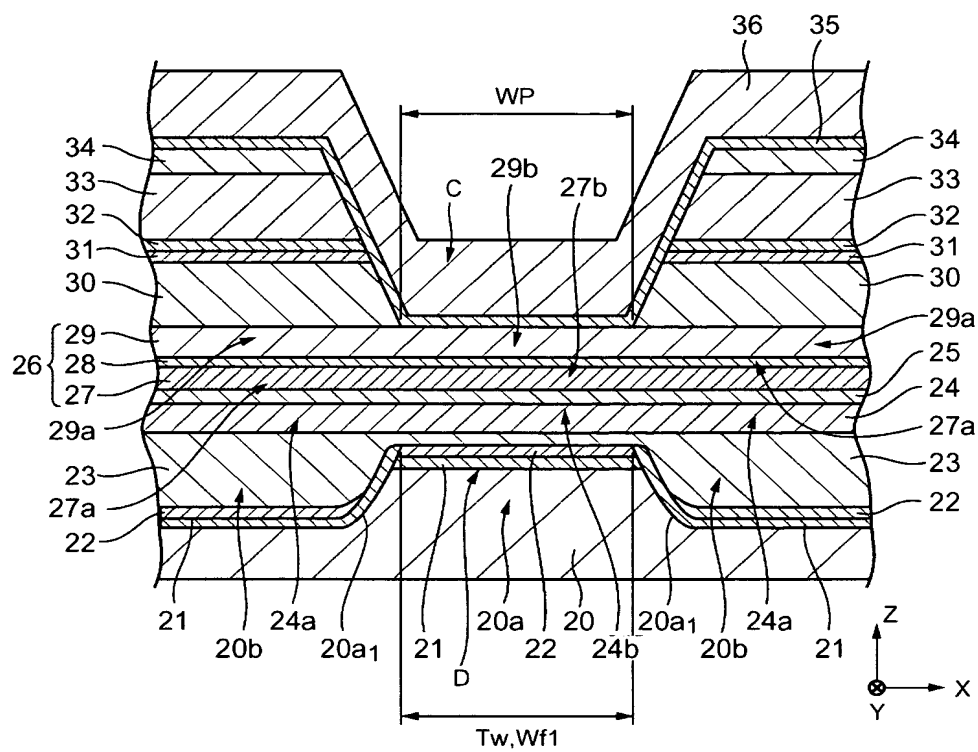
【符号の説明】

- 20 下部シールド層
- 21 下部ギャップ層
- 23 第2の反強磁性層
- 24 フリー磁性層
- 25 非磁性材料層
- 26、64 固定磁性層
- 27、63 第2の磁性層
- 28、44、62 非磁性中間層
- 29、61 第1の磁性層

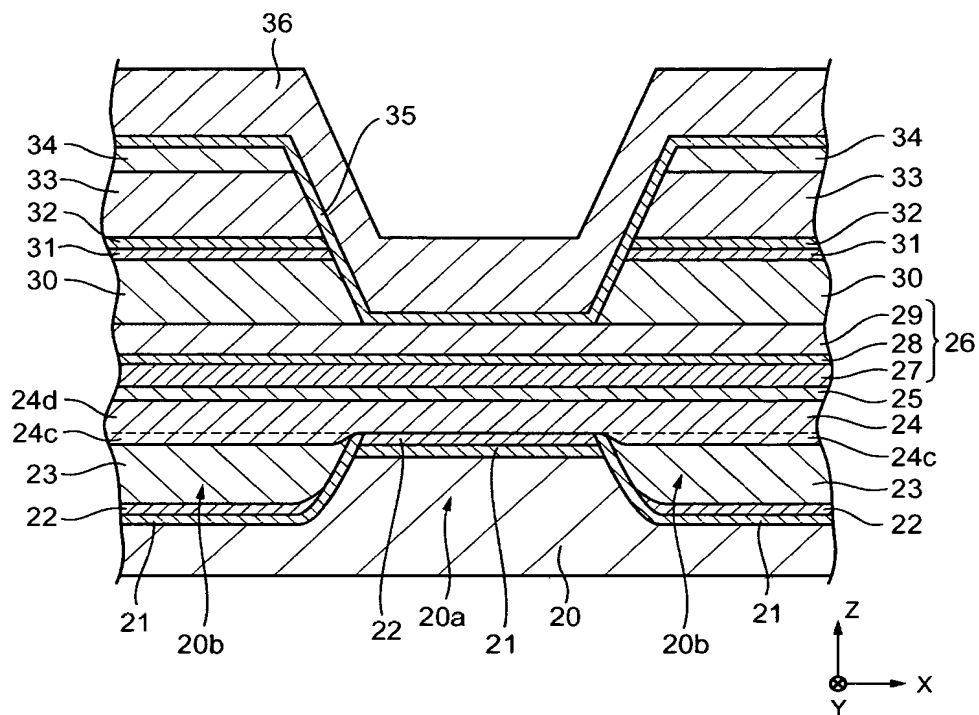
- 3 0 第 1 の反強磁性層
- 3 3 電極層
- 3 5 上部ギャップ層
- 3 6 上部シールド層
- 4 1 永久磁石層
- 4 3 磁性中間層
- 6 0 第 3 の反強磁性層
- 7 0 絶縁層
- 8 1、9 4、1 0 0 マスク層
- 8 3、8 7、8 8、8 9 レジスト層

【書類名】 図面

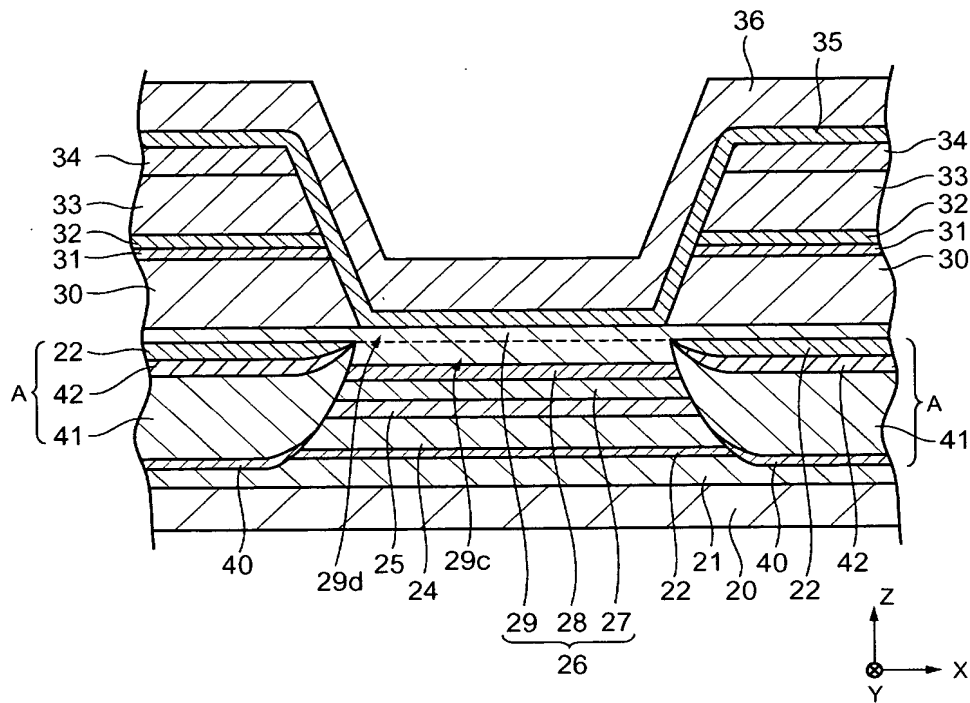
【図 1】



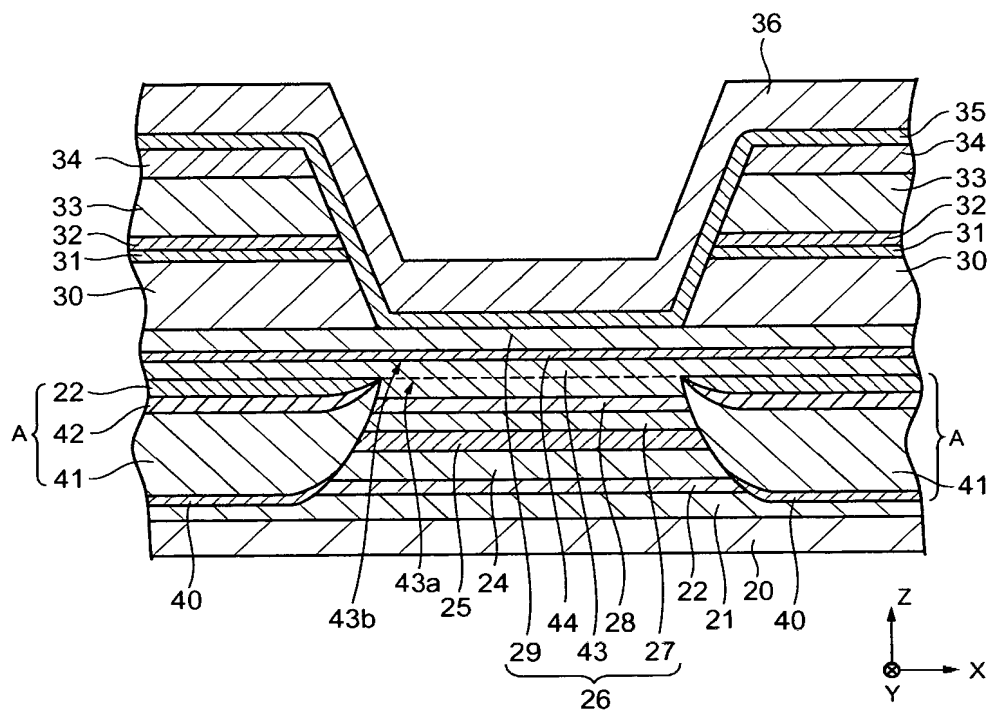
【図 2】



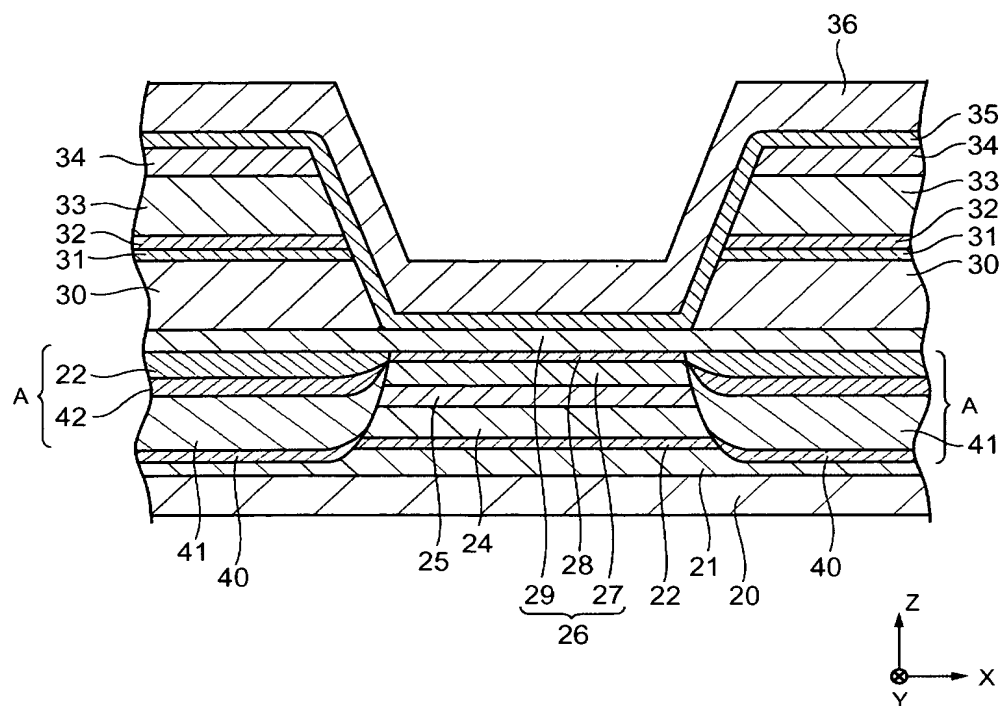
【図 5】



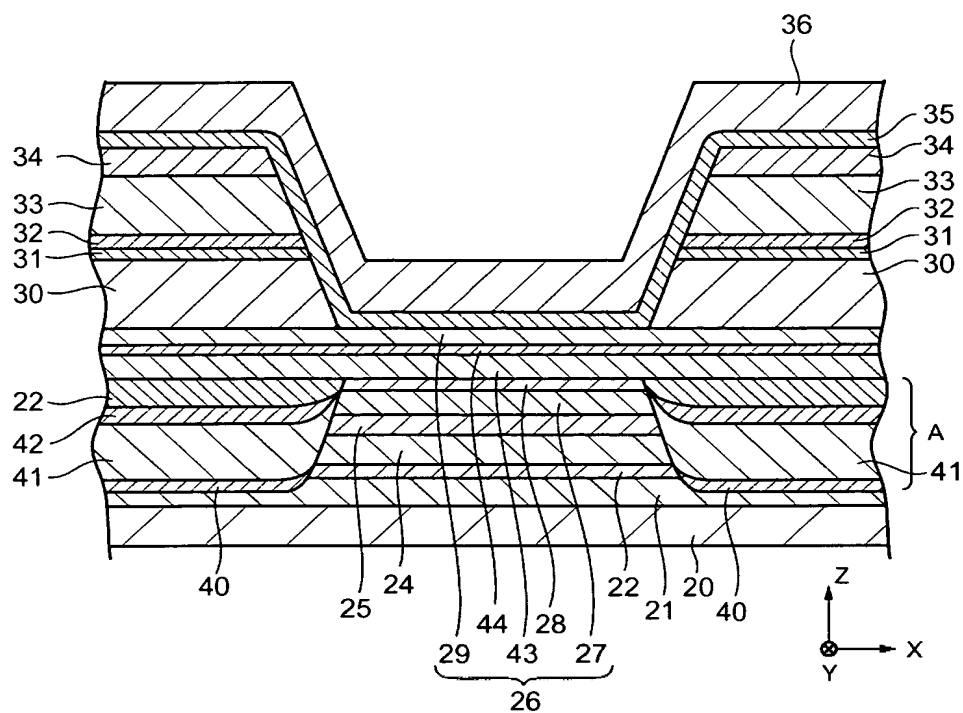
【図 6】



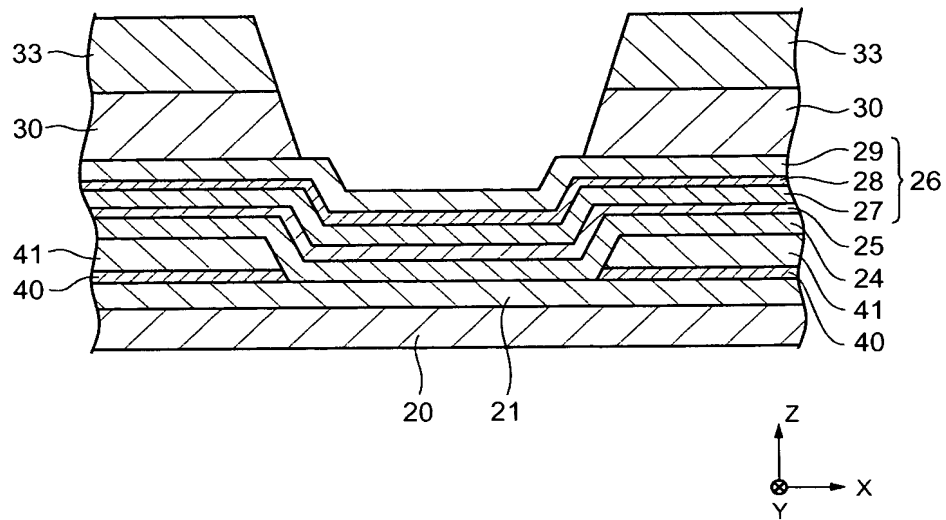
【図 7】



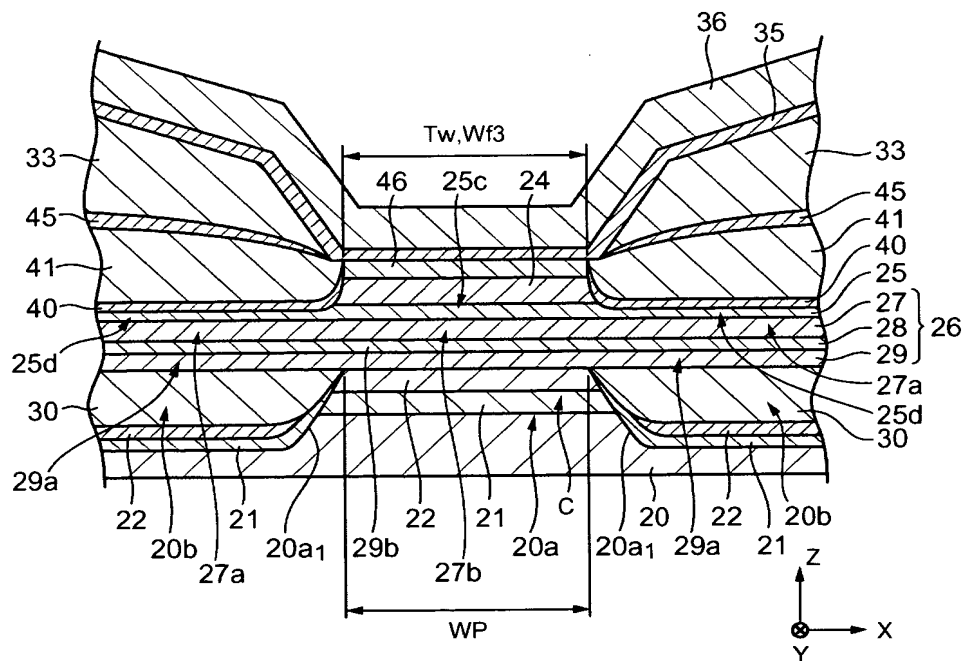
【図 8】



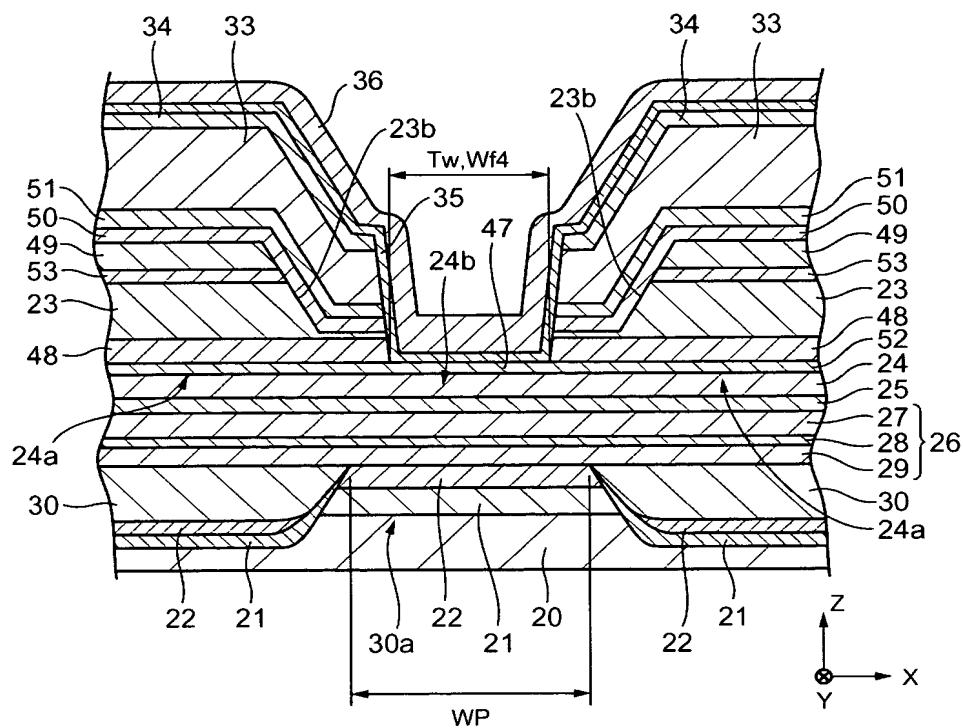
【図 9】



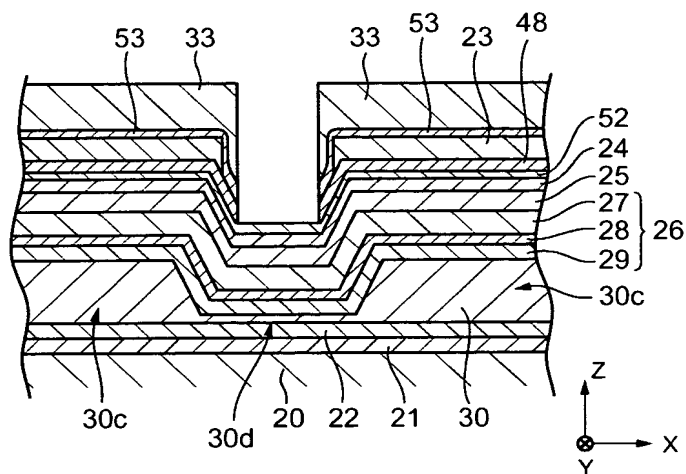
【図 10】



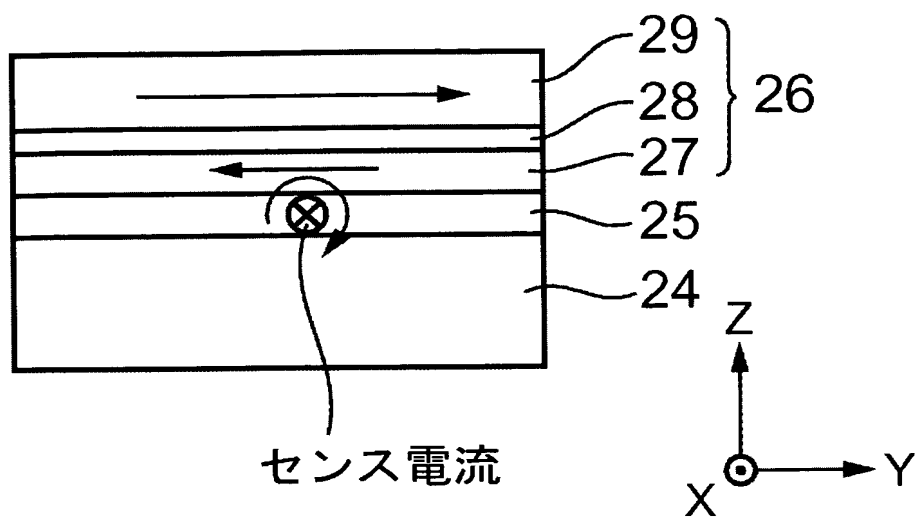
【図 1 1】



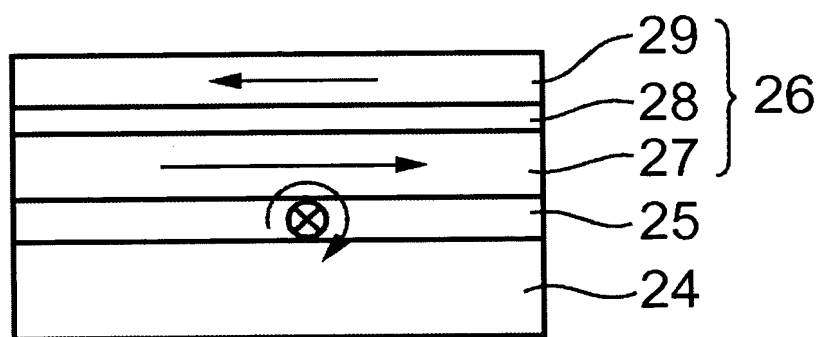
【図 1 2】



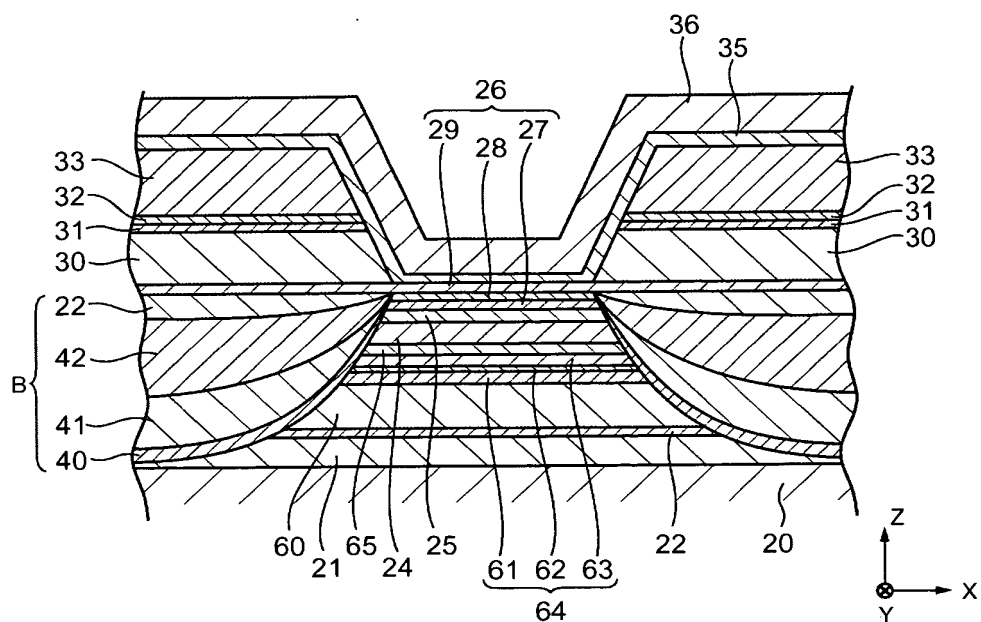
【図 13】



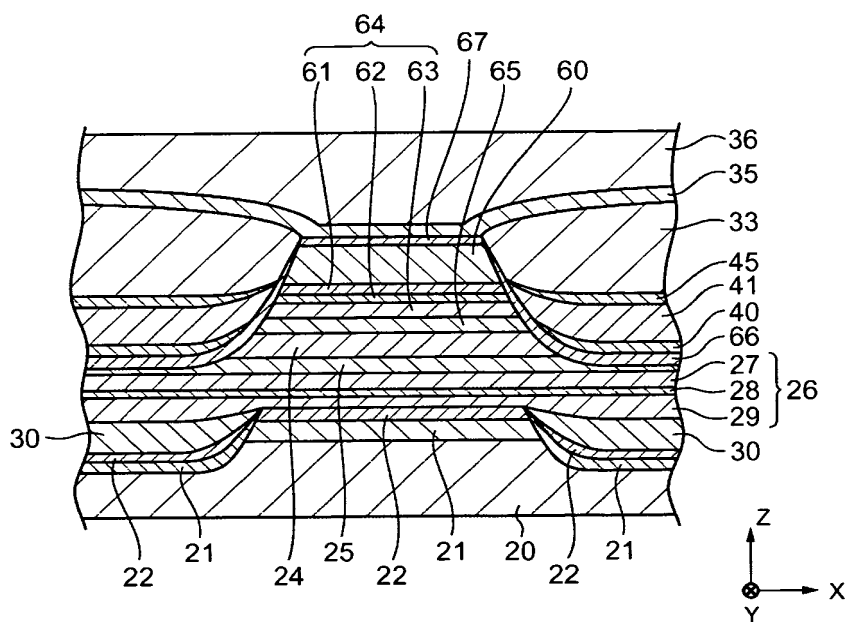
【図 14】



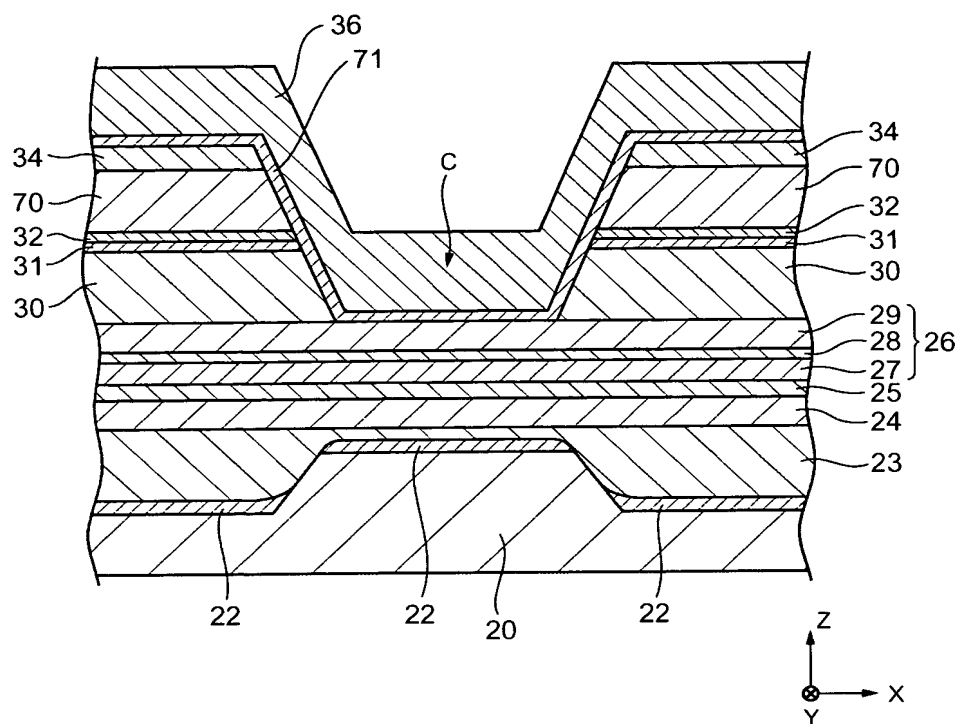
【図 15】



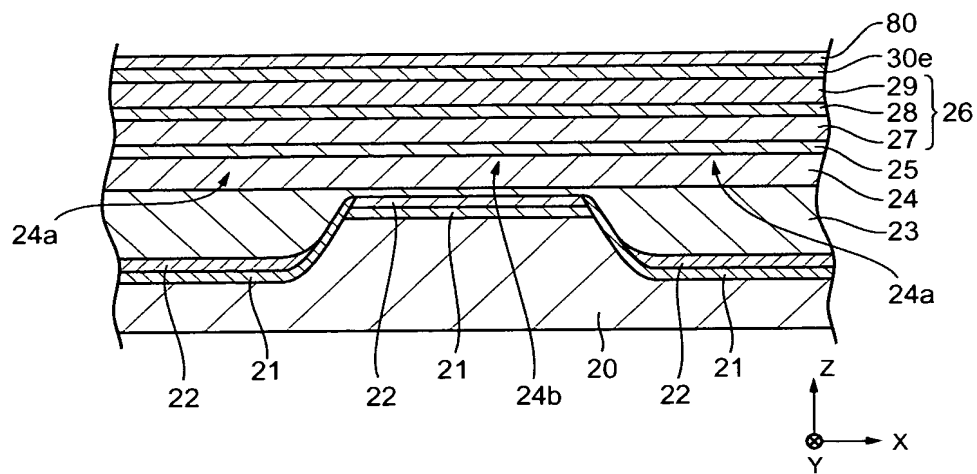
【図 16】



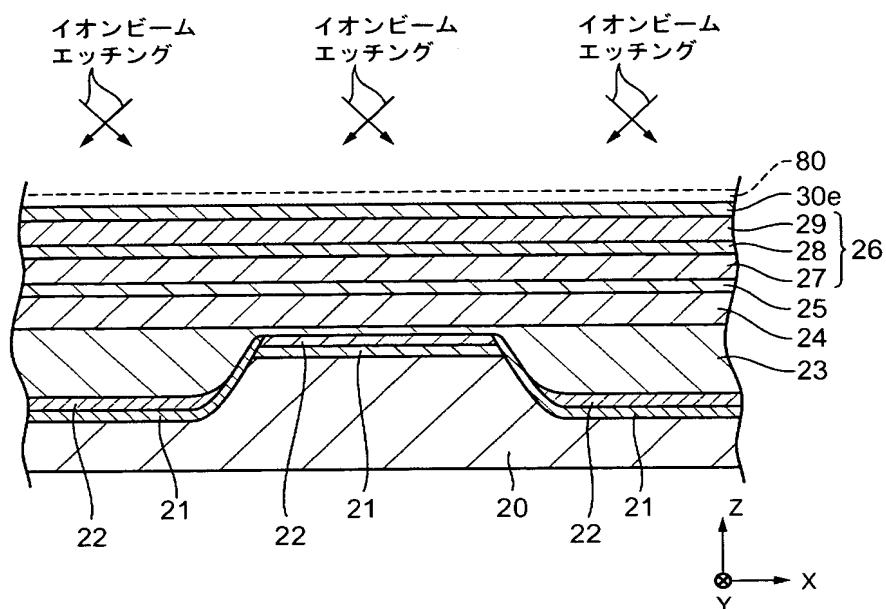
【図 17】



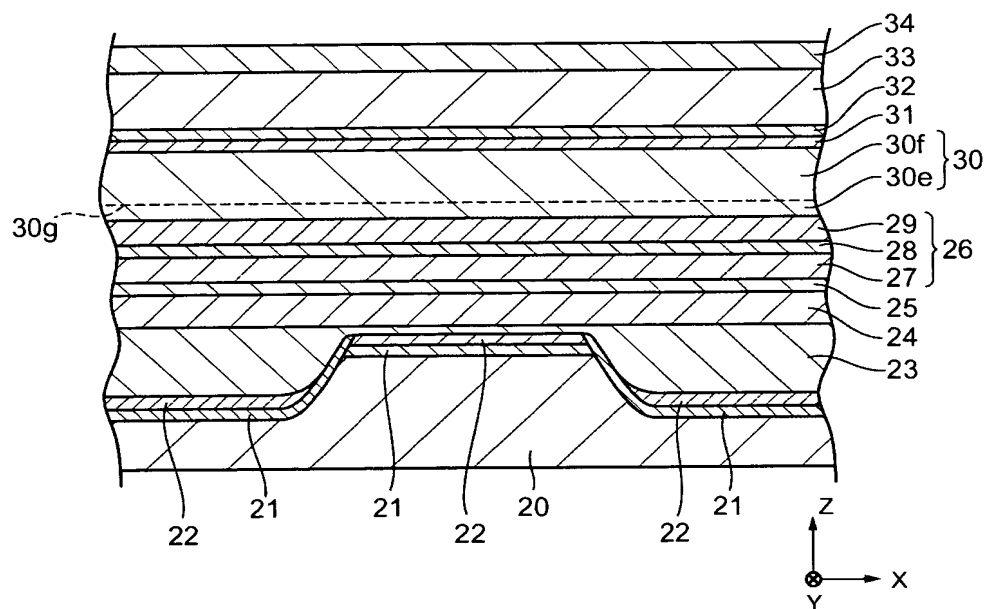
【図 18】



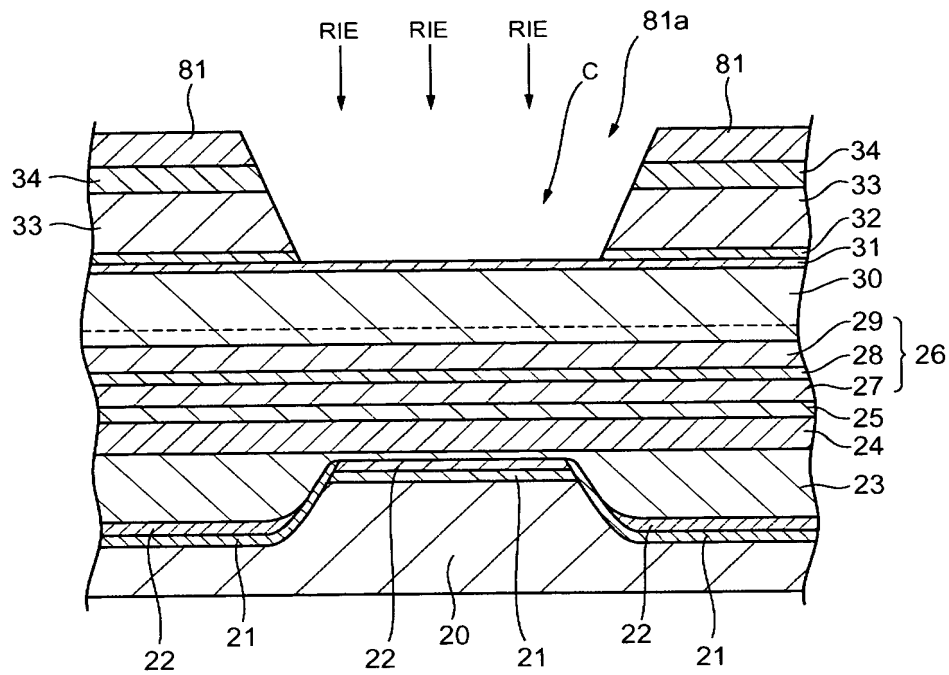
【図 19】



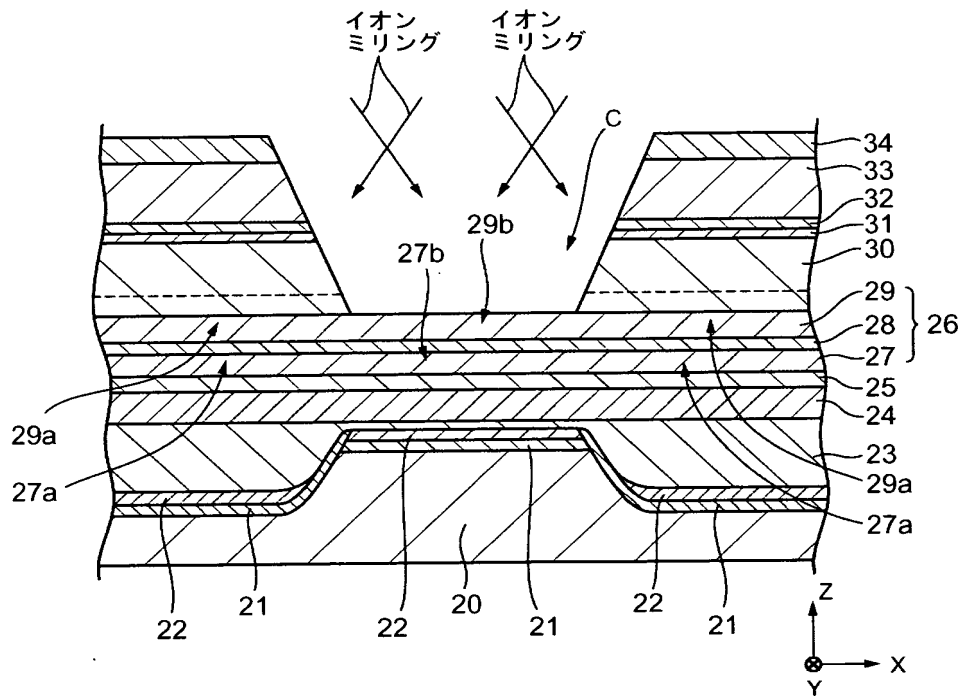
【図 20】



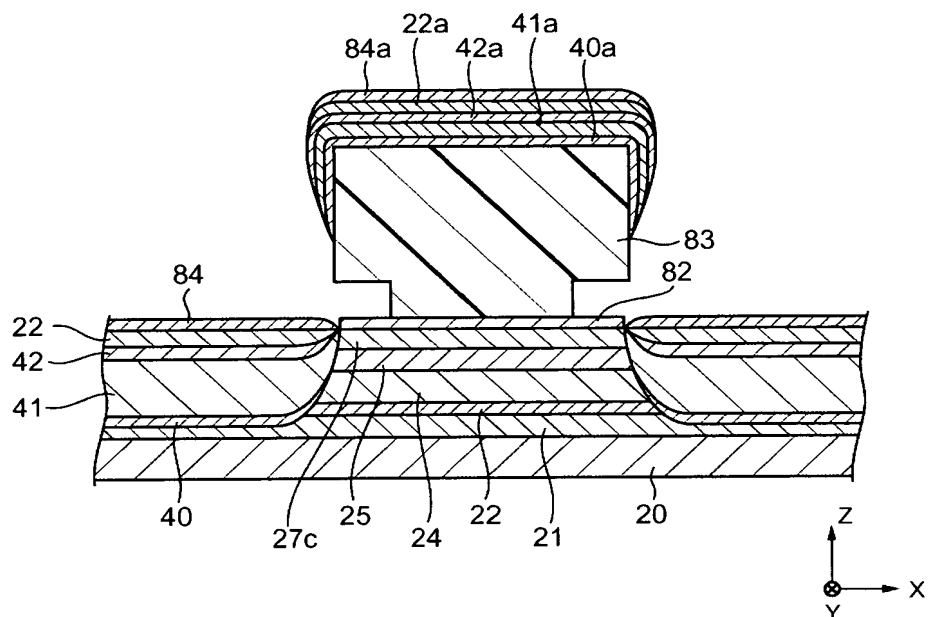
【図 21】



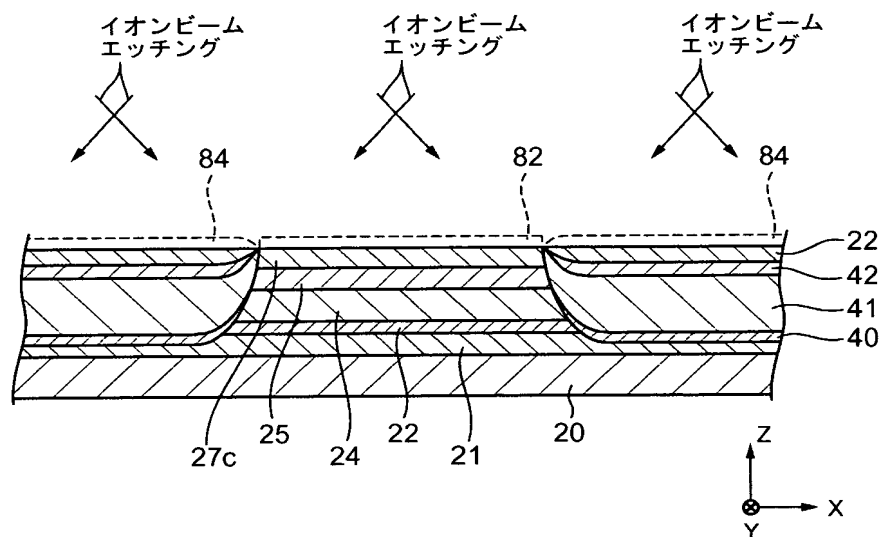
【図 22】



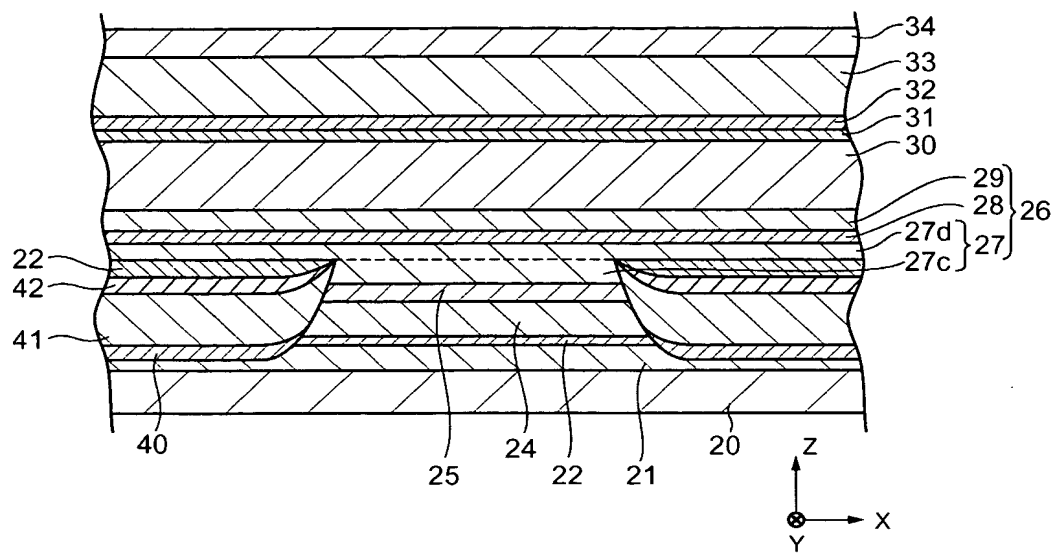
【図 2 3】



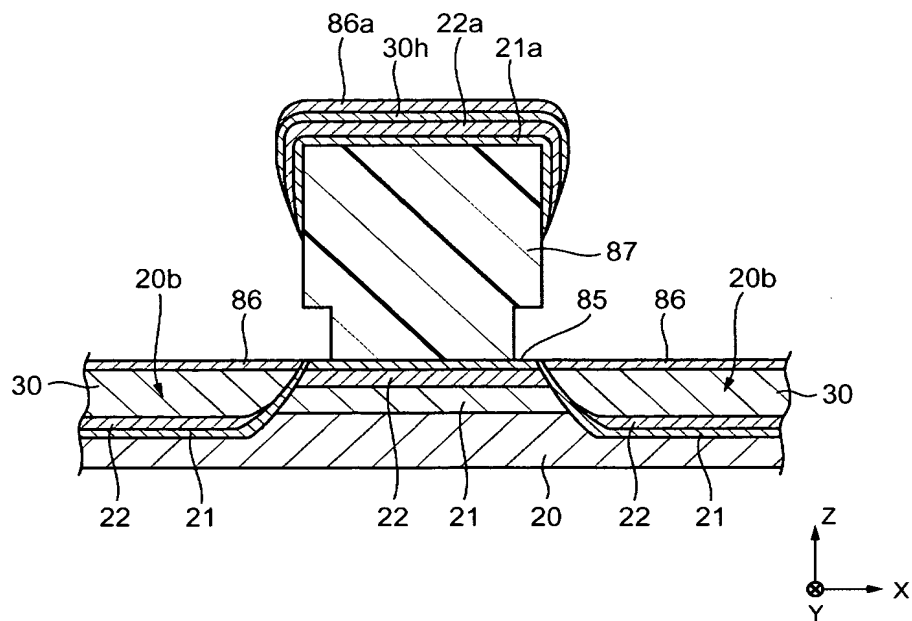
【図 2 4】



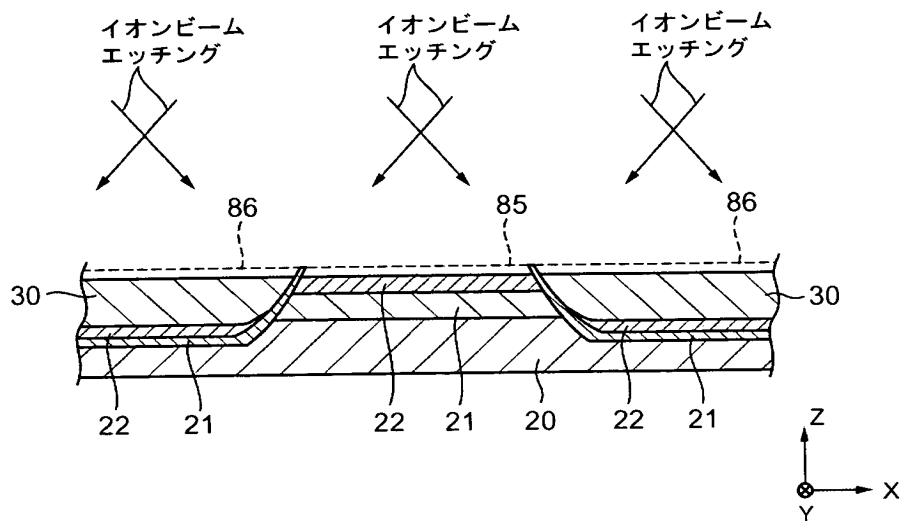
【図 25】



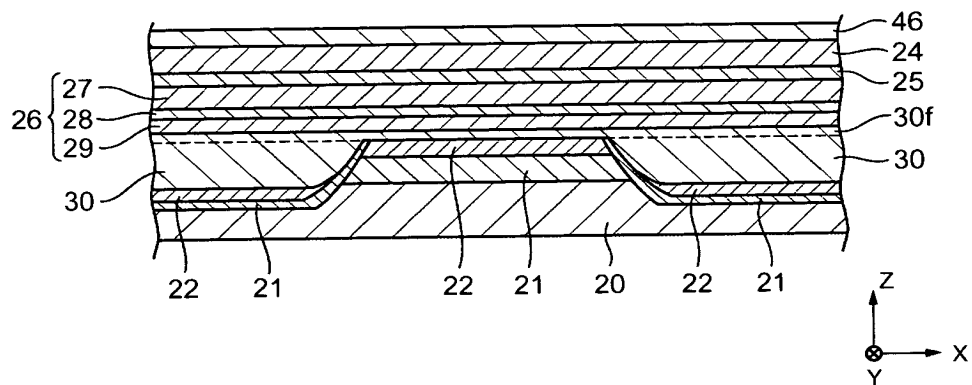
【図 26】



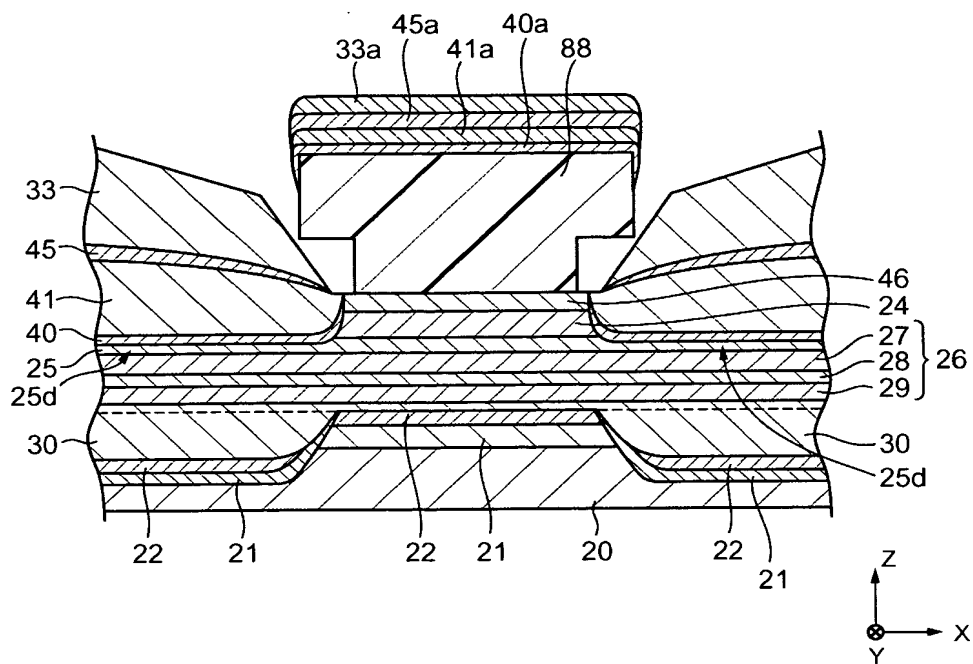
【図 27】



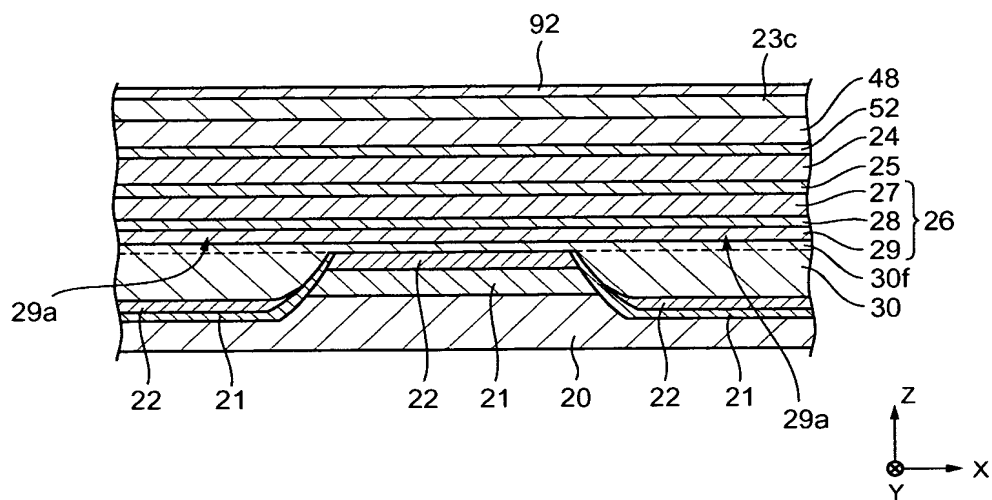
【図 28】



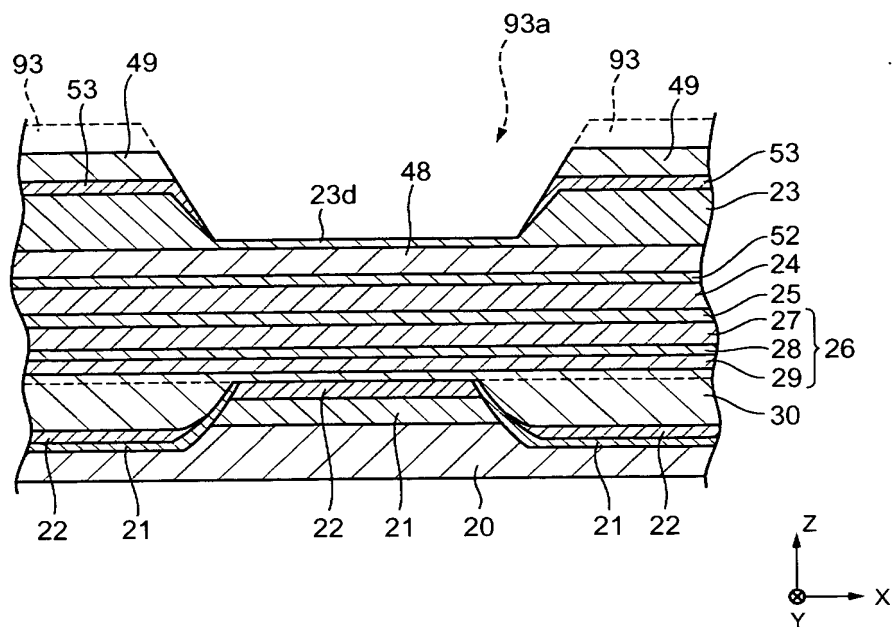
【図 29】



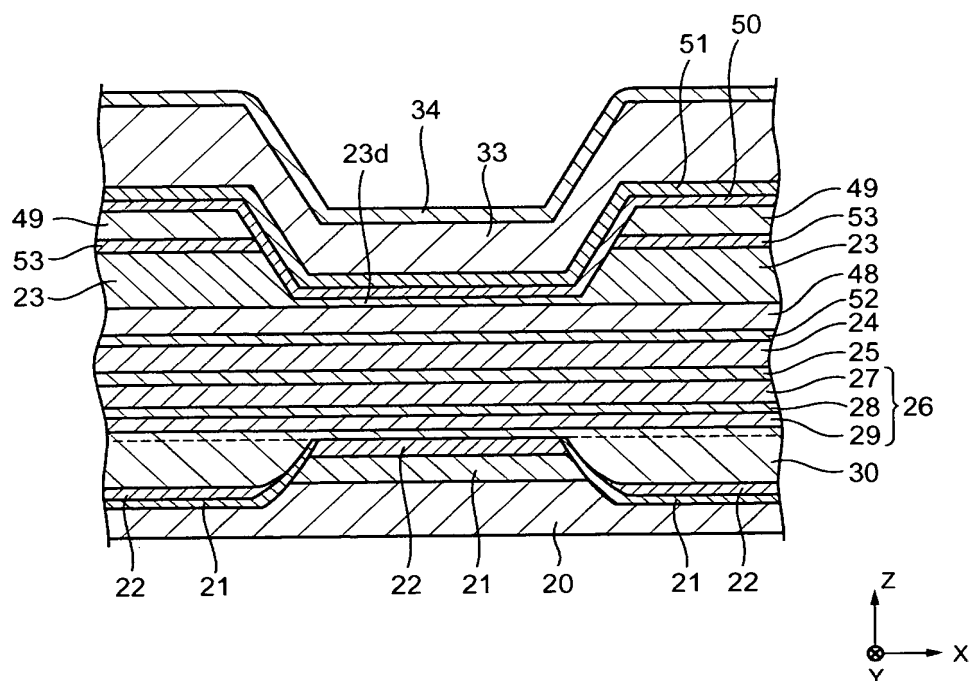
【図 30】



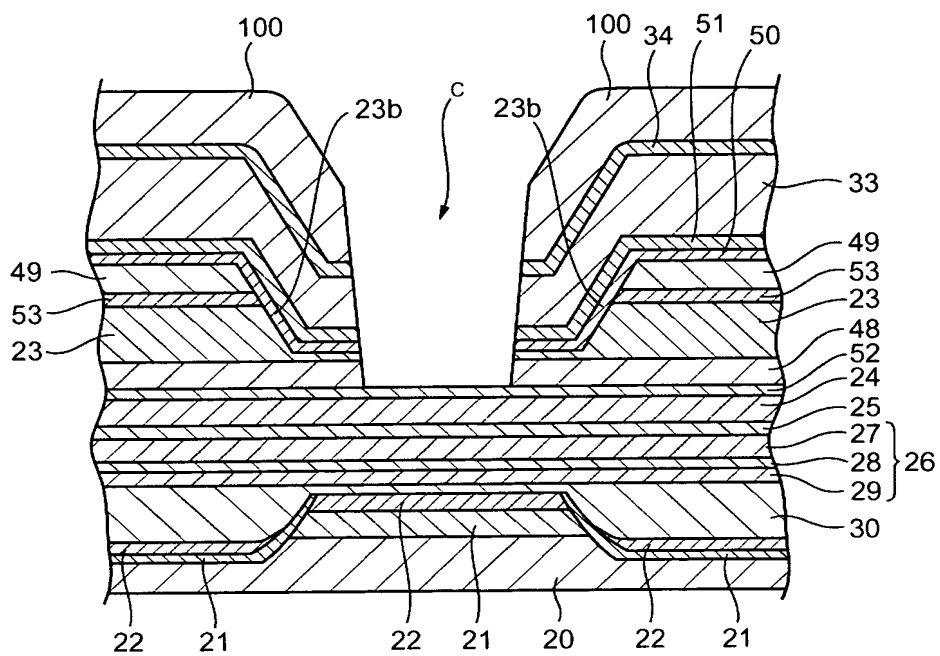
【図 3 1】



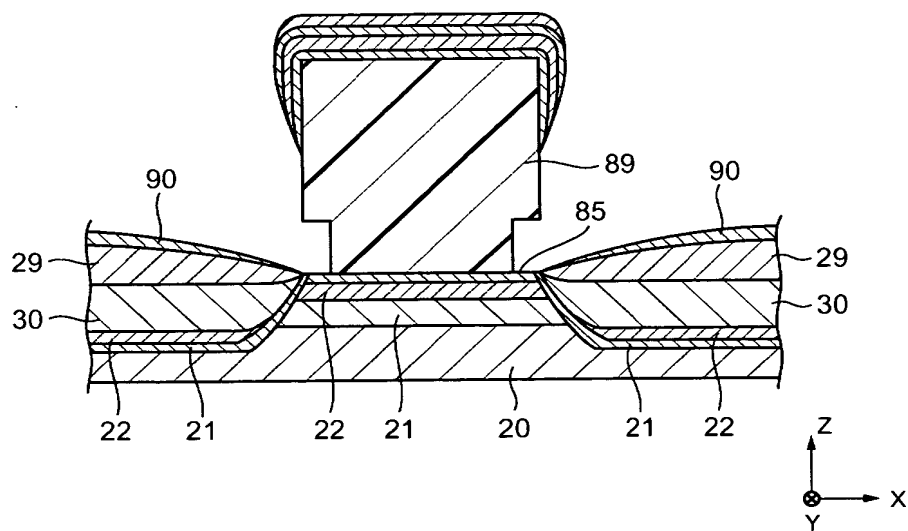
【図 3 2】



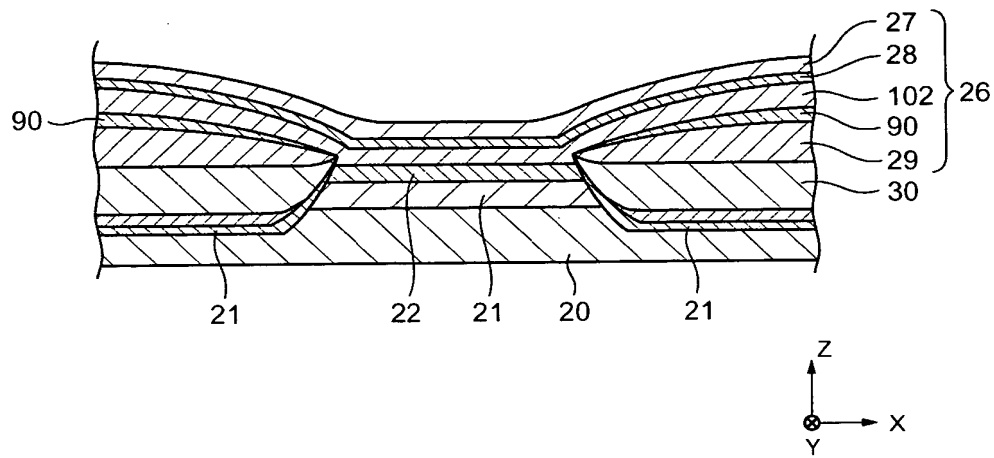
【図 3 3】



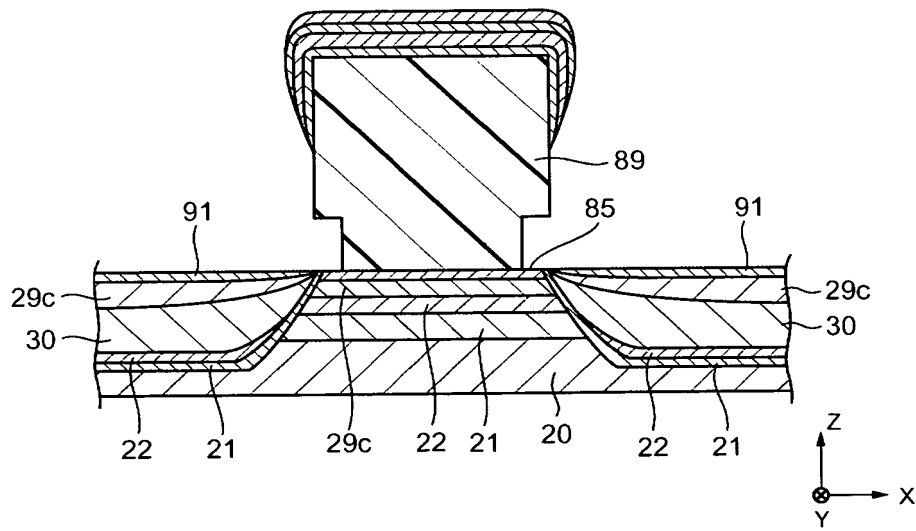
【図 3 4】



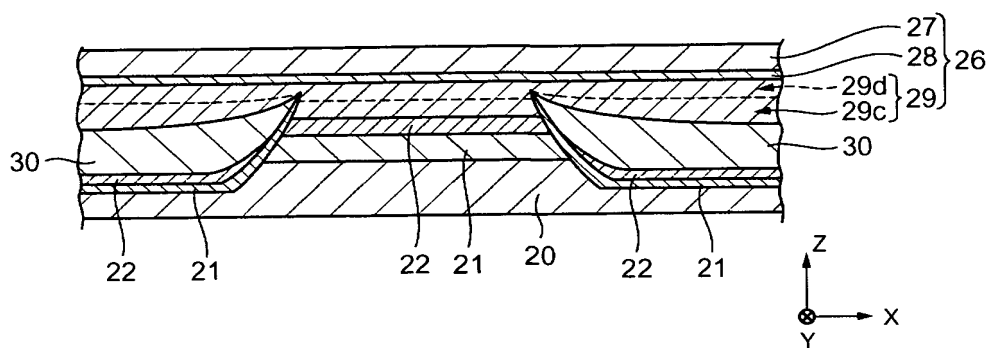
【図 3 5】



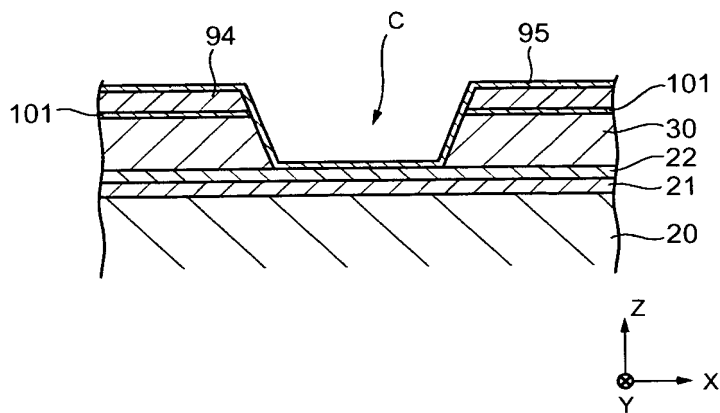
【図 3 6】



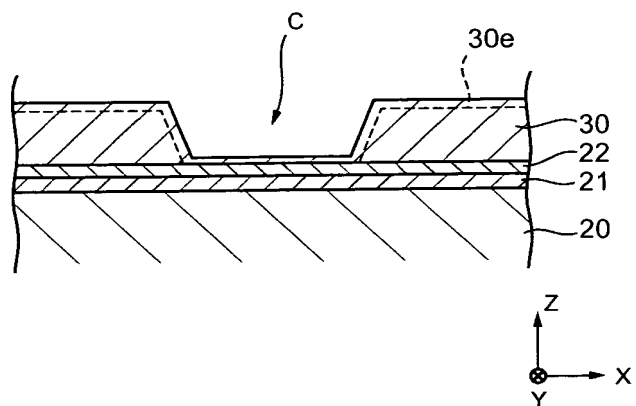
【図 3 7】



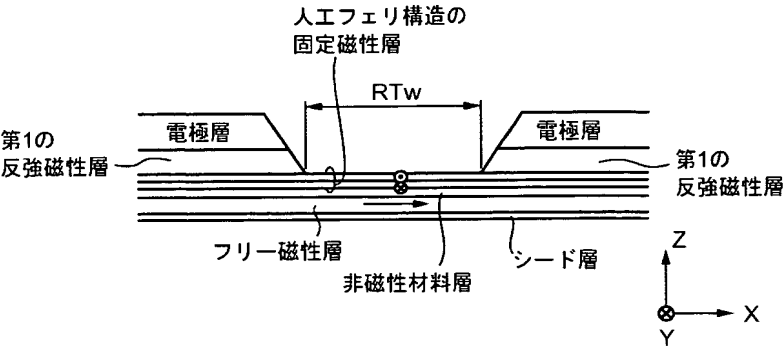
【図 3 8】



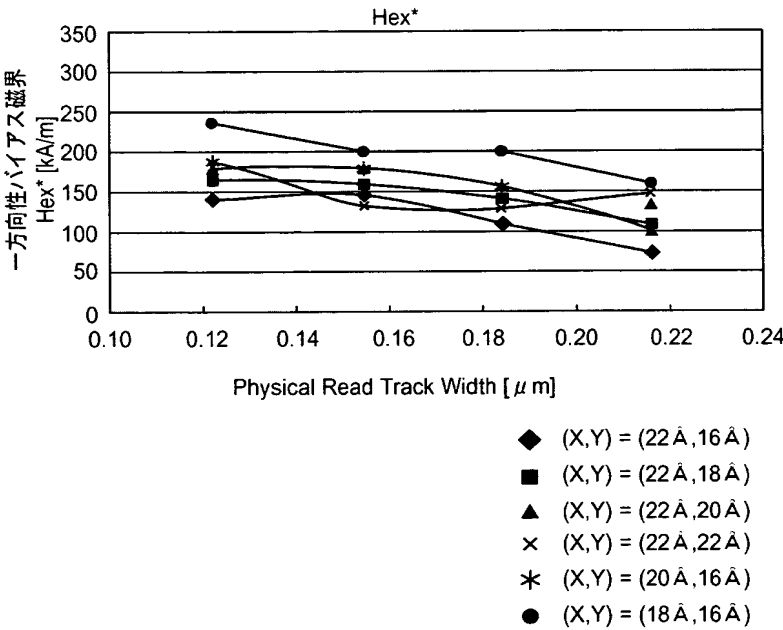
【図 3 9】



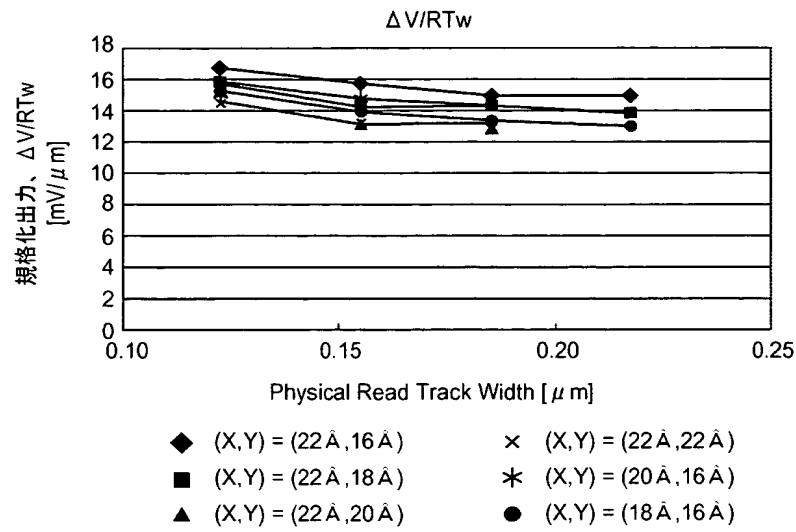
【図 4 0】



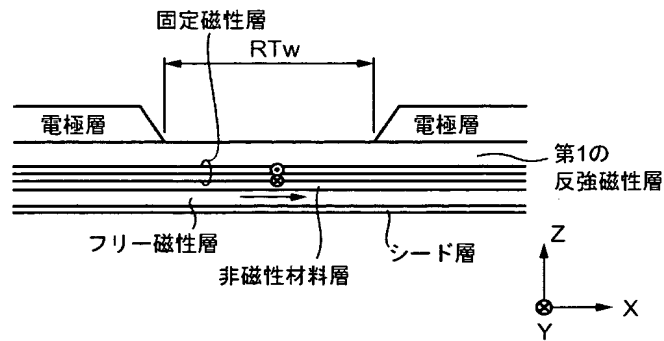
【図 4 1】



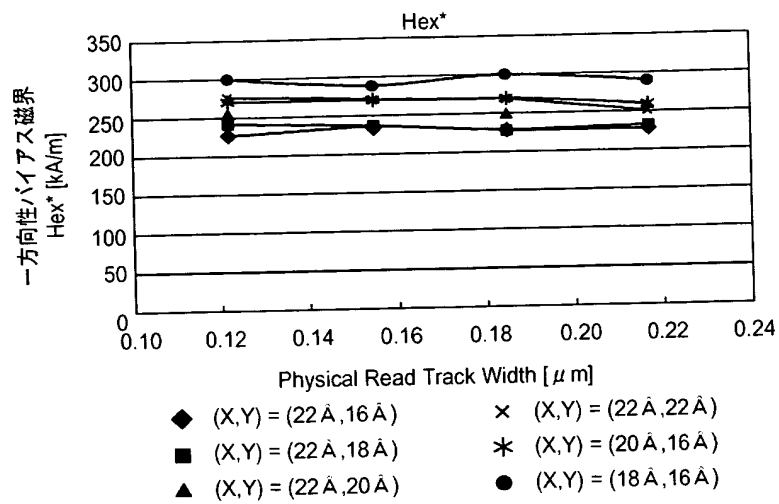
【図 4 2】



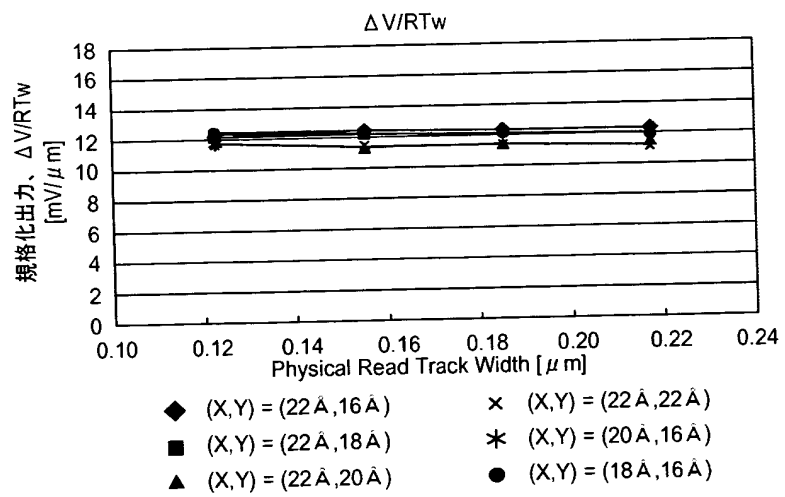
【図 4 3】



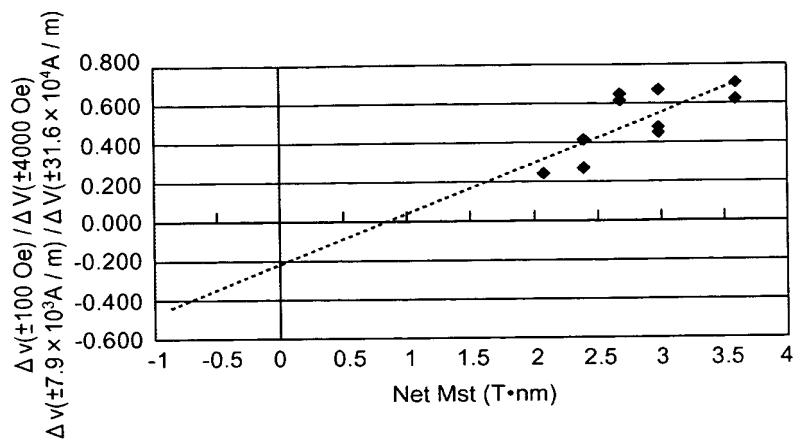
【図 4 4】



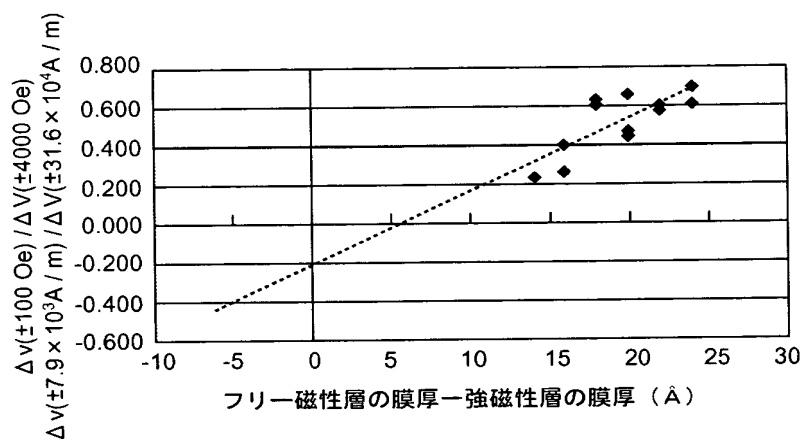
【図 4 5】



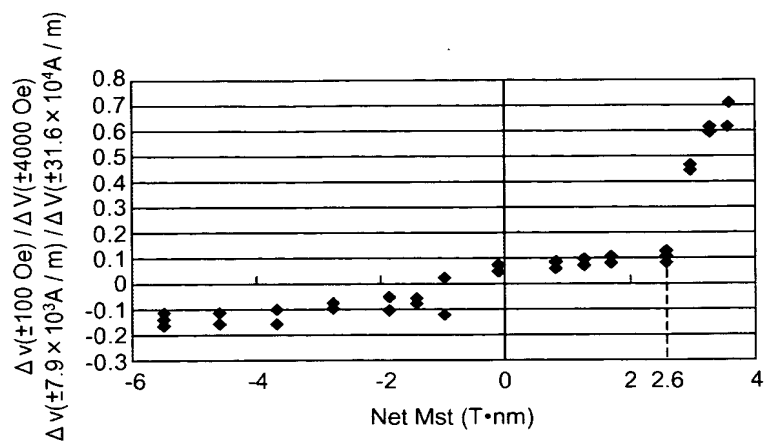
【図 4 6】



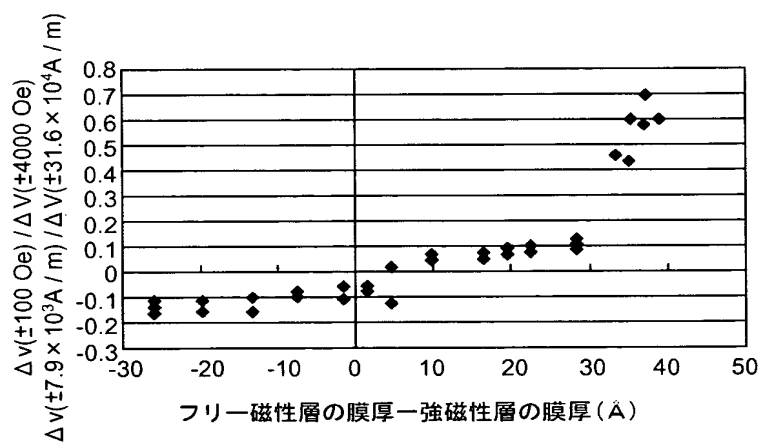
【図 4 7】



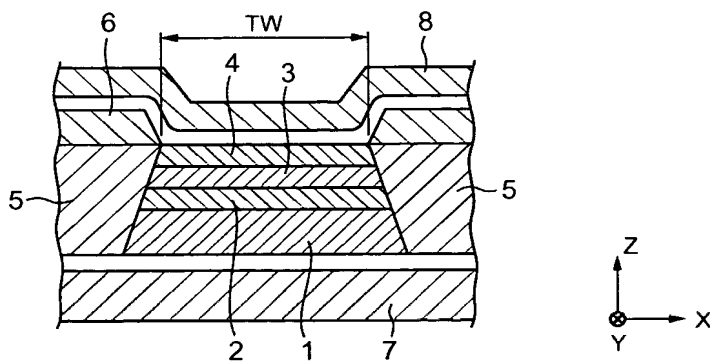
【図 48】



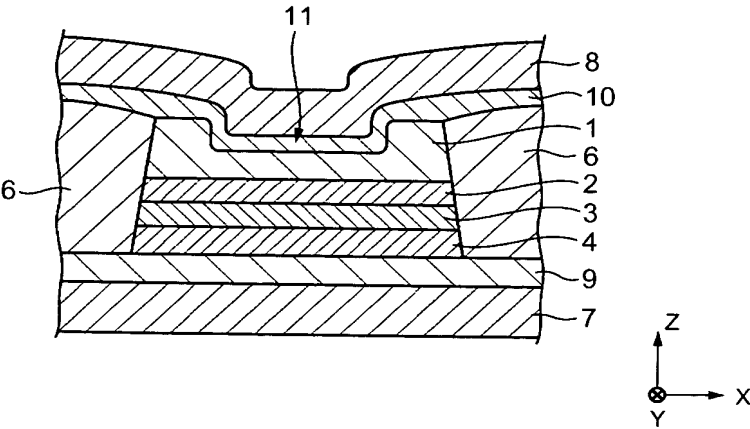
【図 49】



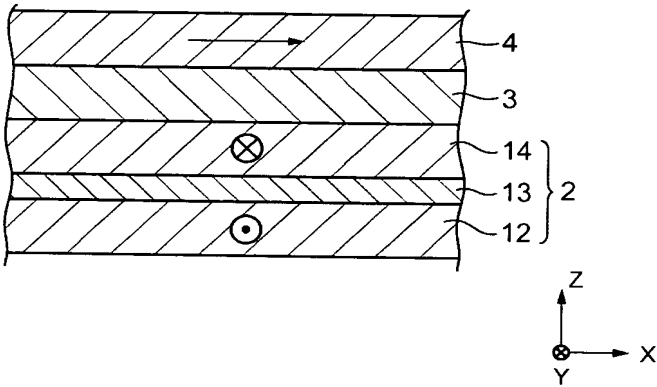
【図 50】



【図 5 1】



【図 5 2】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 特に固定磁性層と第1の反強磁性層との交換結合膜の構造を適正化することで、前記固定磁性層を適切に磁化固定できるとともに、再生出力の向上を図り、さらには狭ギャップ化等に適切に対応することが可能な磁気検出素子及びその製造方法を提供すること目的としている。

【解決手段】 固定磁性層26を、人工フェリ構造にし、前記第1の反強磁性層30間にトラック幅方向に所定の間隔Cを空け、交換結合磁界を、第1の磁性層29の両側端部29aと第1の反強磁性層30間でのみ生じさせることで、固定磁性層26の磁化固定を可能にできるとともに、再生出力を向上でき、狭ギャップ化を実現でき、さらに静電破壊(ESD)に強い磁気検出素子を製造することができる。よって今後の更なる高記録密度化に適切に対応可能な磁気検出素子を提供することができる。

【選択図】 図1

特願 2 0 0 2 - 2 9 3 3 5 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 1 0 0 9 8]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 7 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区雪谷大塚町 1 番 7 号

氏 名

アルプス電気株式会社